

HNOLOGY デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を搭載したデュアル出力 PolyPhase 降圧 DC/DC コントローラ

特長

- PMBus/l2C準拠シリアル・インタフェース
 - 遠隔測定での読み出し内容: V_{IN}、I_{IN}、V_{OUT}、I_{OUT}、温度、 デューティ・サイクル、およびフォルト
 - プログラム可能な電圧、電流制限、デジタル・ソフトスタート/ストップ、シーケンシング、マージニング、 0V/UV、および周波数同期(250kHz~1MHz)
- 全温度範囲での出力電圧精度:±0.5%
- 16ビットADCを内蔵
- V_{OUT}の電圧範囲:0.5V~5.5V(V_{OUTO}、V_{OUT1})
- 内部 EEPROM とフォルト・ログ機能
- 強力なNチャネル MOSFET ゲート・ドライバを内蔵
- 広い入力電圧範囲:4.5V~24V
- アナログ電流モード制御ループ
- PolyPhase®アプリケーション対応のリモート差動検出
- 6位相までのPolyPhase 高精度電流分担
- 40ピン(6mm×6mm)QFNパッケージで供給可能

アプリケーション

- 大電流の分散給電システム
- 通信システム、データ通信システム、および ストレージ・システム
- 高度でエネルギー効率の高い電力レギュレーション

概要

LTC®3887は、I²CベースのPMBus 準拠シリアル・インタフェース を備えたデュアル PolyPhase DC/DC 同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。このコントローラは、グラフィカル・ユーザー・インタフェース(GUI)を備えたLTpowerPlayTM ソフトウェア開発ツールによってサポートされている固定周波数の電流モード・アーキテクチャを採用しています。

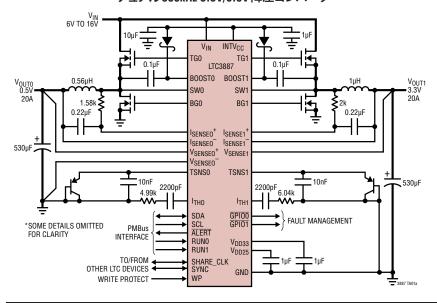
スイッチング周波数、チャネル位相設定、出力電圧、およびデバイス・アドレスは、外付けの構成抵抗を使用して設定できます。さらに、パラメータはデジタル・インタフェースを介して設定することや、EEPROMに格納することができます。電圧、電流、内部/外部温度、およびフォルト状態は、バス・インタフェースを介して読み出すことができます。

LTC3887は、不連続(パルス・スキップ)モード、または連続インダクタ電流モードに合わせて構成できます。LTC3887はゲート・ドライバを内蔵しています。LTC3887はLTC3880の機能向上バージョンであり、出力電圧範囲が広く、デジタル機能が豊富です。詳細については、15ページを参照してください。

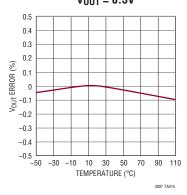
Δ7、LT、LTC、LTM、PolyPhase、μModule、Linear Technology およびLinear のロゴはリニア テクノロジー社の登録商標です。LTpowerPlayはリニアテクノロジー社の商標です。その他全て の商標の所有権は、それぞれの所有者に帰属します。5481178、5705919、5929620、6144194、 6177787、6580258、5408150、7420359を含む米国特許により保護されています。米国特許 7000125 および他の関連する国際特許の使用権を許諾されています。

標準的応用例

デュアル350kHz 3.3V/0.5V 降圧コンバータ



安定化出力電圧と温度、 V_{0UT} = 0.5V



3887f

LINEAR TECHNOLOGY

LTC3887

目次

特長	1
アプリケーション	1
標準的応用例	1
概要	1
目次	2
絶対最大定格	4
発注情報	4
ピン配置	4
電気的特性	5
標準的性能特性	9
ピン機能	12
ブロック図	14
動作	15
概要	15
メイン制御ループ	16
EEPROM(NVM)	
電源投入と初期化	17
ソフトスタート	17
シーケンシング	
イベントベース・シーケンシング	18
シャットダウン	19
軽負荷電流動作	
スイッチング周波数と位相	19
出力電圧検出	20
電流検出	
PolyPhase 負荷シェアリング	21
外部/内部温度検出	
RCONFIG(抵抗構成設定)ピン	
フォルトの検出と処理	
CRC保護	
シリアル・インタフェース	24
通信保護	
デバイス・アドレス指定	
V _{OUT} および I _{OUT} フォルトに対する応答	
出力過電圧フォルトに対する応答	
出力低電圧フォルトに対する応答	
ピーク出力過電流フォルトに対する応答	
タイミング・フォルトに対する応答	26
V _{IN} の OV フォルトに対する応答	26

OT/UTフォルトに対する応答	26
内部過熱フォルト/警告応答	26
外部過熱および低温フォルト応答	26
外部フォルトに対する応答	27
フォルト・ログ	
バス・タイムアウト保護	27
PMBus、SMBus、I ² C 2 線インタフェース間の類似性	27
PMBus シリアル・デジタル・インタフェース	28
PMBus コマンドの概要	33
PMBus コマンド	33
* データ形式	38
アプリケーション情報	39
電流制限のプログラミング	39
Isense⁺ピンとIsense⁻ピン	39
値の小さな抵抗による電流検出	40
インダクタ DCR による電流検出	41
スロープ補償とインダクタのピーク電流	42
インダクタ値の計算	42
インダクタのコアの選択	43
パワー MOSFET とショットキ・ダイオード (オプション)の	
選択	43
	70
可変遅延時間、ソフトスタート、出力電圧ランプ	
可変遅延時間、ソフトスタート、出力電圧ランプ デジタル・サーボ・モード	44
	44 45
デジタル・サーボ・モード	44 45 45
デジタル・サーボ・モードソフトオフ(シーケンス制御によるオフ)	44 45 45 46
デジタル・サーボ・モードソフトオフ(シーケンス制御によるオフ)INTVccレギュレータ	44 45 45 46 46
デジタル・サーボ・モードソフトオフ(シーケンス制御によるオフ)INTV _{CC} レギュレータ 上側 MOSFETドライバの電源(C _B 、D _B)(LTC3887)	44 45 46 46 47
デジタル・サーボ・モードソフトオフ(シーケンス制御によるオフ)INTV _{CC} レギュレータ上側 MOSFET ドライバの電源(C _B 、D _B)(LTC3887) 低電圧ロックアウト	44 45 45 46 46 47
デジタル・サーボ・モードソフトオフ(シーケンス制御によるオフ)	44 45 46 46 47 47
デジタル・サーボ・モードソフトオフ(シーケンス制御によるオフ)INTV _{CC} レギュレータ上側 MOSFETドライバの電源(C _B 、D _B)(LTC3887) 低電圧ロックアウト C _{IN} とC _{OUT} の選択	44 45 46 46 47 47 48 48
デジタル・サーボ・モード	44 45 46 46 47 47 48 48 49
デジタル・サーボ・モードソフトオフ(シーケンス制御によるオフ)	44 45 46 46 47 47 48 49 50
デジタル・サーボ・モードソフトオフ(シーケンス制御によるオフ)	44 45 46 46 47 48 48 49 50
デジタル・サーボ・モードソフトオフ(シーケンス制御によるオフ)	44 45 46 46 47 47 48 49 50 50
デジタル・サーボ・モードソフトオフ(シーケンス制御によるオフ)	44 45 46 46 47 47 48 48 49 50 50 51
デジタル・サーボ・モードソフトオフ(シーケンス制御によるオフ)	44 45 46 46 47 47 48 49 50 50 51 52

目次

プリント回路基板レイアウトのチェックリスト	54
PC基板レイアウトのデバッグ	56
設計例	57
設計に関するその他の確認事項	59
USBからI ² C/SMBus/PMBusへのコントローラを	
システム内のLTC3887へ接続	59
LTpowerPlay: デジタル電源用の対話型 GUI	61
PMBus の通信とコマンド処理	
PMBus コマンドの詳細	63
アドレス指定および書き込み保護	63
汎用構成レジスタ	
オン/オフ/マージン	66
PWM構成	68
電圧	70
入力電圧と制限値	70
出力電圧と制限値	71
電流	73
入力電流の較正	73
出力電流の較正	74
入力電流	74
出力電流	75
温度	76
外部温度の較正	76
外部温度リミット	77
タイミング	78
タイミング - オン・シーケンス/ランプ	78
タイミング - オフ・シーケンス/ランプ	79
再起動の前提条件	79
フォルト応答	
フォルト応答 - 全フォルト	80
フォルト応答 - 入力電圧	

フォルト応答 - 出力電圧	81
フォルト応答 - 出力電流	84
フォルト応答 - IC 温度	85
フォルト応答 - 外部温度	85
フォルト共有	87
フォルト共有 - 伝播	87
フォルト共有 - 応答	88
スクラッチパッド	89
識別	89
フォルトの警告および状態	90
遠隔測定值	97
NVM(EEPROM)メモリ・コマンド	
ストア/リストア	101
フォルト・ログ	101
ブロック・メモリ書き込み/読み出し	106
標準的応用例	
パッケージ	
標準的応用例	112
関連製品	112

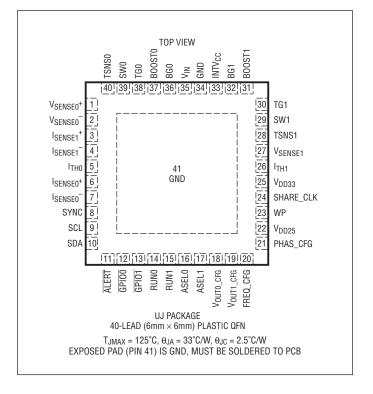


絶対最大定格

(Note 1)

V _{IN} 電圧0.3V~28V
上側ゲート・トランジェント電圧TGO、
TG1 LTC38875V~34V
B00ST1、B00ST00.3V ~ 34V
スイッチ・トランジェント電圧SW1、
SW0 LTC38875V \sim 28V
INTV _{CC} 、(BOOST1 - SW1)、(BOOST0 - SW0)、
BG0、BG1、LTC38870.3V \sim 6V
V_{SENSE0^+} , V_{SENSE1} , $I_{SENSE0n}$, $I_{SENSE1n}$ 0.3V \sim 6V
RUNO, RUN1, SDA, SCL, $\overline{\text{ALERT}}$ 0.3V \sim 5.5V
FREQ_CFG \sim V _{OUTn_CFG} 、ASEL0/1、V _{DD25} 0.3V \sim 2.75V
V _{DD33} , GPIO0, GPIO1, TSNS0, TSNS1, V _{SENSE0} ,
SHARE_CLK, WP, SYNC, ITH n 0.3V \sim 3.6V
INTV _{CC} のピーク出力電流100mA
動作接合部温度範囲
(Note 2) -40° C \sim 125 $^{\circ}$ C
保存温度範囲40℃~150℃*
* 接合部温度が125℃を超える場合には、「アプリケーション
情報」セクションの「温度によるEEPROM保持特性のディ
レーティング」を参照してください。

ピン配置



発注情報

無鉛仕上げ	テープアンドリール	製品マーキング*	パッケージ	接合部温度範囲
LTC3887EUJ#PBF	LTC3887EUJ#TRPBF	LTC3887UJ	40-Lead (6mm×6mm) Plastic QFN	-40°C to 125°C
LTC3887IUJ#PBF	LTC3887IUJ#TRPBF	LTC3887UJ	40-Lead (6mm×6mm) Plastic QFN	-40°C to 125°C

さらに広い動作温度範囲で規定されるデバイスについては、弊社または弊社代理店にお問い合わせください。

無鉛仕上げの製品マーキングの詳細については、http://www.linear-tech.co.jp/leadfree/をご覧ください。 テープアンドリールの仕様の詳細については、http://www.linear-tech.co.jp/tapeandreel/をご覧ください。



^{*}温度グレードは出荷時のコンテナのラベルで識別されます。非標準の鉛仕上げ製品の詳細については、弊社または弊社代理店にお問い合わせください。

電気的特性

●は規定動作接合部温度範囲の規格値を意味する。それ以外はT_A = 25°Cでの値(Note 2)。 注記がない限り、V_{IN} = 12V、V_{RUND,1} = 3.3V、f_{SYNC} = 500kHz(外部から駆動)。

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS
入力電圧							
VIN	Input Voltage Range	(Note 12)	•	4.5		24	V
IQ	Input Voltage Supply Current Normal Operation	V _{RUNO,1} = 3.3V, No Caps on TG and BG V _{RUN0,1} = 0V			25 20		mA mA
V _{UVLO}	Undervoltage Lockout Threshold when V _{IN} > 4.3V	V _{INTVCC} Falling V _{INTVCC} Rising			3.7 3.95		V
T _{INIT}	Initialization Time	Time from V _{IN} Applied Until the TON_DELAY Timer Starts.			70		ms
制御ループ							
V _{OUTR0}	Full-Scale Voltage High Range Set Point Accuracy (0.6V to 5V) Resolution LSB Step Size	VOUT_COMMAND = 5.500V (Note 9)	•	5.45 -0.5	12 1.375	5.55 0.5	V % Bits mV
V _{OUTR1}	Full-Scale Voltage Low Range Set Point Accuracy (0.6V to 2.5V) Resolution LSB Step Size	VOUT_COMMAND = 2.75V (Note 9)	•	2.7 -0.5	12 0.6875	2.8 0.5	V % Bits mV
V _{LINEREG}	Line Regulation	6V < V _{IN} < 24V	•			±0.02	%/V
VLOADREG	Load Regulation	$\Delta V_{ITH} = 1.35V - 0.7V$ $\Delta V_{ITH} = 1.35V - 2.0V$	•		0.01 -0.01	0.1 -0.1	% %
9m0,1	Error Amplifier g _m	I _{TH0,1} =1.22V			3		mmho
I _{ISENSE0,1}	Input Current	VISENSE = 5.5V	•		±1	±3	μA
V _{SENSERINO}	V _{SENSE} Input Resistance to Ground	$0V \le V_{PIN} \le 5.5V$			41		kΩ
V _{SENSERIN1}	V _{SENSE} Input Resistance to Ground	$0V \le V_{PIN} \le 5.5V$			37		kΩ
VIILIMIT	Resolution				3		bits
	VILIMMAX	Hi Range Lo Range	•	68 44	75 50	82 56	mV mV
	VILMMIN	Hi Range Lo Range			37.5 25		mV mV
ゲート・ドラ	イバ						
TG0,1 t _r t _f	TG Transition Time: Rise Time Fall Time	(Note 4) C _{LOAD} = 3300pF C _{LOAD} = 3300pF			30 30		ns ns
BG0,1 t _r t _f	BG Transition Time: Rise Time Fall Time	(Note 4) C _{LOAD} = 3300pF C _{LOAD} = 3300pF			30 30		ns ns
TG/BG t _{1D}	Top Gate Off to Bottom Gate On Delay Time	(Note 4) C _{LOAD} = 3300pF Each Driver			30		ns
BG/TG t _{2D}	Bottom Gate Off to Top Gate On Delay Time	(Note 4) C _{LOAD} = 3300pF Each Driver			30		ns
ton(MIN)	Minimum On-Time				90		ns
0V 出力電圧	スーパバイザ						
N	Resolution				8		Bits
V _{RANGE0}	Voltage Monitoring Range	Range Value = 0		1		5.6	V
V _{RANGE1}	Voltage Monitoring Range	Range Value = 1		0.5		2.7	V
V _{OUSTPO}	Threshold Programming Step	Range Value = 0			22.5		mV
V _{OUSTP1}	Threshold Programming Step	Range Value = 1	-		11.25		mV
V _{THACCO}	Threshold Accuracy 2V < V _{OUT} < 5V	Range Value = 0				±2	<u>%</u>
V _{THACC1}	Threshold Accuracy 1V < V _{OUT} < 2.5V	Range Value = 1	•			±2	<u>%</u>
t _{PROPOV}	OV Comparator to GPIO Low Time	$V_{OD} = 10\%$ of Threshold				35	μs



LTC3887

電気的特性

●は規定動作接合部温度範囲の規格値を意味する。それ以外はT_A = 25°Cでの値(Note 2)。 注記がない限り、V_{IN} = 12V、V_{RUN0,1} = 3.3V、f_{SYNC} = 500kHz(外部から駆動)。

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS
UV出力電圧	スーパバイザ						
N	Resolution				8		bits
V _{RANGE0}	Voltage Range	High Range		1		5.5	V
V _{RANGE1}	Voltage Range	Low Range		0.5		2.7	V
V _{OUSTPO}	Step Size	Range Value = 0, High Range			22		mV
V _{OUSTP1}	Step Size	Range Value = 1, Low Range			11		mV
V _{THACC0}	Threshold Accuracy 2V < V _{OUT1} < 5V	Range Value = 0, High Range	•			±2	%
V _{THACC1}	Threshold Accuracy 1V < V _{OUT1} < 2.5V	Range Value = 1, Low Range	•			±2	%
tpropuv	UV Comparator to GPIO Low Time	V _{OD} = 10% of Threshold				100	μs
V _{IN} 電圧スー	·パバイザ						
N	Resolution				8		bits
VINRANGE	Full-Scale Voltage			4.5		20	V
VINSTP	Step Size				82		mV
VINTHACC	Threshold Accuracy 9.0V < V _{IN} < 20V		•			±2.5	%
VINTHACC\M	Threshold Accuracy 4.5V < V _{IN} ≤ 9V		•			±5	%
tpropvin	Comparator Response Time (VIN_ON and VIN_OFF)	V _{OD} = 10% of Threshold				100	μs
出力電圧読	1						
N	Resolution				16		Bits
	LSB Step Size				244		μV
V _{OFS}	Full-Scale Voltage	(Note 10) V _{RUNn} = 0V (Note 8)			8		V
V _{OUT_TUE}	Total Unadjusted Error	(Note 8) $V_{OUTn} > 0.6V$	•			0.5	%
Vos	Zero-Code Offset Voltage					±500	μV
tconvert	Conversion Time	(Note 6)			100		ms
V _{IN} 電圧読み	4出し						
N	Resolution	(Note 5)			10		Bits
V _{IFS}	Full-Scale Voltage	(Note 11)			38.91		V
V _{IN_TUE}	Total Unadjusted Error	V _{VIN} > 4.5V (Note 8)	•			0.5 2	% %
tconvert	Conversion Time	(Note 6)			100		ms
出力電流読	<u> </u>						
N	Resolution	(Note 5)			10		Bits
	LSB Step Size	$ \hat{O}V \le V_{ISENSE}^+ - V_{ISENSE}^- < 16mV$			15.625		μV
		$16\text{mV} \le V_{\text{ISENSE}}^+ - V_{\text{ISENSE}}^- < 32\text{mV}$			31.25		μV
		$32\text{mV} \le V_{\text{ISENSE}^+} - V_{\text{ISENSE}^-} < 63.9\text{mV}$ $63.9\text{mV} \le V_{\text{ISENSE}^+} - V_{\text{ISENSE}^-} < 127.9\text{mV}$			62.5 125		μV μV
I _{FS}	Full-Scale Current	(Note 7) RISENSE = $1 \text{m}\Omega$			±128		A
I _{OUT_TUE}	Total Unadjusted Error	(Note 8) VISENSE > 6mV				±1	——————————————————————————————————————
V _{0S}	Zero-Code Offset Voltage	(Marc a) AISENSE > 0111A				±28	μV
tconvert	Conversion Time	(Note 6)			100		ms
	よびデューティ・サイクル読み出し	(11010 0)			100		
D_RES	Resolution				10		Bits
D_TUE	Total Unadjusted Error	16.3% Duty Cycle		-3		3	%
t _{CONVERT}	Update Rate	(Note 6)			100		ms
	U(T0, T1, T2)	(1110
T _{RES_T}	Resolution				0.25		°C
T0,1_TUE	External TSNS TUE	$\Delta V_{TSNS} = 72 \text{mV (Note 8)}$	•		J.L0	±3	
T2_TUE	Internal TSNS TUE	V _{RUN0.1} = 0.0V, f _{SYNC} = 0kHz (Note 8)			±1		
tCONVERT_T	Update Rate	(Note 6)	+		100		ms
-OONVERI_I	- Speake Hate	(11010-0)			100		

.

3887f



詳細: www.linear-tech.co.jp/LTC3887

電気的特性 ●は規定動作接合部温度範囲の規格値を意味する。それ以外はT_A = 25°Cでの値(Note 2)。 注記がない限り、V_{IN} = 12V、V_{RUNO,1} = 3.3V、f_{SYNC} = 500kHz(外部から駆動)。

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS
INTV _{CC} レギュ	レータ						
VINTVCC	Internal V _{CC} Voltage No Load	6V < V _{IN} < 24V		4.8	5	5.2	V
V _{LDO_INT}	INTV _{CC} Load Regulation	I _{CC} = 0mA to 50mA			0.5	±2	%
V _{DD33} レギュレ	ータ						
V_{DD33}	Internal V _{DD33} Voltage	4.5V < VINTVCC		3.2	3.3	3.4	V
ILIM(VDD33)	V _{DD33} Current Limit	$V_{DD33} = GND$			70		mA
V _{DD33_0V}	V _{DD33} Overvoltage Threshold				3.5		V
V _{DD33_UV}	V _{DD33} Undervoltage Threshold				3.1		V
V _{DD25} レギュレ	ータ						
V _{DD25}	Internal V _{DD25} Voltage				2.5		V
I _{LIM(VDD25)}	V _{DD25} Current Limit	$V_{DD25} = GND$			50		mA
発振器とフェ	ーズロック・ループ						
fosc	Oscillator Frequency Accuracy	250kHz < f _{SYNC} < 1MHz Measured Falling Edge-to-Falling Edge of SYNC with SWITCH_ FREQUENCY = 250.0 and 1000.0	•			±7.5	%
V _{TH} ,SYNC	SYNC Input Threshold	V _{CLKIN} Falling V _{CLKIN} Rising			1 1.5		V
V _{OL,SYNC}	SYNC Low Output Voltage	$I_{LOAD} = 3mA$			0.2	0.4	V
I _{LEAKSYNC}	SYNC Leakage Current in Slave Mode	$0V \le V_{PIN} \le 3.6V$				±5	μА
θSYNC-θ0	SYNC to Ch0 Phase Relationship Based on the Falling Edge of Sync and Rising Edge of TG0	MFR_PWM_CONFIG_LTC3887[2:0] = 0, 2, 3 MFR_PWM_CONFIG_LTC3887[2:0] = 5 MFR_PWM_CONFIG_LTC3887[2:0] = 1 MFR_PWM_CONFIG_LTC3887[2:0] = 4, 6			0 60 90 120		Deg Deg Deg Deg
θSYNC-θ1	SYNC to Ch1 Phase Relationship Based on the Falling Edge of Sync and Rising Edge of TG1	MFR_PWM_CONFIG_LTC3887[2:0] = 3 MFR_PWM_CONFIG_LTC3887[2:0] = 0 MFR_PWM_CONFIG_LTC3887[2:0] = 2, 4, 5 MFR_PWM_CONFIG_LTC3887[2:0] = 1 MFR_PWM_CONFIG_LTC3887[2:0] = 6			120 180 240 270 300		Deg Deg Deg Deg Deg
EEPROM の特	性						
Endurance	(Note 13)	$0^{\circ}\text{C} < \text{T}_{\text{J}} < 85^{\circ}\text{C}$ During EEPROM Write Operations	•	10,000			Cycles
Retention	(Note 13)	T _J < T _{JMAX}	•	10			Years
Mass_Write	Mass Write Operation Time	STORE_USER_ALL, 0°C < TJ < 85°C During EEPROM Write Operations	•		440	4100	ms
デジタル入力	SCL、SDA、RUNO、RUN1、GPIOO、GPIO1						
V _{IH}	Input High Threshold Voltage	SCL, SDA, RUNO, RUN1, GPIOO, GPIO1	•			2.0	V
V _{IL}	Input Low Threshold Voltage	SCL, SDA, RUNO, RUN1, GPIOO, GPIO1	•	1.4			V
V _{HYST}	Input Hysteresis	SCL, SDA			0.08		V
C _{PIN}	Input Capacitance					10	pF
デジタル入力	WP						
I _{PUWP}	Input Pull-Up Current	WP			10		μΑ
	イン出力 SCL、SDA、GPIOO、GPIO1、ALERT、RUN	_					
V _{0L}	Output Low Voltage	I _{SINK} = 3mA	•			0.4	V
	SHARE_CLK、WP			T			
VIH	Input High Threshold Voltage				1.5	1.8	V
VIL	Input Low Threshold Voltage			0.6	1		V
	, SCL, ALERT, RUNO, RUN1	Ta., .,	1 -	1			
loL	Input Leakage Current	$0V \le V_{PIN} \le 5.5V$	•			±5	μΑ



電気的特性

●は規定動作接合部温度範囲の規格値を意味する。それ以外はT_A = 25°Cでの値(Note 2)。 注記がない限り、V_{IN} = 12V、V_{RUN0,1} = 3.3V、f_{SYNC} = 500kHz(外部から駆動)。

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS		
漏れ電流 GPIOO、GPIO1									
I _{GL}	Input Leakage Current	$0V \le V_{PIN} < 3.6V$	•			±5	μA		
GPIOO, GPIO	0デジタル・フィルタリング		,						
I _{FLTG}	Input Digital Filtering GPIO				3		μs		
RUNO, RUN1	のデジタル・フィルタリング								
I _{FLTG}	Input Digital Filtering RUN				10		μs		
PMBus インタ	フェースのタイミング特性								
f _{SMB}	Serial Bus Operating Frequency		•	10		400	kHz		
t _{BUF}	Bus Free Time Between Stop and Start		•	1.3			μs		
thd,sta	Hold time After Repeated Start Condition.After this Period, the First Clock is Generated		•	0.6			μs		
t _{SU,STA}	Repeated Start Condition Setup Time		•	0.6			μs		
t _{SU,STO}	Stop Condition Setup Time		•	0.6			μs		
t _{HD,DAT}	Data Hold Time Receiving Data Transmitting Data		•	0 0.3		0.9	μs μs		
t _{SU,DAT}	Data Setup Time Receiving Data		•	0.1			μs		
t _{TIMEOUT_SMB}	Stuck PMBus Timer Non-Block Reads Stuck PMBus Timer Block Reads	Measured from the Last PMBus Start Event			32 150		ms ms		
t _{LOW}	Serial Clock Low Period		•	1.3		10000	μs		
thigh	Serial Clock High Period		•	0.6			μs		

Note 1: 絶対最大定格に記載された値を超えるストレスはデバイスに永続的損傷を与える可能性がある。長期にわたって絶対最大定格条件に曝すと、デバイスの信頼性と寿命に悪影響を与える恐れがある。

Note 2: LTC3887 はTJがTAにほぼ等しいパルス負荷条件でテストされる。LTC3887Eは0°C~85°Cの温度範囲で性能仕様に適合することが保証されている。-40°C~125°Cの動作接合部温度範囲での仕様は設計、特性評価および統計学的なプロセス・コントロールとの相関で確認されている。LTC3887Iは-40°C~125°Cの全動作接合部温度範囲で保証されている。TJは周囲温度 T_A および電力損失 T_D から次式に従って計算される。

 $T_J = T_A + (P_D \cdot \theta_{JA})$

これらの仕様を満たす最大周囲温度は、固有の動作条件と基板レイアウト、パッケージの定格熱インピーダンス、その他の環境要因との組み合わせによって決まる。

Note 3: デバイスのピンに流れ込む電流は全て正。デバイスのピンから流れ出す電流は全て負。注記がない限り、全ての電圧はグランドを基準にしている。

Note 4: 立ち上がり時間と立ち下がり時間は10%と90%のレベルを使って測定する。遅延時間は50%レベルを使って測定する。

Note 5: PMBus のデータ形式は、指数部5ビット(符号付き)、仮数部11ビット(符号付き)である。このため、内蔵 ADC は16ビット、計算は32ビット・ワードを用いるものの、出力の分解能は10ビットに制限される。

Note 6: データ変換はラウンド・ロビン方式で実行される。全ての入力信号は、標準レイテンシ $100 \mathrm{ms}$ で、連続的に変換される。ただし、MFR_ADC_CONTROL コマンドは使用しない場合。

Note 7: IOUT_CAL_GAIN = 1.0mΩ、MFR_IOUT_CAL_GAIN_TC = 0.0である。READ_IOUTよりアンペア単位で読み出される値。

Note 8: 製品のテストは PWMをディスエーブルして実施される。能力はアプリケーション内での評価によって実証されている。 TUE(%) = ADC 利得誤差(%) + 100・[ゼロ・コード・オフセット+ADC の直線性誤差]/実際の値

Note 9:全てのV_{OUT}コマンドは、規定の精度を得るために、ADCを用いて出力に対して自動ゼロ点補正を行うことを前提としている。LTC3887は、V_{OUT}を規定の値にサーボ制御する帰還ループ内でテストされる。

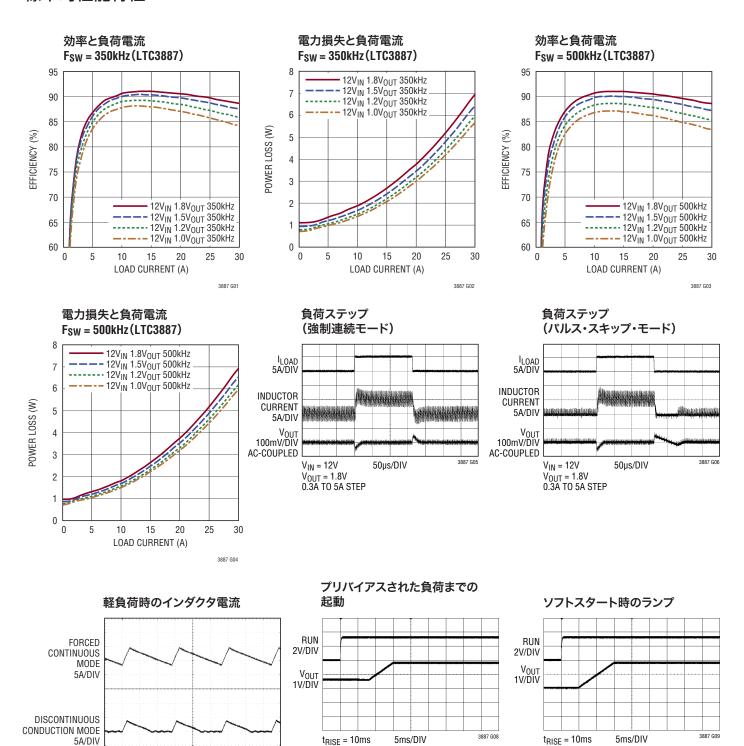
Note 10:最大 V_{OUT} 電圧は5.5V である。

Note 11:最大 V_{IN} 電圧は 28V である。

Note 12: V_{IN} < 6V の場合、INTV_{CC}を V_{IN} に接続する必要がある。

Note 13: EEPROMの耐久性とデータ保持能力は、設計、特性評価および統計学的なプロセス・コントロールとの相関で保証されている。最小保持時間仕様は、内蔵 EEPROMの書き込みサイクル数が最小耐久性仕様より少ないデバイスに適用される。RESTORE_USER_ALL (EEPROM 読み出し)は、全動作接合部温度範囲で有効なコマンドである。

LINEAR TECHNOLOGY



LINEAR

 $\begin{aligned} V_{IN} &= 12V \\ V_{OUT} &= 1.8V \\ I_{LOAD} &= 1A \end{aligned}$

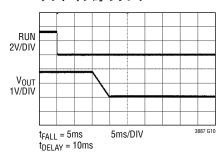
1µs/DIV

3887f

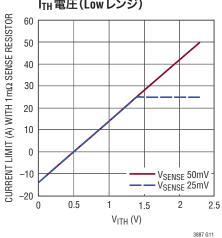
 $t_{DELAY} = 5ms$

 $t_{DELAY} = 5ms$

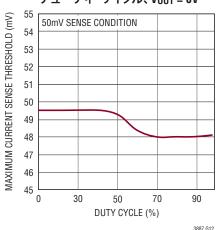
ソフトオフ時のランプ



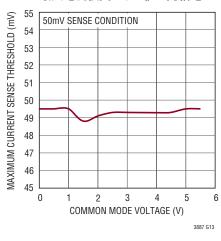
電流検出しきい値と I_{TH}電圧(Low レンジ)



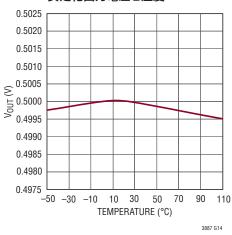
最大電流検出しきい値と デューティ・サイクル、Vout = 0V



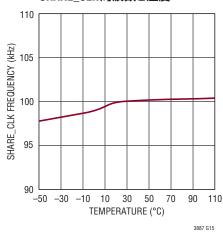
最大電流検出しきい値と同相電圧



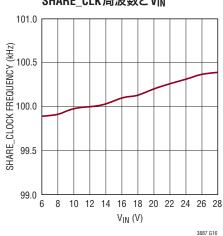
安定化出力電圧と温度



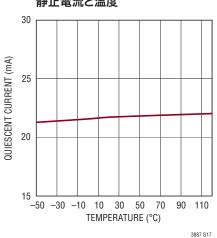
SHARE_CLK 周波数と温度



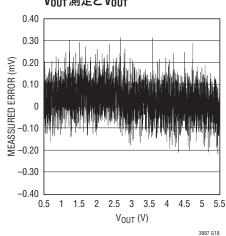
SHARE_CLK 周波数と V_{IN}



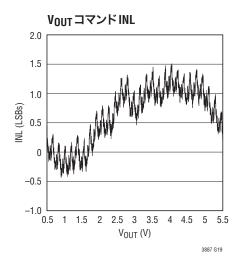
静止電流と温度

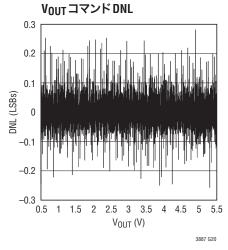


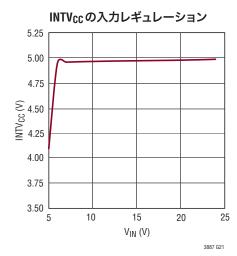
VouT測定とVouT

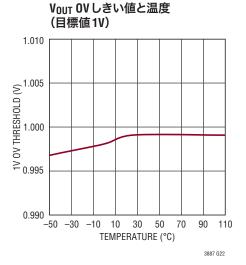


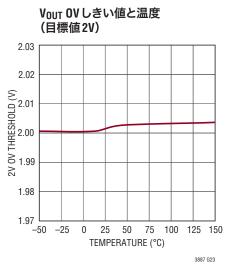


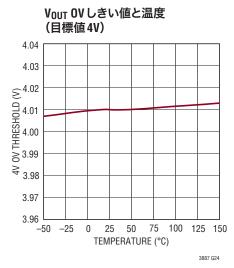


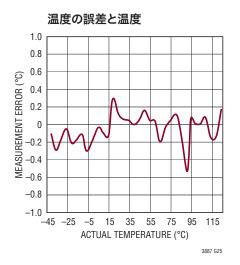


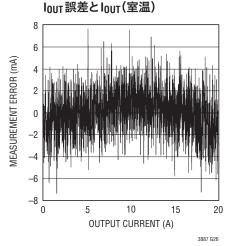


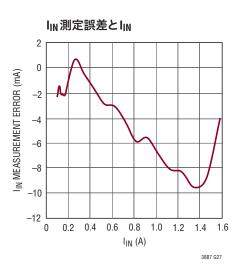








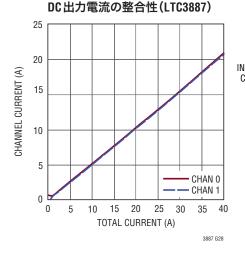




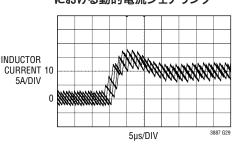
3887f

LINEAR TECHNOLOGY

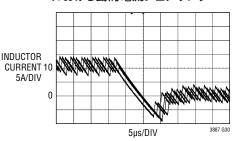
2位相システムにおける



4位相システムの負荷トランジェント における動的電流シェアリング



4位相システムの負荷トランジェント における動的電流シェアリング



ピン機能

V_{SENSEO}⁺(ピン1):チャネル0の正電圧検出入力。

Vsenseo-(ピン2):チャネル0の負電圧検出入力。

ITHO/ITH1(ピン5/ピン26): 電流制御しきい値およびエラー・アンプの補償ノード。対応する各チャネルの電流コンパレータのトリップしきい値は、ITH電圧に応じて増加します。

 I_{SENSE0} †/ I_{SENSE1} †(ピン6/ピン3):電流検出コンパレータの入力。電流コンパレータへの(+)入力は通常、DCR 検出ネットワークまたは電流検出抵抗に接続されます。

|SENSEO-/|SENSE1-(ピン7/ピン4):電流検出コンパレータの入力。 これらの(-)入力は電流検出素子の低電位側に接続されます。

SYNC(ピン8):外部クロック同期入力およびオープンドレイン出力ピン。このピンに外部クロックを入力すると、スイッチング周波数がこの外部クロックに同期します。SYNC出力をイネーブルしている場合、このピンはスイッチング周波数で振動する500nsのパルスによってグランドに引き下げられます。LTC3887のSYNC出力をイネーブルする場合、アプリケーション回路には3.3Vへのプルアップ抵抗が必要です。

SCL(ピン9):シリアル・バスのクロック入力。クロック・ストレッチをイネーブルした場合、オープンドレイン出力が出力を"L" に保持できます。アプリケーション回路には3.3Vへのプルアップ抵抗が必要です。

SDA(ピン10):シリアル・バスのデータ入力および出力。アプリケーション回路には3.3Vに引き上げるプルアップ抵抗が必要です。

ALERT (ピン11): オープンドレインのデジタル出力。このピンにはSMBALERT 信号を接続します。アプリケーション回路には3.3Vへのプルアップ抵抗が必要です。

GPIOO/GPIOT (ピン12/ピン13): デジタル・プログラム可能な 汎用入力および出力。オープンドレインの出力です。アプリケー ション回路には3.3V へのプルアップ抵抗が必要です。

RUN0/RUN1 (ピン14/ピン15): RUNイネーブル入力および出力。これらのピンをロジック"H"にすると、コントローラがイネーブルされます。LTC3887がリセット状態を抜けるまで、オープンドレイン出力がこのピンを"L"に保ちます。アプリケーション回路には3.3Vへのプルアップ抵抗が必要です。

ASELO(ピン16):シリアル・バスのアドレス構成入力。シリアル・バス・インタフェース・アドレスの下位4ビットを選択するために、デバイスのVDD25、ASELO、SGND間に±1%の抵抗分割器を接続します。同一基板上に複数のLTC3887を実装する場合は、ユーザーが各デバイスを独立してプログラムできるように、ASELOに抵抗分割器を接続することを推奨します。このピンを開放のままにすると、デバイスはEEPROMにプログラムされた値を使用します。ピンを開放のままにする場合は、ピンの状態を正確に検出できるように、容量を最小限に抑えてください。

ASEL1(ピン17):シリアル・バスのアドレス構成入力。シリアル・バス・インタフェース・アドレスの上位3ビットを選択するために、デバイスのV_{DD25}、ASEL1、SGND間に±1%の抵抗分割器を接続します。同一基板上に17個以上のLTC3887を実装する場



ピン機能

合は、ユーザーが各デバイスを独立してプログラムできるように、ASEL1に抵抗分割器を接続することを推奨します。このピンを開放のままにすると、デバイスはEEPROMにプログラムされた値を使用します。ピンを開放のままにする場合は、ピンの状態を正確に検出できるように、容量を最小限に抑えてください。

FREQ_CFG (ピン20): 周波数選択ピン。スイッチング周波数を選択するために、デバイスの V_{DD25} 、FREQ_CFG、GND間に $\pm 1\%$ の抵抗分割器を接続します。このピンを開放のままにすると、デバイスはEEPROMにプログラムされた値を使用します。ピンを開放のままにする場合は、ピンの状態を正確に検出できるように、容量を最小限に抑えてください。

PHAS_CFG (ピン21): 位相選択ピン。チャネルの位相同期を選択するために、デバイスの V_{DD25} 、PHAS_CFG、GND間に $\pm 1\%$ の抵抗分割器を接続します。このピンを開放のままにすると、デバイスはEEPROMにプログラムされた値を使用します。ピンを開放のままにする場合は、ピンの状態を正確に検出できるように、容量を最小限に抑えてください。

Vouto_CFG/Vout1_CFG (ピン18/ピン19):電圧選択ピン。出力電圧のセットポイントを調整するために、デバイスのVDD25、Voutn_CFG、GND間に±1%の抵抗分割器を接続します。このピンを開放のままにすると、デバイスはEEPROMを使用します。ピンを開放のままにする場合は、ピンの状態を正確に検出できるように、容量を最小限に抑えてください。

 V_{DD25} (ピン22): 内部で生成される2.5V 電源の出力ピン。低 ESRの1 μ Fコンデンサを使用してこのピンをGND にバイパス します。 構成ピンに必要な $\pm 1\%$ の抵抗分割器を除き、このピンには外部電流による負荷をかけないでください。

WP (ピン23): アクティブ"H"の書き込み保護ピン。内部の 10μ A電流源によって V_{DD33} に引き上げられています。WPが"H"の場合、PMBus 書き込みが制限されます。

SHARE_CLK(ピン24): 共有クロック、双方向オープンドレインのクロック共有ピン。公称100kHzです。複数のLTC388X間でタイミングを同期させるために使用します。全てのSHARE_CLKピンを相互に接続します。全てのLTC388Xが、最速のクロックに同期します。3.3Vへのプルアップ抵抗が必要です。

 V_{DD33} (ピン25): 内部で生成される3.3V電源の出力ピン。低ESRの1 μ Fコンデンサを使用してこのピンをGNDにバイパスします。このピンには外部電流による負荷をかけないでください。ただし、 \overline{GPIO}_n 、SCLK、およびSYNCで必要になり、RUNn、 \overline{ALERT} 、SDA、およびSCLで必要になる可能性のあるプルアップ抵抗を除きます。

Vsense1(ピン27):チャネル1の電圧検出入力。この入力電圧は、GNDピンを基準にしています。

INTV_{CC}(ピン33):内部レギュレータの5V出力。制御回路には、この電圧源から給電されます。最小4.7µFの低ESRタンタル・コンデンサまたはセラミック・コンデンサを使って、このピンを電源グランドにデカップリングします。

GNDSNS(ピン34):グランド検出ピン。このピンは、裏面のパドル・グランドに接続し、裏面のパドルと基板の間に適切なグランド接続が存在するかどうかの検出に使用できます。

 V_{IN} (ピン35): 主入力電源。 0.1μ F~ 1μ Fのコンデンサによって PGND にデカップリングしてください。メインの入力電源が 5Vのアプリケーションでは、 V_{IN} ピンと INTV_{CC}ピンを相互に 接続してください。

BG0/BG1(ピン36/ピン32):下側のゲート・ドライバ出力。これらのピンは、下側のNチャネルMOSFETのゲートをPGNDとINTV $_{CC}$ の間で駆動します。

B00ST0/B00ST1 (ピン37/ピン31): 昇圧されたフローティング・ドライバ電源。ブートストラップ・コンデンサの(+)端子をこれらのピンに接続します。これらのピンは、 $INTV_{CC}$ よりダイオードの電圧降下分だけ低い電圧から V_{IN} + $INTV_{CC}$ まで振幅します。

TGO/TG1 (LTC3887) (ピン38/ピン30): 上側ゲート・ドライバ 出力。これらは、電圧振幅がスイッチ・ノード電圧にINTV_{CC} を重ね合わせた電圧に等しいフローティング・ドライバの出力 です。

SW0/SW1 (LTC3887) (ピン39/ピン29): インダクタへのスイッチ・ノードの接続ピン。このピンの電圧振幅は、グランドより (外付け)ショットキ・ダイオードの電圧降下分だけ低い電圧 から V_{IN}までです。

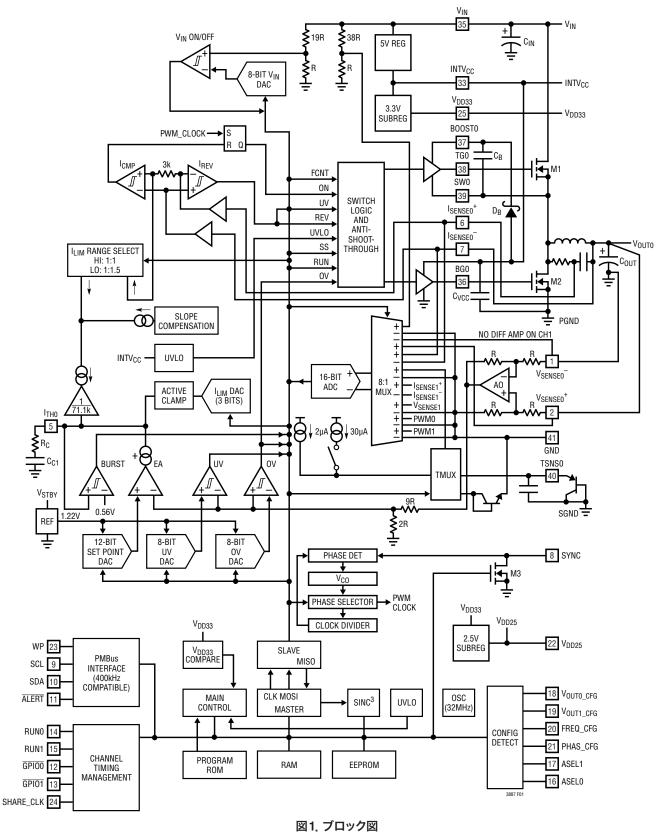
TSNS0/TSNS1(ピン40/ピン28): チャネル0、1の外部ダイオードによる温度検出ピン。ダイオード接続したPNPトランジスタのアノードにこのピンを接続し、カソードをSGNDに直接接続することで、離れた場所の温度を検出できます。温度検出用素子を外付けしない場合は、このピンをグランドに短絡し、UT_FAULT_LIMITを -275° C、IOUT_CAL_GAIN_TCを0に設定し、UT_FAULT_RESPONSEを無視します。

GND(露出パッド・ピン41): グランド。両方の小信号用および 補償用の部品はこのグランドに接続し、このグランド自体は電 源グランドに一点接続します。



ブロック図

2つのチャネルの一方(チャネル0)を表示。(LTC3887アプリケーションのみ)



概要

LTC3887はデジタル・インタフェースを備えた、DC/DC降圧アプリケーション向けのデュアル・チャネル/2相、固定周波数、アナログ電流モードのコントローラです。LTC3887は、ゲート・ドライバを必要とするアプリケーションで使用します。

LTC3887の機能は、LTC3880に非常によく似ています。主な改良点は次のとおりです。

- T_{INIT}起動時間:70ms
- VOUT0/VOUT1は両方とも最大5.5Vに設定可能
- PWM同期回路(詳細については、「スイッチング周波数と 位相」のセクションを参照)
- 1つのパラメータの高速 ADC サンプリングのための MFR_ADC_CONTROL。「PMBus コマンドの詳細」を参照。
- PAGE_PLUSおよびSMBALERTのマスクを追加するバージョン1.2に対応するPMBus。「PMBusコマンドの詳細」を参照。
- 改良されたフォルト・ログ。「PMBusコマンドの詳細」を参照。
- 2相動作のチャネル 0/1 でEA を共有
- 抵抗構成設定ピンを変更。2つのアドレス選択ピン (VOUTn_CFG、PHAS_CFG、およびFREQ_CFG) があります。VOUTn TRIMピンは削除されました。

LTC3887のデジタル・インタフェースは、最大バス周波数 400kHzをサポートするPMBusと互換性があります。標準的アプリケーション回路は、このデータシートの最初のページに記載されています。

主な機能は以下のとおりです。

- プログラム可能な出力電圧
- プログラム可能な入力電圧コンパレータ
- プログラム可能な電流制限
- プログラム可能なスイッチング周波数
- プログラム可能なOV (過電圧)およびUV (低電圧)コンパレータ
- プログラム可能なオン/オフ遅延時間
- プログラム可能な出力立ち上がり/立ち下がり時間
- 同期、PolyPhase動作(2、3、4、6位相)のためのフェーズロック・ループ

- 入力および出力の電圧/電流、温度、デューティ・サイクルのテレメトリ
- 完全差動型の負荷検出
- 内蔵ゲート・ドライバ(LTC3887)
- 不揮発性構成メモリ
- 重要な動作パラメータを格納するオプションの外付け 構成設定抵抗
- 複数のコントローラ間で同期を取るためのオプションの タイムベース・インターコネクト
- フォルト・ログ
- 内部構成を保護するWPピン
- ユーザー向け工場出荷時構成済み製品のスタンドアロン動作
- PMBus 準拠の400kHzインタフェース

システムの動作中は、パワー・マネージメント上重要となる 以下のデータに、PMBusインタフェースを介してアクセスで きます。

- 内部ダイ温度
- オプションのダイオード検出素子を用いた外部システム 温度
- 平均出力電流
- 平均PWMデューティ・サイクル
- 平均出力電圧
- 平均入力電圧
- 平均入力電流
- 個々のフォルトおよび警告をラッチ/ラッチ解除によって 示す構成可能なステータス表示

個々のチャネルには、PAGE コマンド (PAGE 0または1)を使用してPMBus を介してアクセスします。

フォルト報告動作およびシャットダウン動作は完全に設定可能です。2つの GPIO 出力(GPIOO、GPIOI) は個別に供給され、両方の出力を独立してマスクすることができます。また、 ALERT 専用ピンを備えています。シャットダウン動作は、全てのフォルトの個別マスクにも対応し、ラッチ解除モード(ヒカップ)またはラッチ・モードのいずれでも使用できます。



個別のステータス・コマンドによってシリアル・バスを介したフォルト報告が可能なため、特定のフォルト・イベントを識別できます。検出可能なフォルトまたは警告は、次のとおりです。

- 出力低電圧/過電圧
- 入力低電圧/過電圧
- 入力および出力の過電流
- 内部過熱
- 外部過熱
- 通信、メモリ、ロジック(CML)のフォルト

メイン制御ループ

LTC3887は、さまざまなユーザー定義の相対位相設定によっ て動作する、2つのチャネルを備える固定周波数の電流モード 降圧コントローラです。通常動作時は、各チャネルのクロックが RSラッチをセットすると、そのチャネルの上側MOSFETがオン し、メインの電流コンパレータICMPがRSラッチをリセットする とオフします。ICMPがRSラッチをリセットするときのピーク・イン ダクタ電流は、各エラーアンプEAの出力であるITHピンの電圧 によって制御されます。EAの負側端子の電圧は、V_{SENSE}電圧 を5.5で割った値に等しくなります(レンジ = 1の場合は2.75)。 EAの正側端子は、0V~1.024Vの値を取る12ビットDACの出 力に接続されています。出力電圧は、EAの帰還によってDAC 出力の5.5倍(レンジ = 1の場合は2.75倍)に安定化されます。 ユーザーが必要とする出力電圧を合成するために、製品は DACの値を計算します。出力電圧は、表12に詳細を示す抵抗 構成設定ピン、またはVOUTコマンド(EEPROMまたはPMBus コマンドのいずれかによる)を使ってユーザーがプログラムしま す。詳細は、本データシートのPMBus コマンドのセクション、ま たはPMBusの仕様を参照してください。ユーザーはPMBusの VOUT COMMANDによって、いつでも出力電圧を変更できま す。このコマンドには、標準で10ms未満の待ち時間があります。 PMBus Power System Management Protocol Specification を参照して、LTC3887の設定方法を理解することをお勧めし ます。この仕様は、http://www.pmbus.org/specs.html に掲載さ れています。

基本動作の説明を続けます。電流モード・コントローラは、ピーク電流に達すると上側ゲートをオフします。負荷電流が増加すると、VSENSEはDACの基準に対して若干低下します。そのため、平均インダクタ電流が新たな負荷電流に一致するまで、I_{TH}電圧が上昇します。上側MOSFETがオフした後に下側MOSFETがオンします。連続導通モードでは、スイッチング・サイクルが終了するまで下側MOSFETがオン状態を保ちます。

EEPROM(NVM)

LTC3887は、構成設定とフォルト・ログの情報を格納する EEPROMまたはNVM (不揮発性メモリ)を内蔵しています。 EEPROMの書き込み耐性、保持特性、一括書き込みの動作時間は、「電気的特性」および「絶対最大定格」のセクションに規定されています。 $T_J = 85^{\circ}$ Cを超える温度での書き込み動作は可能ですが、電気的特性は保証されておらず、EEPROMは劣化します。 -40° C~125°Cでの読み出し動作によって EEPROMが劣化することはありません。 85° Cを超える温度で EEPROMに書き込むと、保持特性が劣化します。高温で発生しがちなシステム障害のデバッグに役立つフォルト・ログ機能は、EEPROMのフォルト・ログ用アドレスだけに書き込みを実行します。これらのレジスタへの不定期の書き込みが 85° Cより高い温度で実行されると、フォルト・ログのデータ保持特性がわずかに劣化するものの、 73° Cとり高いることはありません。

ダイ温度が85°Cを超えているときにEEPROMに書き込まないことを推奨します。ダイ温度が130°Cを超えると、LTC3887は全てのEEPROMの書き込み動作をディスエーブルします。ダイ温度が125°Cを下回ると、全てのEEPROMの書き込み動作が再度イネーブルされます(ダイ温度が10°Cのヒステリシス付きで160°Cの内部過熱フォルト制限を超えた場合も、コントローラは書き込み動作をディスエーブルします)。

125℃を超える温度でのEEPROMの保持特性の劣化は、次式から無次元の加速係数を計算することによって近似できます。

$$AF = e^{\left[\left(\frac{Ea}{k}\right) \cdot \left(\frac{1}{T_{USE} + 273} - \frac{1}{T_{STRESS} + 273}\right)\right]}$$

LINEAR

ここで、

AF = 加速係数

Ea = 活性化エネルギー = 1.4eV

 $K = 8.617 \cdot 10^{-5} \text{ eV/}^{\circ} \text{K}$

Tuse = 125℃の規定接合部温度

T_{STRESS} = 実際の接合部温度(℃)

例:接合部温度135°Cで10時間動作させた場合の保持特性への影響を計算します。

TSTRESS = 130°C

 $T_{USE} = 125^{\circ}C$

 $AF = e^{[(1.4/8.617 \cdot 10^{-5}) \cdot (1/398 - 1/403)]} = 1.66$

125°Cでの等価動作時間は16.6時間になります。

したがって、EEPROMの全保持時間は、 130° Cの接合部温度で10時間動作させると、6.6時間だけ劣化しました。ただし、EEPROMの 125° Cの最大接合部温度での87,600時間の定格全保持時間に比べると、オーバーストレスの影響は無視できます。

EEPROMの完全性は、パワーオン・リセット後やRESTORE_USER_ALLコマンドの実行後など、EEPROMのデータを読み取るたびに、CRC計算によりチェックされます。CRCエラーが発生した場合、STATUS_BYTEコマンドおよびSTATUS_WORDコマンドのMFRビットが設定されます。STATUS_MFR_SPECIFIC コマンドのNVM CRCエラー・ビットが設定され、ALERTピンとRUNピンが"L"に引き下げられ、安全対策としてディスエーブルされます。デバイスは、特殊アドレス0x7Cまたはグローバル・アドレス0x5Aおよび0x5Bでのみ応答します。

電源投入と初期化

LTC3887は、スタンドアロンの電源シーケンシングと制御されたターンオンおよびターンオフ動作を実行できるように設計されています。単一入力電源 $(4.5V\sim24V)$ によって動作し、3つの内蔵リニア・レギュレータが 2.5V、3.3V、5Vの内部電圧を生成します。 $V_{\rm IN}$ が 6Vを超えない場合、 $INTV_{\rm CC}$ ピンと $V_{\rm IN}$ ピンを相互に接続する必要があります。コントローラの構成は内部しきい値に基づく UVLOによって初期化されます。その条件は、 $V_{\rm IN}$ として約 4V が印加され、5V、3.3V、2.5V のリニア・レギュレータがレギュレーション値の約 20% 以内にあることです。

初期化中は、外付けの構成設定抵抗を識別するとともに、EEPROMの内容をコントローラのコマンドに読み出します(または、それらのいずれか一方の動作)。 GPIOn ピンは、高インピーダンス(Hi-Z)モードになります。 TGn ピン、BGn ピン、およびRUNn ピンは、"L"に保たれます。 LTC3887は、表12~15の内容に基づいて、抵抗で規定されるパラメータを判断します。 詳細は、「抵抗構成設定」のセクションを参照してください。 抵抗構成設定ピンが制御するのは、コントローラのプリセット値の一部のみです。 その他の値は、工場出荷時またはユーザーによって EEPROM にプログラムされます。

構成設定抵抗が挿入されていない場合、またはRCONFIG無視ビット(構成コマンドMFR_CONFIG_ALL_LTC3887のビット6)がアサートされている場合、LTC3887はEEPROMの内容だけに基づいて、DC/DC特性を決定します。パワーアップ時、リセット時、またはRESTORE_USER_ALLコマンドの実行後に読み出されたASEL0とASEL1の値は、これらのピンがオープン状態でない限り常に採用されます。詳細は、「アプリケーション情報」のセクションを参照してください。

デバイス初期化の完了後、別のコンパレータが $V_{\rm IN}$ をモニタします。出力電源シーケンシングが開始されるには、 $V_{\rm IN}$ のしきい値を超える必要があります。 $V_{\rm IN}$ が最初に印加された後、 $T_{\rm ON}$ DELAY タイマを初期化して始動するのに、デバイスは通常 $T_{\rm Oms}$ を必要とします。電圧と電流の読み出しには、さらに $T_{\rm Oms}$ 200ms 待つ必要があります。

ソフトスタート

ソフトスタートする前に、デバイスは実行状態に移行してい なければなりません。LTC3887は、初期化が完了し、VINが VIN_ONしきい値を超えると、RUNピンを解放します。アプ リケーションが複数のLTC3887を使用する場合、各デバイ スは、いずれも初期化が完了して自身のVINがVIN_ONし きい値を超えるまで、それぞれのRUNピンを"L"に保持しま す。SHARE CLKピンは、この信号を接続されたデバイスが、 全て同じタイムベースを使用することを保証します。SHARE CLKピンは、VINが印加されてVINの電圧がVIN_ONしきい 値を超えた後、デバイスが初期化されるまで"L"に保持されま す。SHARE CLKが"L"の場合にターンオフするように(また はオフ状態を保つように)、LTC3887を設定できます(MFR_ CHAN CONFIG LTC3887のビット2を1に設定します)。こ の機能により、基板の制約でRUNピンを相互接続できない 場合でも、多数のLTC IC間で確実に同期を取ることができ ます。一般に、ユーザーがデバイス間の同期を重視する場合 は、対応する全てのRUNピンどうし、および対応する全ての



SHARE_CLKピンどうしを相互に接続することを推奨します。これによって、全てのチップが同時にシーケンシングを開始し、同じタイムベースで動作することを保証できます。

RUNピンの解放から一定の出力電圧レギュレーション状態 に移行するまで、LTC3887は単調な初期ランプ動作「ソフトス タート」を実行します。ソフトスタートは、負荷電圧をアクティ ブに安定化しながら、目標電圧をOVから指示した電圧のセッ トポイントまでデジタルにランプ・アップさせることで実現しま す。LTC3887がオンするように指示されると(電源投入と初期 化の完了後)、コントローラはユーザーが指定するターンオン 遅延(TON DELAY)を待ってから、出力電圧のランプを開始 します。電圧ランプの立ち上がり時間はTON RISEコマンド によってプログラムできるため、起動時の電圧ランプに伴う突 入電流を最小限に抑えることができます。ソフトスタート機能 は、TON RISEの値を0.25ms未満の任意の値に設定するこ とでディスエーブルできます。TON_RISE動作中、LTC3887の PWM は常に不連続モードを使用します。不連続モードでは、 インダクタで逆電流が検出されると、直ちに下側ゲートがオ フされます。この動作により、レギュレータはプリバイアスされ た負荷でも起動できるようになります。TON MAX FAULT LIMITの時間が経過すると、デバイスは連続モードに移行 します(そのようにプログラムされている場合)。TON_MAX_ FAULT LIMITがゼロに設定されている場合、時間の制限は なくなり、デバイスはTON RISEが経過し、VOUTがVOUT UV FAULT LIMITを超えた時点で、IOUT OCが存在しな ければ、目標とする導通モードに移行します。TON MAX FAULT LIMITの値を0に設定することは推奨しません。ここ で説明した起動シーケンシングの方法は時間ベースです。

Voltage Based Sequencing by Cascading GPIOs into RUN Pins

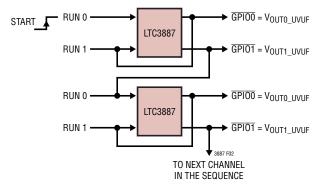


図2. イベント(電圧)ベースのシーケンシング

シーケンシング

出力をオン/オフするシーケンシングのデフォルト・モードは 時間ベースです。各出力は、RUNピンが"H"へ遷移するか、 プログラムされた電圧を超過するのに続き、TON DELAYの 時間が経過した後にイネーブルされます。オフ・シーケンシン グも同様に処理されます。適切なシーケンシングを保証するた めに、全てのデバイスのSHARE CLKピンが相互接続され、 RUNピンが相互接続されていることを確認します。何らかの 理由でRUNピンを相互接続できない場合は、MFR CHAN CONFIG LTC3887のビット2を1に設定します。このビットを セットした場合、電源出力を起動する前に、SHARE CLKピ ンをクロック駆動しておく必要があります。RUNピンが"L"に 引き下げられると、MFR RESTART DELAYの間、LTC3887 がこのピンを"L"に保持します。MFR RESTART DELAYの 最小値は、TOFF DELAY + TOFF FALL + 136msです。こ の遅延は、あらゆる電源レールに対する適切なシーケンシン グを保証します。LTC3887は、内部でのこの遅延を計算し、こ れより短い遅延は処理しません。しかし、MFR RESTART DELAY コマンドによる、より長い遅延は適用されます。 許容さ れる最大値は65.52秒です。

イベントベース・シーケンシング

各出力のUVしきい値を超えた時点で、GPIOnピンをアサー トできます。GPIOピンの1つの出力を、シーケンス内の次の 出力のRUNピンに供給できます。電圧ベースのシーケンシン グに GPIOn ピンを使用するには、MFR GPIOn PROPAGATE コマンドのビット12を1に設定します。ビット12は、フィルタを 通していない VOUT UV コンパレータである、VOUT UVUF です。フィルタを通していない VOUT UV フォルト・リミットの 使用を推奨します。コンパレータがUVしきい値を超えてから GPIO ピンが解放されるまでに感知できるほどの遅延はほとん どないからです。この方式は、複数のLTC3887にまたがって 実装できます。VOUT UVUFには250usのフィルタが適用さ れます。VOLIT電圧がUVしきい値の前後を長期間にわたり行 き来すると、GPIO出力が複数回トグルする可能性があります。 この問題を最小限に抑えるには、TON_RISE時間を100ms 未満に設定します。電源レールのストリング内でフォルトが検 出された場合、そのフォルトの生じた電源レールおよびそれよ り下流の電源レールのみがオフします。デバイス・ストリング内 の、フォルトが発生した電源レールより前の電源レールは、コ マンドによってオフされない限り、オン状態を保ちます。

LINEAR TECHNOLOGY

シャットダウン

LTC3887には、2つのシャットダウン・モードがあります。 第1のモードは、ユーザー定義のターンオフ遅延(TOFF_ DELAY)とランプ・ダウン・レート(TOFF_FALL)による閉ループ・シャットダウン応答です。コントローラはTOFF_ FALLの期間、動作モードを維持します。不連続導通モードの場合、コントローラは負荷からの電流を流さないため、立ち下がり時間は出力容量と負荷電流によって決まります。

もう1つのシャットダウン・モードは、フォルト状態が発生し たか、SHARE CLKを喪失したか(MFR CHAN CONFIG LTC3887のビット2が1に設定されている場合)、V_{IN}がVIN OFFしきい値を下回るか、または GPIO が外部から"L"に引き 下げられた場合(MFR GPIO RESPONSEが禁止に設定さ れている場合)に、それに対する応答として生じます。これらの 条件下では、負荷へのエネルギー伝達をできるだけ迅速に停 止するために、電力段がディスエーブルされます。シャットダウ ン状態にはソフトスタートまたはアクティブなレギュレーション 状態から移行できます。いずれの場合も、ユーザーの介入を 通じて(RUNnのディアサートまたはPMBusのOPERATION コマンド)、あるいは検出されたフォルト、双方向 GPIOn ピン を介した外部フォルト、SHARE CLKの喪失(MFR CHAN CONFIG LTC3887のビット2が1に設定されている場合)、ま たはV_{IN}のVIN_OFFしきい値未満への低下に応答して移行 されます。

ヒカップ・モードの場合、コントローラはフォルトに対して、 シャットダウン動作と、プログラム可能な遅延(MFR RETRY DELAY)の期間、非アクティブ状態に移行することで応答しま す。この遅延により、出力が無効化されることでシャットダウン の原因となったフォルトが解消された場合に、自動リトライに伴 うデューティ・サイクルを最小限に抑えることができます。リトラ イの遅延時間は、MFR RETRY DELAYコマンドまたは安定 化出力がプログラム値の12.5%未満に減衰するまでに要する時 間の、いずれか長い方で決まります。複数の出力を同じGPIOピ ンによって制御している場合、フォルトが発生した出力の減衰 時間がリトライ遅延を決定します。出力が自然に減衰するまで の時間が長すぎる場合、MFR_CHAN_CONFIG_LTC3887の ビット0をアサートすることでMFR RETRY DELAYコマンドの 電圧要件を解除できます。あるいは、コントローラがフォルト後 にラッチ・オフされたままになり、クリアするにはRUNnピンをト グルしたり、デバイスをコマンドによりオフしてから再度オンした りするなどユーザーの介入が必要になるように、コントローラを 設定することもできます。

軽負荷電流動作

LTC3887には、不連続導通モードおよび強制連続導通モードという2つの動作モードがあります。これらのモードはMFR_PWM_MODE_LTC3887コマンドによって選択します(起動時のモードは常に不連続導通モード、デフォルトの動作モードは強制連続モードです)。

コントローラが不連続動作するようにイネーブルされている と、インダクタ電流は反転できません。インダクタ電流がゼロ に達する直前に、逆電流コンパレータ(IREV)が外付けの下側 ゲートMOSFETをオフし、インダクタ電流が反転して負になる のを防ぎます。強制連続動作の場合は、軽負荷時または大き なトランジェント状態でインダクタ電流が反転できます。ピー ク・インダクタ電流はITHピンの電圧だけで決まります。この モードでは、軽負荷での効率が不連続モード動作よりも低下 します。ただし、連続モードは出力リップルが小さく、オーディ オ回路への干渉が抑えられます。強制連続導通モードはイン ダクタ電流の反転を招く可能性があり、これによって入力電 源が昇圧される場合があります。VIN_OV_FAULT_LIMITは、 この状態を検出し、障害が発生したチャネルをオフすることが できます。ただし、このフォルトはADCの読み出し値に基づい て生成されるため、検出に最大120msを要する場合がありま す。入力電源の昇圧が懸念される場合は、デバイスの動作を 不連続導通モードに保ってください。

デバイスを不連続動作に設定した場合、コントローラはインダクタ平均電流の増加に合わせて、動作モードを不連続モードから連続モードへと自動的に切り換えます。

スイッチング周波数と位相

LTC3887コントローラのスイッチング周波数は、内部のクロック基準または外部のタイムベースに基づいて決定できます。LTC3887は、EEPROMに設定された値、PMBusコマンド、またはPHAS_CFGピンでSYNC出力をディスエーブルするように設定することによって、外部クロック入力に構成できます。MFR_PWM_CONFIG_LTC3887コマンドが相対位相を決定します。各レールは互いに位相がずれるように選択してください。FREQUENCYコマンドおよびMFR_PWM_CONFIG_LTC3887コマンドをLTC3887に書き込む前に、両方のRUNピンを"L"にするか、両方のチャネルをオフに指定しておく必要があります。PolyPhase電源レール内では、全デバイスの相対位相を適切に設定してください。各電源レール間の相対位相は360/nです。nは電源レール内の位相数です。



LTC3887は、外部クロックの周波数が内部PWMクロックの1/2を超えている限り、外部SYNC入力を自動的に受け入れ、必要に応じて専用のSYNC出力をディスエーブルします。LTC3887は、SYNC出力を駆動するよう構成されているかどうかに関係なく、後に外部クロック信号が失われると、デバイス自体の内部発振器を使用して、PWM動作を継続することができます。

LTC3887をSYNC、SYNC ENABLEDの発振器出力として構成した場合、スイッチング周波数のソースは外付けの構成設定抵抗またはシリアル・バス・プログラミングのいずれかによって選択できます。FREQ_CFG構成抵抗ピンを使用して、FREQUENCY_SWITCHを選択できます。PHAS_CFGピンを使用してMFR_PWM_CONFIG_LTC3887を設定し、SYNC出力をイネーブルして、表13および14に示した出力周波数を生成できます。あるいは、PMBusコマンドのFREQUENCY_SWITCHおよびMFR_PWM_CONFIG_LTC3887を使って、PWMのスイッチング周波数とPWMチャネル間の位相関係を選択することも可能です。位相と周波数の関係は互いに完全に独立しているため、アプリケーションにおけるユーザーの選択肢の幅が広がります。

MFR_CONFIG_ALL_LTC3887のビット4を0に設定して、SYNC出力を駆動するようにLTC3887を構成した場合、SYNCピンは、500nsの"L"パルスによって、目標のクロック・レート(FREQUENCY_SWITCHコマンドで設定)で"L"に引き下げられます。アプリケーションでは、SYNCの容量が最低限に抑え、コンデンサ負荷に対するプルアップ抵抗の時定数がアプリケーションにとって十分小さいことを確認する必要があります。さらに、LT3887は、SYNCピンに接続された外部クロック・ソースに内部発振器を同期させる、フェーズロック・ループ(PLL)も搭載しています。全ての位相の関係性は、SYNCの立ち下がりエッジと、LTC3887のTG出力の立ち上がりエッジの間で決まります。PolyPhaseアレイを実現するために、複数のLTC3887を同期させることができます。

出力電圧検出

チャネル0の差動アンプによって、離れた場所にある負荷の電圧を $V_{SENSE0n}$ ピンによって差動検出できます。チャネル1の検出ピン (V_{SENSE1}) は、GNDを基準にしています。テレメトリADCは完全差動であり、 $V_{SENSE0n}$ ピンでチャネル1の出力電圧を測定し、 V_{SENSE1} /GNDピンでチャネル1の出力電圧を測定します。最大許容検出電圧は5.5Vです。

電流検出

DCR電流検出アプリケーションでは、インダクタの両端にコンデンサと直列に抵抗を接続します。この構成では、図3に示すように、抵抗をインダクタのFET側に、コンデンサをインダクタの負荷側に接続します。RC時定数がインダクタの時定数(L/DCR。DCRはインダクタの直列抵抗)に等しくなるようにRC値を選択すると、その結果コンデンサの両端に生じる電圧がインダクタの直列抵抗に生じる電圧(VDCR)に等しくなり、インダクタを流れる電流を反映した値になります。RCは、インダクタの室温におけるDCRに基づいて計算します。

RC時定数は、温度の関数として一定値を保ちます。これによっ て、回路のトランジェント応答も温度に関わらず一定になりま す。インダクタのDCRは、約3900ppm/°Cという大きな温度係 数を持っています。このインダクタの温度係数をMFR_IOUT_ CAL GAIN TCレジスタに書き込む必要があります。外部 温度は、インダクタの近くで検出され、温度に対して実質的 に一定の電流制限値が得られるように内部の電流制限回路 を変更するために使用されます。このアプリケーションでは、 Isensen+ピンをコンデンサの電力段側、Isensen-ピンをコンデ ンサの負荷側に接続します。この場合、入力で検出される電 流は式V_{DCR}/DCRで与えられます。V_{DCR}はLTC3887のテレ メトリADCによってデジタル化されます。このADCは、入力 範囲が±128mV、ノイズ・フロアが7μV_{RMS}、ピーク・トゥ・ピー ク・ノイズが約46.5µVです。LTC3887は、IOUT CAL GAIN コマンドに格納されたDCR値と、MFR IOUT CAL GAIN TCコマンドに格納された温度係数に基づいて、インダクタ電 流を計算します。計算で得られた電流値は、READ_IOUTコ マンドによって返されます。



PolyPhase 負荷シェアリング

複数のLTC3887をアレイ配置し、必要なピンをバス接続することで、バランスの取れた負荷シェアリング・ソリューションを構成できます。図3に負荷シェアリングに必要な、共有接続の方法を示します。

外部発振器が提供されない場合、いずれか1つのLTC3887 のみでSYNC出力をイネーブルする必要があります。その他の LTC3887は、MFR_CONFIG_ALL_LTC3887のビット4を使 用して、SYNC出力をディスエーブルするように設定します。両 方のデバイスで、発振器を目的のPWM周波数に設定します。 外部発振器が存在する場合、SYNC出力がイネーブルされて いるデバイスは、外部クロックの存在を検出し、SYNC出力の 駆動を停止します。

MFR_PWM_CONFIG_LTC3887のビット7をアサートすることによって、同じデバイス上の2つのPWMコントローラのエラーアンプを共有できます。アプリケーションで両方のVouTピンが相互に接続され、かつ両方のITHピンが相互に接続されていない場合、このビットをアサートしないでください。これによって、PolyPhaseレールのリモート差動電圧検出が可能になります。

外部/内部温度検出

外部温度は、ダイオード接続したPNPトランジスタ (MMBT3906など)をチップから離れた場所に配置することで、最も的確に測定できます。PNPトランジスタのエミッタ端子はTSNSnピンに接続しますが、ベース端子とコレクタ端子はLTC3887のGNDピンに直接接続して戻す必要があります。インダクタ温度を正確に測定するために、PNPトランジスタをインダクタに近づけて配置します。ノイズ耐性を最大限に高めるには、これらの接続を差動配線し、ダイオード接続したPNPトランジスタと並列に10nFのコンデンサを配置してください。ダイオードに、2つの異なる電流(公称2 μ Aと32 μ A)を印加し、 Δ VBEの測定から温度を計算します。外付けトランジスタの温度はテレメトリADCによってデジタル化され、PMBusコマンドのREAD_TEMPERATURE 1(Chn)によって返されます。

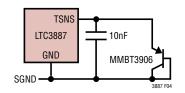


図4. 温度検出回路

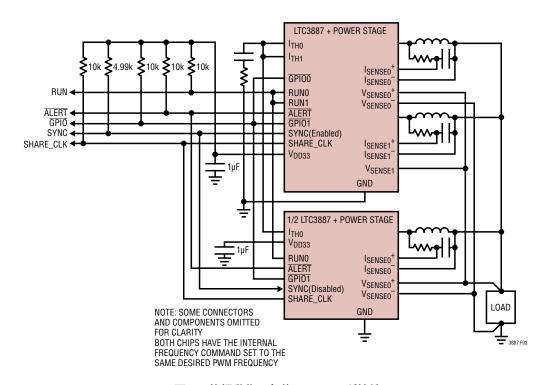


図3.3位相動作の負荷シェアリング接続



READ_TEMPERATURE_2コマンドは、内蔵ダイオードによってLTC3887の接合部温度を返します。外付け温度センサの温度勾配は、MFR_TEMP_1_GAINに格納された温度勾配係数によって変更できます。一般的なPNPトランジスタでは、1より若干小さい温度勾配の調整が必要です。MMBT3906におけるこのコマンド(MFR_TEMP_1_GAIN)の推奨値は、理想性係数が1.01であることから、およそ0.991になります。MFR_TEMP_1_GAINの値は、単純に理想係数の逆数から計算できます。理想性係数は、メーカーごと、ロットごとに異なる場合があります。この値を設定する際は、メーカーに問い合わせてください。

外付け温度センサのオフセットは、MFR_TEMP_1_OFFSET によって調整できます。このレジスタの値を0にすると、温度オフセットは-273.15°Cに設定されます。

PNPトランジスタをインダクタに直付けできない場合、温度の不一致を考慮して勾配またはオフセットを増加させることができます。ユーザーが勾配を調整する場合、グラフの切片が絶対零度の-273.15°Cであるため、勾配をわずかに変更しただけでも、見かけの温度測定値が大きく変化する可能性があります。温度の項の勾配を人為的に増加させるもう1つの手段として、MFR_IOUT_CAL_GAIN_TCの値を大きくする方法があります。これは、室温を中心に温度勾配を変化させます。

RCONFIG (抵抗構成設定)ピン

VDD25とGNDの間には、重要な動作パラメータを選択するために1%の抵抗分割器を使用する6つの入力ピンがあります。それらのピンは、ASEL0、ASEL1、FREQ_CFG、VOUT0_CFG、VOUT1_CFG、およびPHAS_CFGです。これらのピンをフロート状態にした場合は、対応するEEPROMコマンドに格納された値が使われます。EEPROM内のMFR_CONFIG_ALL_LTC3887構成コマンドのビット6がアサートされると、電源投入時に抵抗入力は無視されます。ただし、ASEL0およびASEL1の値だけは例外であり、常に採用されます。抵抗構成設定ピンが測定されるのは、電源投入リセット時か、MFR_RESETコマンドまたはRESTORE_USER_ALLコマンドの実行後だけです。

VOUTn_CFGピンの設定は、表12に記載されています。これらのピンは、LTC3887のアナログPWMコントローラの出力電圧を選択します。ピンがオープン状態の場合、EEPROMからVOUT_COMMANDコマンドが読み込まれ、出力電圧が決まります。出荷時のEEPROMのデフォルト設定では、電圧構成ピンを実装していない場合、スイッチャがオフになっています。

ユーザーは、EEPROMをアプリケーションの目的の設定にプログラムし直すことができます。EEPROM構成を読み込む場合は、MFR_CONFIG_ALL_LTC3887のビット6をアサートし、以降の全てのリセット動作に対して抵抗構成設定ピンをディスエーブルすることを推奨します。

RCONFIGピンを出力電圧の決定に使用する場合は、以下のパラメータは出力電圧に対する比率(パーセント)として設定されます。

■ VOUT_OV_FAULT_LIMIT	+10%
■ VOUT_OV_WARN	+7.5%
■ VOUT_MAX	+7.5%
■ VOUT_MARGIN_HIGH	+5%
■ VOUT_MARGIN_LOW	5%
■ VOUT_UV_WARN	6.5%
■ VOUT IIV FAULT LIMIT	_7%

FREO CFGピンの設定は、表14に記載されています。この ピンは、スイッチング周波数を選択します。2つのチャネル とSYNCピンの間の位相関係は、表13で説明されている PHAS CFGピンによって決定されます。外部クロックに同期 するには、デバイスを外部クロック・モードに移行させる必要 があります(SYNC出力をディスエーブルするが周波数を公 称値に設定)。外部クロックを供給しない場合、デバイスは 設定された周波数で駆動されます。アプリケーションがマル チフェーズで、デバイス間のSYNC信号が失われた場合、各 デバイスは同じ周波数にならず、出力でリップル電圧が増加 し、望ましくない動作が生じる可能性があります。SYNC信号 が内部で生成されており、イネーブルされたSYNC出力が選 択されていない場合、MFR PADS LTC3887のビット10がア サートされます。周波数が選択されておらず、外部SYNC周 波数が存在しない場合、PLL FAULTが発生します。パワー アップ時に有効な同期信号が存在しない場合でも、PLL_ FAULTによる ALERT を出力したくない場合は、PLL FAULT のALERTマスクを書き込む必要があります。詳細については、 SMBALERT_MASKの説明を参照してください。複数のデバ イス間でSYNCピンを接続する場合、その中の1つデバイス のみのSYNC出力をイネーブルし、残りのデバイスのSYNC 出力を全てディスエーブルするように構成してください。

ASEL0ピンおよびASEL1ピンの設定は、表15に記載されています。ASLE1ピンはLTC3887のスレーブ・アドレスの上位3ビットを選択します。ASEL1がフロート状態の場合、上位3ビットは、EEPROMのMFR_ADDRESSコマンドから取得します。ASEL0はLTC3887のスレーブ・アドレスの下位4ビットを選択します。ASEL0がフロート状態の場合、EEPROMのMFR_



ADDRESSコマンドに格納された下位4ビットは、スレーブ・アドレスの下位4ビットの決定に使用されます。詳細は表15を参照してください。

注記:PMBusの仕様に基づき、ピンによってプログラムされたパラメータよりもデジタル・インタフェースからのコマンドの方が優先されます。ただし、ASELOおよびASEL1だけは例外であり常にピン設定が優先されます。0x0C、0x5A、0x5B、または0x7Cのアドレスはいずれのデバイスにも割り当てないでください。これらはグローバル・アドレスであり、全てのLTC PMBus デバイスが応答する場合があります。

フォルトの検出と処理

各種のフォルトおよび警告を報告または処理する機能を搭載しています。フォルトおよび警告の検出機能には、次のようなものがあります。

- 入力OV(過電圧)/フォルト保護およびUV(低電圧)警告
- 平均入力OC(過電流)警告
- 出力OV/UVフォルトおよび警告保護
- 出力OCフォルトおよび警告保護
- 内部および外部 OT (過熱)フォルトおよび警告保護
- 外部 UT(低温)フォルト保護
- CML(通信、メモリ、ロジック)フォルト
- 双方向 GPIOn ピンを介した外部フォルト検出

さらに、LTC3887ではフォルト・インジケータの任意の組み 合わせを各GPIOnピンに割り当てることができます。それに は、GPIOn 応答伝播コマンドのMFR_GPIO_PROPAGATE_ LTC3887を使用します。GPIOピンの代表的な用途として、外 部クローバー・デバイス、過熱アラート、過電圧アラートのドラ イバや、マイクロコントローラにフォルト・コマンドのポーリング を促す割り込み要因などがあります。あるいは、コントローラ の下流で発生し、直ちに応答する必要がある外部フォルトを 検出するための入力として GPIOn ピンを使用できます。 GPIOO ピンまたはGPIO1ピン(あるいは、その両方)を、パワーグッド 出力として構成することもできます。パワーグッドは、コントロー ラの出力がOV/UVフォルトしきい値の範囲内にあることを示 します。電源投入時の初期状態では、このピンはトライステー トです。この構成で電源投入時にピンに所望の極性を設定 する必要がある場合は、伝播されるパワーグッド信号のRUN ピンとGPIOピンの間にショットキ・ダイオードを接続します。

カソードをRUNピンに、アノードをGPIOピンに接続してください。GPIOピンをパワーグッド・ステータスに設定する場合、MFR_GPIO_RESPONSEを無視する必要があります。このように設定しないと、ラッチ・オフ状態になる場合があります。

ソフトスタートのセクションで述べたとおり、イベントの組み合わせによって起動を制御できます。 GPIOn によって他のコントローラのRUNピンを駆動する場合、フィルタされていない VOUT_UVフォルト・リミットを GPIO ピンにマッピングしてください。

いずれかのフォルト・イベントまたは警告イベントが発生する と、SMBALERT MASKコマンドによってALERTがマスクさ れていなければ、ALERTピンが"L"にアサートされます。この ピンは、CLEAR FAULTSコマンドが発行されるか、フォルト・ ビットに1が書き込まれるか、PMBusマスタが正常にデバイス のARAレジスタを読み出すか、バイアス電源がオフになって 再びオンになるか、MFR RESETコマンドまたはRESTORE USER ALLコマンドが発行されるまで"L"にアサートされた ままになります。RUNピンがオフになって再びオンになるか、 PMBusによってデバイスがオフ/オンするように指示されると、 チャネル固有のフォルトがクリアされます。MFR CONFIG ALL LTC3887のビット0が1に設定された場合、RUNピン がオフになって再びオンになるか、PMBusによってデバイスが オフ/オンするように指示されると、全てのフォルトがクリアさ れます。フォルトが検出された場合にGPIOピンが"L"に引き 下げられるかどうかは、MFR GPIO PROPAGATE LTC3887 コマンドによって決まります。ただし、ALERTピンは、フォルト または警告が検出されてステータス・ビットが更新されると、 SMBALERT MASK コマンドによって ALERT ピンがマスクさ れていなければ、必ず"L"に引き下げられます。

出力および入力のフォルト・イベント処理は、表5~9に記載された、対応するフォルト応答バイトによって制御されます。これらの各種フォルトからのシャットダウン回復は、自律的なものとラッチされるものがあります。自律的な回復の場合、フォルトはラッチされないため、リトライ・インターバル時間の経過後にフォルト状態が解消されていれば、新たにソフトスタートが試みられます。フォルト状態が解消されていない場合、コントローラはリトライを繰り返します。リトライ・インターバルはMFR_RETRY_DELAYコマンドによって指定し、電源サイクルが繰り返されることによるデバイスの損傷を防ぎます。MFR_RETRY_DELAYは120msより大きくなければなりませんが、83.88秒を超えることはできません。



チャネル間のフォルト依存関係を構築できるようにするには、 GPIOn ピンを相互に接続します。内部フォルトが発生すると、 1つ以上のチャネルが、バス接続された GPIOn ピンを"L"に引 き下げるように構成されます。それ以外のチャネルは、GPIOn ピンが"L"に引き下げられるとシャットダウンするように構成 されます。自律的グループの再試行では、再試行間隔の経過 後、フォルト発生チャネルがGPIOnピンを解放するよう構成 され、当初のフォルトは解消されたものとみなします。その後、 グループ内の全てのチャネルがソフトスタート・シーケンスを 開始します。フォルト応答がLATCH OFFの場合、RUNピン のオフ/オン・トグル、デバイスへのオフ/オン指示のいずれか が実行されるまで、GPIOピンは"L"にアサートされたままにな ります。ピンまたはオフ/オン指示のいずれかによってRUNを トグルすると、チャネル関連のフォルトはクリアされます。いず れかのRUNピンがトグルされた場合に、全てのフォルトをクリ アする必要がある場合は、MFR CONFIG ALL LTC3887の ビット0を1に設定します。

全てのフォルトおよび警告のステータスは、STATUS_WORD および STATUS_BYTE コマンド内にまとめて表示されます。

フォルトの検出および処理には、他にも次のような機能があります。

CRC保護

EEPROMメモリの完全性をパワーオン・リセット後に確認できます。CRCエラーは、コントローラがオフ状態から脱することを妨げます。CRCエラーが発生した場合、STATUS_BYTEおよびSTATUS_WORDコマンド内のCMLビットがセットされます。さらに、STATUS_MFR_SPECIFICコマンド内の該当するビットがセットされ、ALERTピンが"L"に引き下げられます。EEPROMの修復は、必要な構成をコントローラに書き込み、STORE_USER_ALLコマンドに続いてCLEAR_FAULTSコマンドを実行することで可能です。

LTC3887のEEPROMの製造時セクションには、ミラー・コピーがあります。LTC3887は、EEPROM構成の2つの製造時セクションのいずれか一方が破壊されている場合にも動作できます。2つのセクション間に相違が検出されると、STATUS_MFR_SPECIFICコマンド内に、「NVM CRCフォルト」が設定されます。CLEAR_FAULTSを発行してクリアするか、1を書き込んだ後も、このビットがセットされたままの場合は、修復できない内部フォルトの発生を意味します。製造時セクションの修復不能EEPROMフォルトを、ユーザーの手元で修復する方法はありません。

シリアル・インタフェース

LTC3887のシリアル・インタフェースはPMBus準拠のスレーブ・デバイスであり、10kHz~400kHzの間の任意の周波数による動作が可能です。アドレスは、EEPROMまたは外付けの抵抗分割器によって構成できます。さらに、LTC3887はグローバル・ブロードキャスト・アドレスである0x5A(7ビット)または0x5B(7ビット)には必ず応答します。アドレス0x5Aはページ指定されず、両方のチャネルに対して実行されます。0x5Bはページ・コマンドに従います。アドレス0x5Aは、ページに対応していないため、ページ指定読み出しコマンドには使用できません。

シリアル・インタフェースは、PMBus 仕様に規定された、以下のプロトコルをサポートします。1)コマンド送信、2)バイト書き込み、3)ワード書き込み、4)グループ、5)バイト読み出し、6)ワード読み出し、7)ブロック読み出し、8) PAGE_PLUS_READ、9) PAGE_PLUS_WRITE、10) SMBALERT_MASK 読み出し、11) SMBALERT_MASK 書き込み全ての読み出し動作は、PMBusマスタが要求している場合、有効なPECを返します。MFR_CONFIG_ALL_LTC3887コマンド内のPEC_REQUIREDビットがセットされている場合、LTC3887が有効なPECを受信するまで、PMBus書き込み動作は処理されません。

通信保護

PEC書き込みエラー(PEC_REQUIREDがアクティブな場合)、サポート外のコマンドへのアクセス試行、サポート対象のコマンドへの無効データ書き込みは、いずれもCMLフォルトを発生させます。STATUS_BYTEおよびSTATUS_WORDコマンド内のCMLビットがセットされます。さらに、STATUS_CMLコマンド内の該当するビットがセットされ、ALERTピンが"L"に引き下げられます。

デバイス・アドレス指定

LTC3887のPMBusインタフェースを介したアドレス指定には、次の4種類が用意されています。1) グローバル、2) デバイス、3) レールによるアドレス指定および4) アラート応答アドレス(ARA)。

グローバル・アドレス指定は、バス上の全てのLTC3887デバイスのアドレスを指定するための手段をPMBusマスタに提供します。LTC3887のグローバル・アドレスは、固定された0x5A(7ビット)または0xB4(8ビット)であり、ディスエーブルすることはできません。グローバル・アドレスに送信されたコマンドは、PAGEが0xFFの値に設定された場合と同様に機能します。送信されたコマンドは、両方のチャネルに同時に書き込まれます。



グローバル・コマンド 0x5B (7ビット)または0xB6 (8ビット)は、ページ指定され、バス上の全てのLTC3887 デバイスのチャネル固有のコマンドを可能にします。他のLTC デバイス・タイプは、これらのグローバル・アドレスの1つまたは両方で応答する可能性があります。そのため、グローバル・アドレスからは読み出さないでください。

レール・アドレス指定は、単一の出力電圧(PolyPhase)を生成するために相互に接続している全てのチャネルとバス・マスタが同時に通信する方法を提供します。グローバル・アドレス指定と同様ですが、レール・アドレスには、ページ設定されたMFR_RAIL_ADDRESSコマンドを動的に割り当てることができるので、信頼できるシステム制御で要求される場合があるチャネルの論理的グループ分けに対応します。複数のLTCデバイスが応答する可能性があるため、レール・アドレスからは読み出さないでください。

デバイス・アドレス指定は、PMBusマスタがLTC3887の1つのインスタンスと通信するときの標準的な手段です。デバイス・アドレスの値は、ASEL0およびASEL1構成ピンと、MFR_ADDRESSコマンドの組み合わせによって設定します。このアドレス指定方法を使用すると、PAGEコマンドによって動作中のチャネルを決定できます。デバイス・アドレス指定は、MFR_ADDRESSに値0x80を書き込むことでディスエーブルできます。

以上の4つのPMBusアドレス指定方法は、いずれもユーザーによる整然とした計画に基づいて適用し、アドレスの競合を防ぐ必要があります。グローバル・アドレスおよびレール・アドレスでのLTC3887デバイスへの通信は、コマンド書き込み動作に限定してください。

VoutおよびIoutフォルトに対する応答

V_{OUT}のOVおよびUV状態は、コンパレータによってモニタされます。OVとUVのリミット値は、次の3つの方法で設定できます。

- 抵抗構成設定ピンを使用している場合はV_{OUT}に対する パーセンテージ
- 工場出荷時またはGUIのいずれかによってプログラムされている場合はEEPROM内の値
- PMBus コマンドによる指定

I_{IN}とI_{OUT}の過電流モニタには、ADCの読み出しと計算を使用します。これらの値は平均電流に基づいているため、最大120msのレイテンシが必要になる場合があります。I_{OUT}の計算には、検出抵抗と抵抗の温度係数が加味されます。入力電流は、出力電流に各チャネルのデューティ・サイクルを掛け、

各チャネルの入力オフセット電流を足した値になります。この 入力電流の計算値がIN_OC_WARN_LIMITを超えた場合、 ALERT ピンが"L"に引き下げられ、STATUS_INPUTレジスタのIIN_OC_WARNビットがアサートされます。

LTC3887には、フォルトを無視する機能、デバイスをシャットダウンしてラッチ・オフする機能、デバイスをシャットダウンして無期限でリトライを繰り返す機能(ヒカップ)があります。リトライ・インターバルは、MFR_RETRY_DELAYによって、120ms~83.88秒の範囲で1ms刻みの設定が可能です。OV/UVおよびOCによるシャットダウンは、フォルト発生後直ちに実行するか、ユーザーが選択するデグリッチ時間の経過後に実行することができます。

出力過電圧フォルトに対する応答

プログラム可能な過電圧(OV)コンパレータは、出力の過渡的なオーバーシュートと長時間の過電圧からデバイスを保護します。これらの状態が発生した場合、PMBusコマンドのVOUT_OV_FAULT_RESPONSEのバイト値に関わらず、過電圧状態が解消されるまで上側MOSFETがオフし、下側MOSFETがオンします。このハードウェア・レベルのフォルト応答の遅延、つまり過電圧状態の発生からBGが"H"にアサートされるまでの標準的な遅延時間は2μsです。ユーザーはVOUT_OV_FAULT_RESPONSEコマンドによって、次のいずれかの動作を選択できます。

- OVのプルダウンのみ(OVは無視できません)
- 即時シャットダウン(スイッチング停止) ― ラッチ・オフ
- 即時シャットダウン MFR_RETRY_DELAY で指定した インターバルで無期限のリトライ

ラッチ・オフまたはリトライのいずれのフォルト応答も、(0~7)・10μs刻みでデグリッチできます。表5を参照してください。

出力低電圧フォルトに対する応答

低電圧(UV)コンパレータ出力に対しては、次のいずれかの応答が可能です。

- 無視
- 即時シャットダウン ― ラッチ・オフ
- 即時シャットダウン MFR_RETRY_DELAY で指定した インターバルで無期限のリトライ

ラッチ・オフまたはリトライのいずれのフォルト応答も、(0~7)・10μs刻みでデグリッチできます。表6を参照してください。



3887f

ピーク出力過電流フォルトに対する応答

電流モードの制御アルゴリズムを使用しているため、インダクタのピーク出力電流は、サイクルごとに常に制限されています。ピーク電流のリミット値は、電気的特性の表の検出電圧に規定されています。電流制限回路は、ITHの最大電圧を制限することで動作します。DCR検出を使用している場合、ITHの最大電圧は、インダクタDCRの温度係数に直接比例する温度依存性を持ちます。LTC3887は、外付けの温度センサを自動的にモニタし、この項を補償するためにITHの最大許容値を変更します。

過電流フォルト処理回路では、次のいずれかの動作を実行できます。

- 無期限の電流制限
- 即時シャットダウン ― ラッチ・オフ
- 即時シャットダウン MFR_RETRY_DELAY で指定した インターバルで無期限のリトライ

過電流フォルトに対する応答は、(0~7)・16ms刻みでデグリッチできます。表7を参照してください。

タイミング・フォルトに対する応答

TON_MAX_FAULT_LIMIT は、起動時にV_{OUT}が立ち上がり、安定するまでに許される時間です。TON_MAX_FAULT_LIMITの条件は、出力がSOFT_STARTシーケンスを実行している間の、VOUT_UV_FAULT_LIMITの検出に基づいて判断されます。TON_MAX_FAULT_LIMITの時間は、TON_DELAYが経過し、SOFT_STARTシーケンスが開始された時点を起点とします。TON_MAX_FAULT_LIMITの分解能は10µsです。TON_MAX_FAULT_LIMITの時間内にVOUT_UV_FAULT_LIMITに到達しなかった場合、このフォルトに対する応答がTON_MAX_FAULT_RESPONSEコマンドの値によって決まります。次のいずれかの応答が可能です。

- 無視
- 即時シャットダウン(スイッチング停止) ― ラッチ・オフ
- 即時シャットダウン MFR_RETRY_DELAY で指定した インターバルで無期限のリトライ

このフォルトに対する応答は、デグリッチされません。TON_MAX_FAULT_LIMITの値を0に設定することは、このフォルトの無視を意味します。TON_MAX_FAULT_LIMITは、TON_RISEの時間よりも長くしてください。TON_MAX_

FAULT_LIMITには、常に0以外の値を設定することを推奨します。0を設定すると出力がまったく立ち上がらず、ユーザーに対するフラグも一切セットされない恐れがあります。

表9を参照してください。

VINのOVフォルトに対する応答

 $V_{\rm IN}$ の過電圧状態は、A/Dコンバータによって測定されます。 したがって、その応答はA/Dコンバータの標準応答時間である 100ms によって自然にデグリッチされます。フォルトには、次の応答が可能です。

- 無視
- 即時シャットダウン ラッチ・オフ
- 即時シャットダウン MFR_RETRY_DELAY で指定した インターバルで無期限のリトライ

表9を参照してください。

OT/UTフォルトに対する応答

内部過熱フォルト/警告応答

内部温度センサは、EEPROMを損傷から保護します。85°C を超える温度におけるEEPROMへの書き込みは推奨できません。130°Cを上回ると、内部過熱警告しきい値を超えて、デバイスがEEPROMの書き込みをディスエーブルし、温度が125°Cに低下するまで再びイネーブルしません。ダイ温度が160°Cを超えると、温度が150°C未満に低下するまで内部過熱フォルト応答がイネーブルされ、PWMがディスエーブルされます。温度は、A/Dコンバータによって測定されます。内部温度フォルトは無視できません。ユーザーは内部温度のリミット値を変更できません。

表8を参照してください。

外部過熱および低温フォルト応答

2つの外付け温度センサによって、インダクタやパワー MOSFET などの重要な回路素子の温度を検出できます。OT_FAULT_RESPONSEコマンドとUT_FAULT_RESPOSEコマンドは、過熱状態と低温状態への適切な応答を決定するためにそれぞれ使用されます。外付けのセンサ素子を使用しない場合(推奨しません)は、UT_FAULT_RESPONSEを「無視」に設定し、UT_FAULT_LIMITを-275°Cに設定し、MFR_IOUT_CAL_GAIN_TCを0に設定します。

388/1



フォルトには、次の応答が可能です。

- 無視
- 即時シャットダウン ― ラッチ・オフ
- 即時シャットダウン MFR_RETRY_DELAY で指定した インターバルで無期限のリトライ

表9を参照してください。

外部フォルトに対する応答

GPIOnピンのいずれかが"L"に引き下げられると、STATUS_WORDコマンド内のOTHERビットがセットされます。さらに、STATUS_MFR_SPECIFCコマンド内の該当するビットがセットされ、ALERTピンが"L"に引き下げられます。応答はデグリッチされません。各チャネルは、MFR_GPIO_RESPONSEコマンドを変更することで、GPIOnピンの"L"遷移に対して、無視またはシャットダウン後のリトライのいずれかで応答するように構成できます。GPIOが"L"に引き下げられたときにALERTピンが"L"にアサートされるのを防ぐには、MFR_CHAN_CONFIG_LTC3887のビット1をアサートするか、SMBALERT_MASKコマンドを使用してALERTをマスクします。

フォルト・ログ

LTC3887にはフォルト・ログ記録の機能があります。データは表11に示す順序でメモリに記録されます。フォルト・ログに保存されるデータは、内部揮発性メモリに保存され続けています。フォルト・イベントが発生すると、内部揮発性メモリへの記録が停止し、フォルト・ログ情報をMFR_FAULT_LOGコマンドから入手できるようになり、内部メモリの内容がEEPROMにコピーされます。フォルト・ログ機能は85°Cを超える温度でも使用できますが、10年の保持特性は保証されません。ダイ温度が130°Cを超えると、温度が125°C未満に低下するまでフォルト・ログ記録が遅延します。フォルト・ログ・イベントを発生させたフォルト状態が解消されると、フォルトがクリアされてから、フォルト・ログ・データが消去されます。フォルト状態が解消されない場合、デバイスは即座に別のフォルト・ログを発行します。

LTC3887は、電源投入時に有効なフォルト・ログがないか、EEPROM内を確認します。EEPROM内に有効なフォルト・ログが存在した場合、STATUS_MFR_SPECIFICコマンドの「有効なフォルト・ログ」ビットがセットされ、ALERTイベントが生成されます。また、LTC3887がMFR_FAULT_LOG_CLEARコマンドを受信するまでフォルト・ログはブロックされ、このコマンドの受信後に再度イネーブルされます。

いずれかのチャネルのコントローラを無効化するいかなるフォルトが発生した場合も、情報はEEPROMに格納されます。外部でGPIOnが"L"に引き下げられることによって、フォルト・ログ記録イベントはトリガされません。

バス・タイムアウト保護

シリアル・インタフェースのハングアップを防ぐために、LTC3887にはタイムアウト機能が実装されています。データ・パケット・タイマはデバイス・アドレス書き込みバイトの前の最初のSTARTイベントによって起動されます。データ・パケット情報は25ms以内に完了する必要があります。この時間を超過した場合、LTC3887はバスをトライステート状態に遷移させ、そのデータ・パケットを無視します。さらに多くの時間が必要な場合は、MFR_CONFIG_ALL_LTC3887のビット3をアサートして、255msの標準のバス・タイムアウトを許容します。データ・パケットの情報には、デバイス・アドレス・バイト書き込み、コマンド・バイト、反復スタート・イベント(読み出し動作の場合)、デバイス・アドレス・バイト読み出し(読み出し動作の場合)、全てのデータ・バイト、および該当する場合はPECバイトが含まれます。

LTC3887は、データ・パケットのブロック読み出しに対して、より長いPMBus タイムアウトを許容します。このタイムアウト時間は、ブロック読み出しの長さに比例します。ブロック読み出しのタイムアウト延長は、主にMFR_FAULT_LOGコマンドに適用されます。どのような状況でも、タイムアウト期間がtTIMEOUT_SMBの32ms(標準)の規定値より短くなることはありません。

シリアル・バス・インタフェースを共有する全てのデバイス間の 効率的なデータ・パケット伝送を維持するために、できるだけ 速いクロック・レートを使用することを推奨します。LTC3887 は、PMBusの周波数範囲である10kHz~400kHzの全域をサポートしています。

PMBus、SMBus、I2C 2線インタフェース間の類似性

PMBus 2線インタフェースはSMBusの拡張版です。SMBusは、I²Cを基盤として構築され、両者の間にはタイミング、DCパラメータ、プロトコルにいくつかのわずかな差異が存在します。PMBus/SMBusプロトコルは、バス・エラーを防ぐタイムアウトと、データの完全性を保証するオプションのパケット・エラー・チェック(PEC)を備えているので、シンプルなI²Cのバイト・コマンドよりも堅牢です。通常、I²C通信用に構成できるマスタ・デバイスは、ハードウェアまたはファームウェアにわずかな変更を加えるか、まったく変更なしにPMBusにも適用できます。



反復スタート(リスタート)は、全てのI²Cコントローラでサポートされているわけではありませんが、SMBus/PMBusの読み出しには必要です。汎用I²Cコントローラを使用する場合は、反復スタートをサポートしているか確認してください。

PMBusで適用されたSMBusに対する軽微な拡張や例外については、『PMBus Specification Part 1 Revision 1.2』の第5節「Transport」を参照してください。

SMBus と I²Cの相違点については、『System Management Bus (SMBus) Specification Version 2.0』の付録 B「Differences Between SMBus and I²C」を参照してください。

PMBus シリアル・デジタル・インタフェース

LTC3887は、標準PMBusシリアル・バス・インタフェースを使用してホスト(マスタ)と通信します。バス信号のタイミング関係をタイミング図(図5)に示します。バスを使用しない場合、2本のバスライン(SDAとSCL)は"H"にする必要があります。これらのラインには外付けのプルアップ抵抗または電流源が必要です。

LTC3887はスレーブ・デバイスです。マスタは以下の形式でLTC3887と通信できます。

- マスタ・トランスミッタ、スレーブ・レシーバ
- マスタ・レシーバ、スレーブ・トランスミッタ

以下のPMBusプロトコルがサポートされています。

- バイト書き込み、ワード書き込み、バイト送信、ブロック書 き込み
- バイト読み出し、ワード読み出し、ブロック読み出し
- アラート応答アドレス

前述のSMBusプロトコルを図7~23に示します。全てのトランザクションがPEC(パリティ・エラー・チェック)とGCP(グループ・コマンド・プロトコル)に対応しています。ブロック読み出しは、戻り値のデータとして255バイトをサポートします。このため、フォルト・ログを読み出す場合にPMBusタイムアウトを延長できます。

図6は、このセクションに示すプロトコル図の凡例です。PEC はオプションです。

以下の図のフィールド下に示された値は、そのフィールドに対 する必須値です。

PMBusによって実装されるデータ形式は次のとおりです。

- マスタ・トランスミッタがスレーブ・レシーバに送信する。この場合、伝送方向は変化しません。
- 最初のバイトの直後にマスタがスレーブを読み出す。最初のアクノリッジ(スレーブ・レシーバによる)の時点で、マスタ・トランスミッタはマスタ・レシーバになり、スレーブ・レシーバがスレーブ・トランスミッタになります。
- 組み合わせ形式伝送中に方向が変化する時点で、マスタ はスタート条件とスレーブ・アドレスの両方を反復します が、その際R/Wビットを反転させます。その場合、マスタ・ レシーバは伝送の最後のバイトとストップ条件に対して NACKを生成して伝送を中止します。

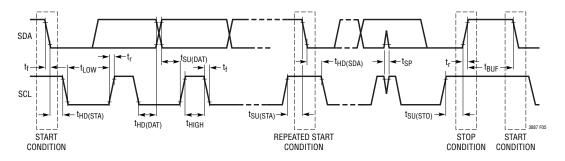


図5. タイミング図

LINEAR

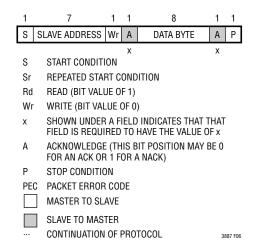


図6、PMBusパケット・プロトコル図の凡例



図7.クイック・コマンド・プロトコル

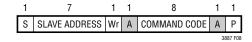


図8. バイト送信プロトコル

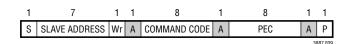


図9. PEC付きバイト送信プロトコル



図10. バイト書き込みプロトコル

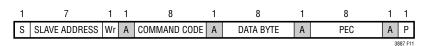
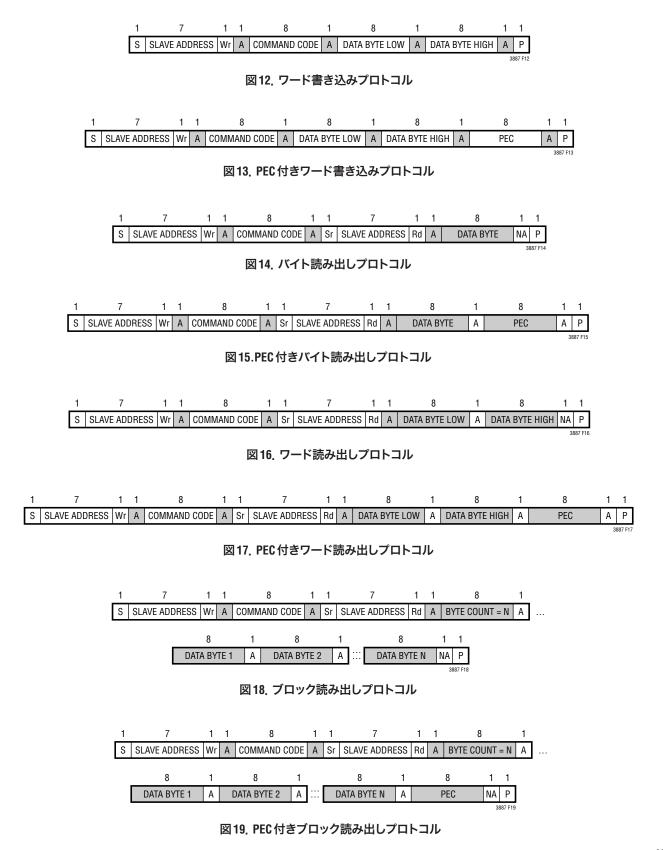


図11. PEC付きバイト書き込みプロトコル





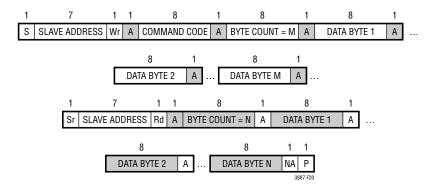


図20. ブロック書き込み - ブロック読み出しプロセス呼び出し

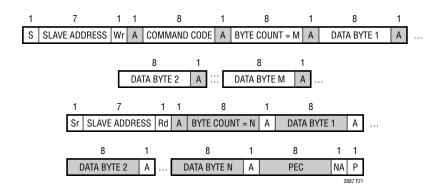


図21. ブロック書き込み - PEC付きブロック読み出しプロセス呼び出し

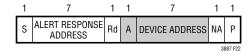


図22.アラート応答アドレス・プロトコル



図23. PEC付きアラート応答アドレス・プロトコル

表1.データ形式の用語

PMBus用語	意味	仕様、GUI、アプリケーション・ ノートの用語	コマンドの概要一覧表の略語	データ形式詳細の 参照先ページ(表2)
Linear	リニア	Linear_5s_11s	L11	p. 38
Linear(電圧関連コマンド用)	リニア	Linear_16u	L16	p. 38
Direct	メーカーによる 直接カスタマイズ	DirectMfr	CF	p. 38
Hex		Hex	l16	
ASCII		ASCII	ASC	
	レジスタ・フィールド	Reg	Reg	

堅牢なシステム通信を保証するためにハンドシェイク機能を備えています。詳細は、「アプリケーション情報」の「PMBusの通信とコマンド処理」の項を参照してください。

PMBus コマンド

以下の表は、サポートされるPMBusコマンドとメーカー固有コマンドの一覧です。これらのコマンドの詳細な説明は、『PMBus Power System Mgt Protocol Specification – Part II – Revision 1.2』に記載されています。この仕様を参照することを推奨します。例外またはメーカー固有の実装については表2に掲載されています。表の「デフォルト値」に示した浮動小数点の値は、Linear 16 ビット符号付き (PMBus セクション 8.3.1)またはLinear_5s_11s (PMBus セクション 7.1)のいずれかのうち、そのコマンドに該当する形式を取ります。この表に記載されていない0xD0~0xFFのコマンドは、いずれもメーカーが暗黙のうちに予約済みとしているものです。デバイスの誤動作を避けるために、ユーザーは、この範囲のコマンドを不用意に書き込まないようにする必要があります。この表に記載されていない0x00~0xCFのコマンドは、いずれもメーカーが暗黙

のうちにサポート外としているものです。サポート外または予約済みコマンドにアクセスすると、CMLコマンド・フォルト・イベントが発生する可能性があります。出力電圧の設定および測定は、全てVOUT_MODEに対する0x14の設定に基づいています。これは、2⁻¹²の指数に相当します。

PMBusコマンドの受信に処理が追いつかなくなると、デバイスがビジー状態となり新たなコマンドを処理できなくなる場合があります。そのような状況になると、デバイスは「PMBus Specification v1.2, Part II, Section 10.8.7」に規定されたプロトコルに従い、ビジーであることを伝えます。デバイスは、堅牢な通信とシステム動作を確保すると同時に、ビジー・エラーをなくし、エラー処理ソフトウェアを簡素化する、ハンドシェイク機能を備えています。詳細は、「アプリケーション情報」の「PMBusの通信とコマンド処理」の項を参照してください。

表2.コマンド一覧(注記:データ形式の略語については、この表の最後で説明されています。NVMとEEPROMは同じです。)

コマンド名	CMD コード	説明	タイプ	ページ 指定	データ 形式	単位	NVM	デフォルト 値	ページ
PAGE	0x00	ページングをサポートしているコマンドの、 現在選択されているチャネルまたはページ。	R/W Byte	N	Reg			0x00	<u>63</u>
OPERATION	0x01	動作モードの制御。オン/オフ、マージン・ハイ およびマージン・ロー。	R/W Byte	Y	Reg		Y	0x40	<u>67</u>
ON_OFF_CONFIG	0x02	RUNピンおよびPMBusのオン/オフ・コマンドの構成。	R/W Byte	Υ	Reg		Υ	0x1E	<u>66</u>
CLEAR_FAULTS	0x03	セットされている全フォルト・ビットをクリア。	Send Byte	N				NA	90
PAGE_PLUS_WRITE	0x05	指定のページにコマンドを直接書き込む。	W Block	N					<u>63</u>
PAGE_PLUS_READ	0x06	指定のページからコマンドを直接読み取る。	Block R/W	N					<u>64</u>
WRITE_PROTECT	0x10	偶発的な変更に対してデバイスが提供する保護の レベル。	R/W Byte	N	Reg		Y	0x00	<u>64</u>
STORE_USER_ALL	0x15	ユーザー動作メモリを EEPROM に格納する。	Send Byte	N				NA	<u>101</u>
RESTORE_USER_ALL	0x16	ユーザー使用メモリをEEPROMからリストアする。	Send Byte	N				NA	<u>101</u>
CAPABILITY	0x19	デバイスがサポートする PMBus オプション通信 プロトコルの要約。	R Byte	N	Reg			0xB0	<u>89</u>
SMBALERT_MASK	0x1B	ALERT 動作をマスクする	Block R/W	Y	Reg			CMDを 参照	<u>91</u>
VOUT_MODE	0x20	出力電圧の形式および指数(2-12)。	R Byte	Y	Reg			2 ⁻¹² 0x14	<u>71</u>
VOUT_COMMAND	0x21	公称出力電圧の設定ポイント。	R/W Word	Υ	L16	V	Υ	1.0 0x 1000	<u>72</u>
VOUT_MAX	0x24	指示した出力電圧に対するVOUT_MARGIN_HIGHを含む上限。	R/W Word	Y	L16	V	Υ	5.6 0x 599A	<u>71</u>
VOUT_MARGIN_HIGH	0x25	マージン・ハイの出力電圧設定ポイント。VOUT_COMMANDよりも大きくなければならない。	R/W Word	Y	L16	V	Υ	1.05 0x10CD	<u>72</u>
VOUT_MARGIN_LOW	0x26	マージン・ローの出力電圧設定ポイント。VOUT_COMMANDよりも小さくなければならない。	R/W Word	Y	L16	V	Υ	0.95 0x0F33	<u>73</u>



300/1

コマンド名	CMD コード	説明	タイプ	ページ 指定	データ 形式	単位	NVM	デフォルト 値	ページ
VOUT_TRANSITION_ RATE	0X27	VOUTに新しい値を指定したときに出力が変化する 速度。	R/W Word	Y	L11	V/ms	Υ	0.25 AA00	<u>78</u>
FREQUENCY_SWITCH	0x33	コントローラのスイッチング周波数。	R/W Word	N	L11	kHz	Υ	350 0xFABC	<u>70</u>
VIN_ON	0x35	デバイスが電力変換を開始する入力電圧。	R/W Word	N	L11	V	Υ	6.5 0xCB40	<u>71</u>
VIN_OFF	0x36	デバイスが電力変換を停止する入力電圧。	R/W Word	N	L11	V	Υ	6.0 0xCB00	<u>71</u>
IOUT_CAL_GAIN	0x38	検出電流に対する電流検出ピンの電圧の比。 固定された電流検出抵抗を使用している デバイスの場合はmΩ単位の抵抗値となる。	R/W Word	Υ	L11	mΩ	Υ	1.8 0xBB9A	<u>74</u>
VOUT_OV_FAULT_LIMIT	0x40	出力過電圧フォルト・リミット。	R/W Word	Y	L16	V	Υ	1.1 0x119A	<u>72</u>
VOUT_OV_FAULT_ RESPONSE	0x41	出力過電圧フォルトが検出されたときのデバイスの 動作。	R/W Byte	Y	Reg		Υ	0xB8	<u>81</u>
VOUT_OV_WARN_LIMIT	0x42	出力の過電圧警告リミット。	R/W Word	Υ	L16	V	Υ	1.075 0x1133	<u>72</u>
VOUT_UV_WARN_LIMIT	0x43	出力の低電圧警告リミット。	R/W Word	Y	L16	V	Υ	0.925 0x0ECD	<u>73</u>
VOUT_UV_FAULT_LIMIT	0x44	出力低電圧フォルト・リミット。	R/W Word	Υ	L16	V	Υ	0.9 0x0E66	<u>73</u>
VOUT_UV_FAULT_ RESPONSE	0x45	出力低電圧フォルトが検出されたときのデバイスの 動作。	R/W Byte	Y	Reg		Υ	0xB8	<u>82</u>
IOUT_OC_FAULT_LIMIT	0x46	出力の過電流フォルト制限値。	R/W Word	Y	L11	А	Υ	29.75 0xDBB8	<u>75</u>
IOUT_OC_FAULT_ RESPONSE	0x47	出力過電流フォルトが検出されたときのデバイスの 動作。	R/W Byte	Y	Reg		Υ	0x00	<u>84</u>
IOUT_OC_WARN_LIMIT	0x4A	出力の過電流警告制限値。	R/W Word	Y	L11	А	Υ	20.0 0xDA80	<u>76</u>
OT_FAULT_LIMIT	0x4F	外部過熱フォルト制限値。	R/W Word	Y	L11	С	Υ	100.0 0xEB20	<u>77</u>
OT_FAULT_RESPONSE	0x50	外部過熱フォルトが検出されたとき、 デバイスが取るアクション。	R/W Byte	Y	Reg		Υ	0xB8	<u>86</u>
OT_WARN_LIMIT	0x51	外部過熱警告制限値。	R/W Word	Y	L11	С	Υ	85.0 0xEAA8	<u>77</u>
UT_FAULT_LIMIT	0x53	外部低温フォルト制限値。	R/W Word	Υ	L11	С	Υ	-40.0 0xE580	<u>77</u>
UT_FAULT_RESPONSE	0x54	外部低温フォルトが検出されたとき、 デバイスが取るアクション。	R/W Byte	Υ	Reg		Υ	0xB8	<u>86</u>
VIN_OV_FAULT_LIMIT	0x55	入力電源の過電圧フォルト・リミット。	R/W Word	N	L11	V	Υ	15.5 0xD3E0	<u>70</u>
VIN_OV_FAULT_ RESPONSE	0x56	入力の過電圧フォルトが検出されたときの デバイスの動作。	R/W Byte	Υ	Reg		Υ	0x80	<u>80</u>
VIN_UV_WARN_LIMIT	0x58	入力電源の低電圧警告リミット。	R/W Word	N	L11	V	Υ	6.3 0xCB26	<u>70</u>

コマンド名	CMD コード	説明	タイプ	ページ 指定	データ 形式	単位	NVM	デフォルト 値	ページ
IIN_OC_WARN_LIMIT	0x5D	入力電源の過電流警告リミット。	R/W Word	N	L11	А	Υ	10.0 0xD280	<u>74</u>
TON_DELAY	0x60	RUN および OPERATION (または、そのいずれか) によるオンから、出力レールのターンオンまでの時間。	R/W Word	Υ	L11	ms	Υ	0.0 0x8000	<u>78</u>
TON_RISE	0x61	出力の立ち上がり開始から、出力電圧がVOUT コマンドで指定された値に達するまでの時間。	R/W Word	Υ	L11	ms	Υ	8.0 0xD200	<u>78</u>
TON_MAX_FAULT_LIMIT	0x62	TON_RISEの開始から、VOUTがVOUT_UV_FAULT_ LIMITをよぎるまでの最大時間。	R/W Word	Υ	L11	ms	Υ	10.00 0xD280	<u>78</u>
TON_MAX_FAULT_ RESPONSE	0x63	TON_MAX_FAULTイベントが検出されたときの デバイスの動作。	R/W Byte	Υ	Reg		Υ	0xB8	<u>83</u>
TOFF_DELAY	0x64	RUN および OPERATION (またはそのいずれか) によるオフから TOFF_FALL ランプの開始までの時間。	R/W Word	Υ	L11	ms	Υ	0.0 0x8000	<u>79</u>
TOFF_FALL	0x65	出力の立ち下がり開始から、出力がOVに達する までの時間。	R/W Word	Υ	L11	ms	Υ	8.00 0xD200	<u>79</u>
TOFF_MAX_WARN_ LIMIT	0x66	TOFF_FALLが完了してから、デバイスが12.5% 未満に減衰するまでの最大許容時間。	R/W Word	Υ	L11	ms	Υ	150 0xF258	<u>79</u>
STATUS_BYTE	0x78	ユニットのフォルト状態の1バイトの要約。	R/W Byte	Υ	Reg			NA	<u>92</u>
STATUS_WORD	0x79	ユニットのフォルト状態の2バイトの要約。	R/W Word	Υ	Reg			NA	<u>92</u>
STATUS_VOUT	0x7A	出力電圧のフォルトおよび警告の状態。	R/W Byte	Υ	Reg			NA	93
STATUS_IOUT	0x7B	出力電流のフォルトおよび警告の状態。	R/W Byte	Υ	Reg			NA	93
STATUS_INPUT	0x7C	入力電源のフォルトおよび警告の状態。	R/W Byte	N	Reg			NA	<u>93</u>
STATUS_TEMPERATURE	0x7D	READ_TEMERATURE_1の外部温度フォルトおよび 警告の状態。	R/W Byte	Υ	Reg			NA	<u>94</u>
STATUS_CML	0x7E	通信およびメモリのフォルトおよび警告の状態。	R/W Byte	N	Reg			NA	<u>94</u>
STATUS_MFR_SPECIFIC	0x80	メーカー固有のフォルトおよび状態の情報。	R/W Byte	Υ	Reg			NA	<u>94</u>
READ_VIN	0x88	入力電源電圧の測定値。	R Word	N	L11	V		NA	<u>97</u>
READ_IIN	0x89	入力電源電流の測定値。	R Word	N	L11	Α		NA	<u>97</u>
READ_VOUT	0x8B	出力電圧の測定値。	R Word	Υ	L16	V		NA	<u>97</u>
READ_IOUT	0x8C	出力電流の測定値。	R Word	Υ	L11	А		NA	<u>98</u>
READ_TEMPERATURE_1	0x8D	外部温度センサ。IOUT_CAL_GAINをはじめとする、 全ての温度関連処理に使用される値。	R Word	Υ	L11	С		NA	<u>98</u>
READ_TEMPERATURE_2	0x8E	内部ダイ温度。他のいずれのレジスタにも影響を 与えない。	R Word	N	L11	С		NA	<u>98</u>
READ_DUTY_CYCLE	0x94	上側ゲート制御信号のデューティ・サイクル。	R Word	Υ	L11	%		NA	<u>98</u>
READ_POUT	0x96	出力電力の測定値。	R Word	Υ	L11	W		NA	<u>98</u>
PMBUS_REVISION	0x98	デバイスがサポートする PMBus のリビジョン。 現在のリビジョンは 1.2。	R Byte	N	Reg			0x22	<u>89</u>
MFR_ID	0x99	LTC3887のメーカー IDをASCIIで示した値。	R String	N	ASC			LTC	<u>89</u>
MFR_MODEL	0x9A	メーカー製品番号をASCIIで示した値。	R String	N	ASC			LTC3887	90
MFR_SERIAL	0x9E	この特定のユニットのシリアル番号。	R Block	N	CF			NA	90
MFR_VOUT_MAX	0xA5	VOUT_OV_FAULT_LIMITを含む最大許容出力電圧。	R Word	Y	L16	V		5.7 0x5B34	<u>73</u>



コマンド名	CMD コード	説明	タイプ	ページ 指定	データ 形式	単位	NVM	デフォルト 値	ページ
USER_DATA_00	0xB0	OEMにより予約。通常、デバイスのシリアル化に使用。	R/W Word	N	Reg		Υ	NA	<u>89</u>
USER_DATA_01	0xB1	メーカーにより、LTpowerPlay用に予約。	R/W Word	Υ	Reg		Υ	NA	<u>89</u>
USER_DATA_02	0xB2	OEMにより予約。通常、デバイスのシリアル化に使用。	R/W Word	N	Reg		Υ	NA	<u>89</u>
USER_DATA_03	0xB3	ユーザーが使用可能なNVMワード。	R/W Word	Υ	Reg		Υ	0x0000	<u>89</u>
USER_DATA_04	0xB4	ユーザーが使用可能なNVMワード。	R/W Word	N	Reg		Υ	0x0000	<u>89</u>
MFR_EE_UNLOCK	0xBD	MFR_EE_ERASE コマンドと MFR_EE_DATA コマンドによるアクセスのために、 ユーザーの EEPROM のロックを解除する。	R/W Byte	N	Reg			NA	106
MFR_EE_ERASE	0xBE	MFR_EE_DATAによる一括プログラミングのために、 ユーザーのEEPROMを初期化する。	R/W Byte	N	Reg			NA	106
MFR_EE_DATA	0xBF	PMBusワードの順次読み出しまたは書き込みに よってEEPROMとの間で伝送されるデータ。 一括プログラミングをサポートする。	R/W Word	N	Reg			NA	106
MFR_CHAN_CONFIG_ LTC3887	0xD0	チャネル固有の構成ビット。	R/W Byte	Y	Reg		Υ	0x1D	<u>65</u>
MFR_CONFIG_ALL_ LTC3887	0xD1	全てのページで共通の構成ビット。	R/W Byte	N	Reg		Υ	0x01	<u>66</u>
MFR_GPIO_ PROPAGATE_LTC3887	0xD2	GPIO ピンに伝播するフォルトを決定する設定。	R/W Word	Υ	Reg		Υ	0x6993	<u>87</u>
MFR_PWM_MODE_ LTC3887	0xD4	各チャネルの PWM エンジンの設定。	R/W Byte	Υ	Reg		Υ	0xC1	<u>68</u>
MFR_GPIO_RESPONSE	0xD5	GPIOピンが外部から"L"にアサートされたとき、 デバイスが取るアクション。	R/W Byte	Υ	Reg		Υ	0xC0	88
MFR_OT_FAULT_ RESPONSE	0xD6	内部過熱フォルトが検出されたとき、 デバイスが取るアクション。	R Byte	N	Reg			0xC0	<u>85</u>
MFR_IOUT_PEAK	0xD7	最後のMFR_CLEAR_PEAKS以降に測定された READ_IOUTの最大値を報告する。	R Word	Y	L11	А		NA	99
MFR_ADC_CONTROL	0xD8	A/Dコンバータの反復される高速読み出しのために 選択するADCテレメトリ・パラメータ。	R/W Byte	N	Reg			0x00	99
MFR_ADC_TELEMETRY_ STATUS	0xDA	ショート・ラウンド・ロビン ADC ループがイネーブル されたときに、最後に変換されたパラメータを示す ADC テレメトリ・ステータス。	R/W Byte	N	Reg		Υ	NA	100
MFR_RETRY_DELAY	0xDB	フォルト再試行モードでの再試行間隔。	R/W Word	Y	L11	ms	Υ	350 0xFABC	<u>80</u>
MFR_RESTART_DELAY	0xDC	LLTC3887がRUNピンを"L"に保持する最小時間。	R/W Word	Y	L11	ms	Υ	500 0xFBE8	<u>80</u>
MFR_VOUT_PEAK	0xDD	最後のMFR_CLEAR_PEAKS以降に測定された READ_VOUTの最大値。	R Word	Y	L16	V		NA	98
MFR_VIN_PEAK	0xDE	最後のMFR_CLEAR_PEAKS以降に測定された READ_VINの最大値。	R Word	N	L11	V		NA	99
MFR_TEMPERATURE_1_ PEAK	0xDF	最後のMFR_CLEAR_PEAKS以降に測定された 外部温度(READ_TEMPERATURE_1)の最大値。	R Word	Y	L11	С		NA	99
MFR_CLEAR_PEAKS	0xE3	全てのピーク値をクリアする。	Send Byte	N				NA	<u>91</u>
MFR_PADS	0xE5	1/0パッドのデジタル・ステータス。	R Word	N	Reg			NA	<u>95</u>
MFR_ADDRESS	0xE6	7ビットのI ² Cアドレス・バイトを設定する。	R/W Byte	N	Reg		Υ	0x4F	<u>65</u>
MFR_SPECIAL_ID	0xE7	LTC3887を表すメーカー・コード。	R Word	N	Reg			0x470X	<u>90</u>

PMBusコマンドの概要

コマンド名	CMD コード	説明	タイプ	ページ 指定	データ 形式	単位	NVM	デフォルト 値	ページ
MFR_IIN_OFFSET	0xE9	デバイスのIQを考慮するために入力電流への 追加に使用される係数。	R/W Word	Y	L11	А	Υ	0.050 0X9333	<u>74</u>
MFR_FAULT_LOG_ STORE	0xEA	RAM から EEPROM へのフォルト・ログの伝送を 命令する。	Send Byte	N				NA	102
MFR_FAULT_LOG_ CLEAR	0xEC	フォルト・ログ用に予約されたEEPROMブロックを 初期化する。	Send Byte	N				NA	106
MFR_READ_IIN	0xED	チャネルごとに測定された入力電流。	R Word	Υ	L11	Α		NA	98
MFR_FAULT_LOG	0xEE	フォルト・ログのデータ・バイト。この順次取得データを使用して完全なフォルト・ログをアセンブルする。	R Block	N	Reg		Υ	NA	<u>102</u>
MFR_COMMON	0xEF	複数のLTCチップに共通するメーカー・ステータス・ ビット。	R Byte	N	Reg			NA	<u>95</u>
MFR_COMPARE_USER_ ALL	0xF0	現在のコマンドの内容をNVMと比較する。	Send Byte	N				NA	<u>101</u>
MFR_TEMPERATURE_2_ PEAK	0xF4	最後のMFR_CLEAR_PEAKS以降の内部ダイ温度のピーク。	R Word	N	L11	С		NA	99
MFR_PWM_CONFIG_ LTC3887	0xF5	位相設定をはじめとするDC/DCコントローラの 多数のパラメータを設定する。	R/W Byte	N	Reg		Υ	0x10	<u>69</u>
MFR_IOUT_CAL_GAIN_ TC	0xF6	電流検出素子の温度係数。	R/W Word	Y	CF		Υ	3900 0x0F3C	<u>74</u>
MFR_TEMP_1_GAIN	0xF8	外付け温度センサの勾配を設定する。	R/W Word	Y	CF		Υ	1.0 0x4000	<u>76</u>
MFR_TEMP_1_OFFSET	0xF9	外付け温度センサの-273.1℃を基準とした オフセットを設定する。	R/W Word	Y	L11	С	Υ	0.0 0x8000	<u>76</u>
MFR_RAIL_ADDRESS	0xFA	PolyPhase 出力の共通パラメータを調整するための 共通アドレス。	R/W Byte	Y	Reg		Υ	0x80	<u>65</u>
MFR_RESET	0xFD	パワーダウン不要の、コマンドによるリセット。	Send Byte	N				NA	<u>68</u>

Note 1: 「Y」と書かれたコマンドは、STORE_USER_ALL コマンドによって格納され、RESTORE_USER_ALL コマンドによってリストアされることを意味する。

Note 2: デフォルト値に「NA」と示されたコマンドは、「該当値なし」を意味する。 デフォルト値に「FS」と示されたコマンドは、「デバイスごとに工場で設定済み」を意味する。

Note 3: LTC3887には、この表には記載されていない他のコマンドも実装されている。これらのコマンドの読み出しがICの動作に悪影響を及ぼすことはないが、その内容や意味は予告なく変更される場合がある。

Note 4: 未公開のコマンドの一部は読み出し専用であり、書き込むと CML ビット 6 のフォルトが発生する。

Note 5:この表に公開されていないコマンドへの書き込みは禁止されている。

Note 6: たとえコマンド名が同じであっても、異なるデバイス間でコマンドに互換性があると見なさないこと。必ずデバイスごとにメーカーのデータシートを参照してコマンド機能の詳細な定義を確認すること。

LTCは、コマンド機能のデバイス間互換性を保つように相応の取り組みを行ってきたものの、製品の要件を満たすために相違点が生じる場合もある。



38871

PMBusコマンドの概要

*データ形式

- T	ツルエ	
L11	Linear_5s_11s	PMBus のデータ・フィールド b[15:0] 値 = Y・2 ^N ここで、N = b[15:11] は5ビットの2の補数の整数、Y = b[10:0] は11ビットの2の補数の整数 例:
		b[15:0] = 0x9807 = 'b10011_000_0000_0111 の場合 値 = 7・2 ⁻¹³ = 854・10 ⁻⁶
		「PMBus Spec Part II: Paragraph 7.1」より
L16	Linear_16u	PMBus のデータ・フィールド b[15:0] 値 = Y・2 ^N ここで、Y = b[15:0]は符号なしの整数、N = Vout_mode_parameterは5ビットの2の補数の指数で、 10進数の-12に固定配線されている
		例: b [15:0] =0x4C00 = 'b0100_1100_0000_0000 の場合 値 = 19456・2 ⁻¹² = 4.75
		「PMBus Spec Part II: Paragraph 8.2」より
Reg	レジスタ	PMBusのデータ・フィールド b[15:0] または b[7:0]
		ビット・フィールドの意味はPMBusコマンド・レジスタの詳細解説で定義されている
116	Integer Word	PMBus のデータ・フィールド b[15:0] 値 = Y
		ここで、Y = b[15:0] は16ビットの符号なし整数
		例: b[15:0] = 0x9807 = 'b1001_1000_0000_0111 の場合 値 = 38919(10進)
CF	Custom Format	値はPMBusコマンド・レジスタの説明で詳細に定義されている。 多くの場合、MFR固有の一定の倍率が掛けられる、符号なし整数または2の補数の整数である
ASC	ASCII Format	ISO/IEC8859-1 規格に準拠した、可変長の文字列。

裏表紙の「標準的応用例」はLTC3887の一般的なアプリケー ション回路です。LTC3887は、DCR (インダクタの抵抗)検出 または低い値の抵抗による検出のどちらかを使うように構成 することができます。2つの電流検出方式のどちらを選択する かは、主として設計上、コスト、消費電力、精度のどれを採る かで決まります。DCRによる検出は高価な電流検出抵抗を 省くことができ、特に大電流のアプリケーションで電力効率 が高いので普及しています。LTC3887は、設計上DCR検出 素子の温度依存性を考慮しています。電流の読み出し値や 電流制限値の精度は、通常DCR抵抗の精度(LTC3887の IOUT CAL GAINレジスタに反映)によって制限されます。し たがって、電流検出抵抗がアプリケーションのより正確な電 流検出と電流制限の値を提供します。他の外付け部品の選 択は負荷条件に基づいて行い、(もしR_{SENSE}が使われていれ ば) R_{SENSE}とインダクタ値の選択から始めます。次に、パワー MOSFETを選択します。続いて、入力と出力のコンデンサを選 択します。最後に電流制限の値を選択します。これらの部品 および値の範囲は、いずれも外付けの補償用部品を計算す る前に決定しておく必要があります。電流制限の範囲が必要 となるのは、MFR_PWM_MODE_LTC3887コマンド内のビッ ト7で設定される、EAの利得が2つのレンジ(25mV~50mV と37.5mV~70mV)で異なるためです。電圧のRANGEビッ トでもループ利得を変更可能であり、MFR PWM MODE LTC3887のビット1によって設定される補償ネットワークにも 影響を与えます。プログラム可能なその他のパラメータはルー プ利得に影響を与えないため、負荷に対するトランジェント応 答に影響を与えずに変更できます。

電流制限のプログラミング

LTC3887には電流制限のプログラミング・レンジが2つ、各レンジ内には計8つのレベルがあります。PMBusコマンドのIOUT_OC_FAULT_LIMITのセクションを参照してください。各レンジ内ではエラー・アンプの利得が固定されているため、ループ利得は一定になります。LTC3887はインダクタのDCRの温度係数を考慮し、インダクタの温度変化に応じて電流制限を自動的に更新します。DCRの温度係数はMFR IOUT CAL GAIN TCレジスタに格納します。

電流制限の精度を最大限に高めるには、75mVの設定を使用してください。25mVに設定するとDCRが非常に小さなインダクタまたは検出抵抗を使用できますが、電流制限の精度が劣化します。電流制限はサイクルごとであり、インダクタのピーク電流だけで決まります。インダクタの平均電流はADCによってモニタされ、過大な平均出力電流が流れた場合に警告を発することができます。過電流フォルトは、ITH電圧が最大値に達した時点で検出されます。LTC3887内のデジタル・プロセッサには、フォルトを無視する機能、デバイスをシャットダウンして無期限でリトライを繰り返す機能(ヒカップ)があります。詳細は、「動作」のセクションの過電流の項を参照してください。

ISENSE[†]ピンとISENSE⁻ピン

Isense⁺ピンとIsense⁻ピンは、電流コンパレータとA/Dの入力です。電流コンパレータの同相入力電圧範囲は、0V~5.5Vです。SENSEピンは両方とも高インピーダンス入力であり、通常1μA未満の小さなベース電流が流れます。Isenseピンが0Vから1.4Vにランプアップすると、小さなベース電流がSENSEピンから流れ出します。Isenseピンの電圧が1.4Vを超えると、ベース電流がIsenseピンに流れ込みます。電流コンパレータへの入力は高インピーダンスなので、DCRによる正確な検出が可能です。通常動作中は、これらのピンをフロート状態にしないでください。

ISENSEラインに接続されるフィルタ部品はデバイスの近くに配置してください。正側と負側のトレースは差動配線とし、電流検出素子にケルビン接続します(図 24参照)。非ケルビン接続によって、電流検出素子の寄生インダクタンスや寄生容量が増加し、検出端子における情報が劣化して、プログラムされた電流制限が正しく機能しないことがあります。PolyPhaseシステムにおいて検出素子の配置をおろそかにすると、電力段間で最適の電流シェアリングが行われなくなる恐れがあります。DCR検出を使用する場合は(図25a)、検出抵抗R1をスイッチング・ノード(SW)の近くに配置して、敏感な小信号ノードにノイズが結合することを防ぐ必要があります。コンデンサ

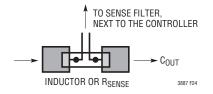


図24. 検出ラインの最適配置



3887f

C1はICのピンの近くに配置します。このインピーダンスの差がADCの電流読み出し値の精度劣化につながる恐れがあります。電流読み出し値の精度は、2つの I_{SENSE} 入力のインピーダンスを整合させることで改善する場合があります。それには、 V_{OUT} と I_{SENSE} 間に R_1 に等しい直列抵抗を追加します。この抵抗と並列に $I_{\mu}F$ 以上のコンデンサを接続します。室温のピーク電圧が75mV未満の場合、 R_2 は不要です。

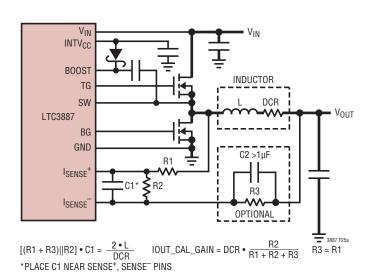


図25a. インダクタDCRによる電流検出回路

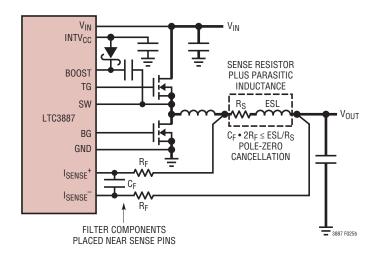


図25b. 抵抗による電流検出回路

値の小さな抵抗による電流検出

ディスクリート抵抗を使用した標準的な検出回路を図25bに示します。R_{SENSE}は必要な出力電流に基づいて選択します。

電流コンパレータの最大しきい値 $V_{SENSE}(MAX)$ は I_{LIMIT} の設定によって決まります。電流コンパレータの入力同相電圧の範囲は $0V \sim 5.5V$ です $(V_{IN}$ が 6V よりも大きい場合)。電流コンパレータのしきい値によってインダクタ電流のピーク値が設定され、このピーク値からピーク・トゥ・ピーク・リップル電流 ΔI_{L} の半分を差し引いた値に等しい最大平均出力電流 I_{MAX} が得られます。検出抵抗の値を計算するには次式を使用します。

$$R_{SENSE} = \frac{V_{SENSE(MAX)}}{I_{MAX} + \frac{\Delta I_{L}}{2}}$$

電流検出ループにPCB / イズが存在する可能性があるため、 $\Delta V_{SENSE} = \Delta I_L \cdot R_{SENSE}$ の AC 電流検出リップルも設計で チェックして、信号対雑音比(SNR)を良くする必要があります。一般に、適度に良好な PCB レイアウトを得るには、R_SENSE または DCR のいずれの検出アプリケーションの場合でも、検討着手時の控えめな値として 15 mV の最小 ΔV_{SENSE} 電圧を 推奨します。

従来の電流モード・コントローラでは、最大検出電圧が十分 高く(例えば、LTC1628/LTC3728製品ファミリでは75mV)、 検出抵抗の寄生インダクタンス両端の電圧降下は比較的小 さな誤差にしかなりませんでした。ただし、より新しく高い電 流密度のソリューションでは、検出抵抗の値は1mΩに満たな いことがあり、ピーク検出電圧が20mVを下回る場合がありま す。さらに、最大1MHzの動作でインダクタのリップル電流が 50%を超えることも普通になってきています。これらの条件で は、もはや検出抵抗の寄生インダクタンスによる電圧降下を 無視できません。ディスクリート抵抗を使用した標準的な検出 回路を図18bに示します。従来のコントローラでは、PCBの検 出トレースに結合した容量性および誘導性のノイズの影響を 低減するのに、通常はデバイスの近くに配置した小さなRCフィ ルタが使用されていました。標準的なフィルタは1000pFの並 列コンデンサに接続された2個の直列100Ω抵抗で構成され、 時定数は200nsになります。



この同じRCフィルタは、若干の変更を加えることで寄生インダクタンスが存在する環境における、電流検出信号の抵抗性成分の抽出に使用できます。例えば、図26は2010フットプリントの2mΩ抵抗両端の電圧波形です。波形は、純粋な抵抗性成分と純粋な誘導性成分が重畳されたものです。これは、差動測定による結果を得るため、オシロスコープの2つのプローブと波形計算を使用して測定しています。インダクタのリップル電流および上側スイッチのオン時間とオフ時間の追加測定に基づき、寄生インダクタンスの値は次式によって0.5nHであると計算されました。

$$ESL = \frac{V_{ESL(STEP)}}{\Delta I_{L}} \bullet \frac{t_{ON} \bullet t_{OFF}}{t_{ON} + t_{OFF}}$$
(1)

寄生インダクタンスを検出抵抗で割った値(L/R)に近くなるようにRC時定数を選択すると、得られる波形は図27に示すように抵抗性に見えます。低い最大検出電圧を使用するアプリケーションでは、検出抵抗メーカーのデータシートに記載された寄生インダクタンスの情報を確認してください。データが存在しない場合は、検出抵抗の両端で電圧降下を直接測定してESLステップの大きさを求め、式1を使用してESLを決定します。ただし、信号にフィルタをかけすぎないでください。RC時定数をインダクタの時定数以下にしてVRSENSEのリップル電圧を十分高く保ち、電流ループ・コントローラの最適動作を確保します。

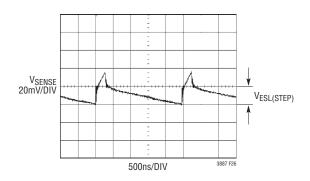


図26.R_{SENSE}両端で直接測定した電圧

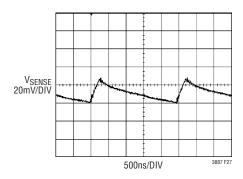


図27. RSENSEのフィルタ後に測定した電圧

インダクタ DCR による電流検出

LTC3887は、高負荷電流で可能な限り高い効率を必要とするアプリケーション向けに、図25aに示した方法でインダクタのDCR両端の電圧降下を検出できます。インダクタのDCRとは、銅巻線のDC抵抗の小さな値を表し、最近の値の小さい大電流インダクタでは1mΩより小さいことがあります。このようなインダクタを必要とする大電流アプリケーションでは、検出抵抗による導通損失は、DCRによる検出に比べると数ポイントの効率低下になると考えられます。

外部の(R1+R3) ||R2 • C1の時定数が正確に2 • L/DCRの時 定数に等しくなるように選択し、R1 = R3と仮定すると、外付け コンデンサ両端の電圧降下はインダクタのDCR両端の電圧 降下にR2/(R1+R2+R3)を掛けたものに等しくなります。R2は、目標とする検出抵抗値よりもDCRが大きいアプリケーショ ンの検出端子両端の電圧のスケールを設定します。R2が不 要な場合、DCRの値はIOUT CAL GAINにmΩ単位で入 力します。R2を使用する場合は、IOUT CAL GAIN = DCR・ R2/(R1+R2+R3)となります。信号を減衰させる必要がない 場合は、R2を省くことができます。外付けのフィルタ部品の大 きさを適切に決定するには、インダクタのDCRを知る必要が あります。DCRは適切なRLCメータを使って測定できますが、 DCRの許容誤差は常に同じとは限らず、温度によって変化し ます。詳細については、メーカーのデータシートを参照してく ださい。MFR IOUT CAL GAIN TCレジスタに正確なパラ メータを入力すれば、LTC3887は温度変動を考慮して動作し ます。通常、抵抗の温度係数は3900ppm/°Cです。

R1 = R3と仮定して次の式を使用し、平坦な周波数応答が得られるようにC2を最適化できます。

$$C2 = [2R1 \cdot R2 \cdot C1 - L/DCR \cdot (2R1 + R2)]/R1^{2}$$

「インダクタの値の計算」のセクションのインダクタ・リップル 電流値を使用すると、目標とする検出抵抗値は次のようにな ります。

$$R_{SENSE(EQUIV)} = \frac{V_{SENSE(MAX)}}{I_{MAX} + \frac{\Delta I_{L}}{2}}$$



アプリケーションが、動作温度範囲の全域で最大負荷電流を確実に供給できるように、MFR_IOUT_CAL_GAINに入力するパラメータに応じて、DCRの誤差を考慮した最適のI_{LIMIT}を選択してください。

次に、インダクタのDCRを決定します。提供されている場合、通常は 20° Cで規定されるメーカーの最大値を使用します。温度検出素子自体の 3° C~ 5° Cの誤差や、温度センサ素子とインダクタ間の距離に伴うその他の誤差を全て加味して、この値を増加させます。

インダクタの最大DCRを必要な検出抵抗値に合わせてスケール調整するには、次の分圧器の比を使います。

$$RD = \frac{R_{SENSE(EQUIV)}}{DCR_{(MAXERROR)} \text{ at } T_{L(MAX)}}$$

C1は通常、 0.047μ F~ 4.7μ Fの範囲で選択します。これによって、 $R1\parallel$ R2は自動的に約2kになります。この抵抗値によって、SENSEピンの漏れ電流によって生じる誤差が最小限に抑えられます。図18aに示すようにオプションの素子R3とC2を追加すると、これらの漏れ電流に伴うオフセット誤差を最小化できます。

等価抵抗(R1+R3) ||R2は室温のインダクタンスと最大DCR に従って次のようにスケーリングされます。

$$(R1+R3)||R2 = \frac{2 \cdot L}{(DCR \text{ at } 20^{\circ}C) \cdot C1}$$

検出抵抗の値は、次のようになります。

R1=R3; R1=
$$\frac{R1||R2}{RD}$$
; R2= $\frac{R1 \cdot RD}{1-RD}$

R1による最大電力損失はデューティ・サイクルと関係があり、 連続モード時の最大入力電圧で発生します。

$$P_{LOSS}R1 = \frac{\left(V_{IN(MAX)} - V_{OUT}\right) \cdot V_{OUT}}{R1}$$

R1の電力定格がこの値より大きいことを確認してください。軽負荷時に高い効率が必要な場合、DCR検出と検出抵抗のどちらを使用するかを決定するときに、この電力損失を検討します。軽負荷での電力損失は、R1によって生じる余分なスイッチング損失のため、検出抵抗を使う場合よりDCR回路網を使う方がやや高いことがあります。ただし、DCRによる検出では検出抵抗が省かれることで、導通損失が減少し、重負荷時の効率が高くなります。ピーク効率はどちらの方法でもほぼ同じです。不連続モードを選択すると、電流検出方式に関係なく、軽負荷時のコンバータ効率が向上します。

電流検出信号の信号対雑音比を良好に保つには、 $10 \text{mV} \sim 15 \text{mV}$ の最小 $\Delta \text{V}_{\text{SENSE}}$ を使います。D CR 検出を使用するアプリケーションにおける、実際のリップル電圧は次式で求められます。

$$\Delta V_{SENSE} = \frac{V_{IN} - V_{OUT}}{R1 \cdot C1} \cdot \frac{V_{OUT}}{V_{IN} \cdot f_{OSC}}$$

スロープ補償とインダクタのピーク電流

スロープ補償により、高いデューティ・サイクルでの低調波発振が防止されるので、固定周波数電流モード・アーキテクチャの安定性が得られます。これは、35%を超えるデューティ・サイクルの場合、インダクタ電流信号に内部で補償ランプを重畳させることで実現します。LTC3887は、補償ランプに対抗する特許取得済みの電流制限手法を使用しています。この手法により、デューティ・サイクルがどのような値を取っても、インダクタの最大ピーク電流には影響が及びません。

インダクタ値の計算

必要な入力電圧と出力電圧が与えられると、インダクタ値と動作周波数foscによって直ちにインダクタのピーク・トゥ・ピーク・リップル電流が決まります。

$$I_{RIPPLE} = \frac{V_{OUT} (V_{IN} - V_{OUT})}{V_{IN} \cdot f_{OSC} \cdot L}$$

リップル電流が小さいと、インダクタのコア損失、出力コンデンサのESR 損失、および出力電圧リップルが減少します。このため、最大効率の動作は、最低周波数でリップル電流が小さい場合に得られます。ただし、これを達成するには大きなインダクタが必要になります。

/ LINEAR

妥当な出発点として、I_{OUT} (MAX)の約40%のリップル電流を選択します。入力電圧が最大のときに最大リップル電流が生じることに注意してください。リップル電流が規定の最大値を超えないことを保証するには、次式に従ってインダクタを選択します。

$$L \ge \frac{V_{OUT} \left(V_{IN} - V_{OUT} \right)}{V_{IN} \bullet f_{OSC} \bullet I_{RIPPLE}}$$

インダクタのコアの選択

インダクタ値が決定されたら、次にインダクタの種類を選択する必要があります。インダクタ値が一定の場合、コア損失はコア・サイズには依存せず、インダクタンスに強く依存します。インダクタンスが増加すると、コア損失は減少します。しかし残念なことに、インダクタンスを大きくするにはワイヤの巻数を増やす必要があり、銅損失が増加します。

フェライトを使用した設計ではコア損失がきわめて小さく、高いスイッチング周波数に適しているため、設計目標を飽和の防止と銅損失に集中することができます。フェライト・コアの材質は「ハードに」飽和します。つまり、設計ピーク電流を超えるとインダクタンスは急激に低下します。その結果、インダクタのリップル電流が急激に増加し、そのため出力電圧リップルも増加します。コアは絶対に飽和させないでください。

パワー MOSFET とショットキ・ダイオード (オプション)の 選択

LTC3887ではコントローラ1つに付き、2個の外付けパワー MOSFETを選択する必要があります。上側(メイン)スイッチ 用および下側(同期)スイッチ用にそれぞれ1個のNチャネル MOSFETです。

ピーク・トゥ・ピーク駆動レベルはINTV_{CC}電圧により設定されます。この電圧は、標準で5Vです。したがって、ほとんどのアプリケーションでは、ロジック・レベルのしきい値を持つMOSFETを使用する必要があります。唯一の例外は、低い入力電圧($V_{IN} < 5V$)が想定される場合です。この場合は、サブロジック・レベルのしきい値を持つMOSFET($V_{GS\,(TH)} < 3V$)を使用してください。MOSFETのBV_{DSS}の仕様にも十分注意を払ってください。ほとんどのロジック・レベル MOSFET は、30V以下に制限されています。

パワー MOSFET の選択基準には、オン抵抗 $R_{DS}(ON)$ 、ミラー容量 C_{MILLER} 、入力電圧、および最大出力電流が含まれます。ミラー容量 C_{MILLER} は、MOSFET のメーカーのデータシートに通常記載されているゲート電荷曲線から推定することができます。 C_{MILLER} は、曲線がほぼ平らな区間の水平軸に沿ったゲート電荷の増分を、規定の V_{DS} 電圧変化で割ったものに等しくなります。次に、この結果に、アプリケーションで印加される V_{DS} とゲート電荷曲線で規定されている V_{DS} との比を掛けます。このデバイスが連続モードで動作しているときのトップ MOSFET とボトム MOSFET のデューティ・サイクルは以下の式で与えられます。

Main Switch Duty Cycle =
$$\frac{V_{OUT}}{V_{IN}}$$

Synchronous Switch Duty Cycle = $\frac{V_{IN} - V_{OUT}}{V_{IN}}$

最大出力電流でのMOSFETの電力損失は、以下の式で与えられます。

$$\begin{split} P_{MAIN} &= \frac{V_{OUT}}{V_{IN}} \big(I_{MAX}\big)^2 \big(1 + \delta\big) R_{DS(ON)} + \\ & \big(V_{IN}\big)^2 \bigg(\frac{I_{MAX}}{2}\bigg) \big(R_{DR}\big) \big(C_{MILLER}\big) \bullet \\ & \bigg[\frac{1}{V_{INTVCC} - V_{TH(MIN)}} + \frac{1}{V_{TH(MIN)}}\bigg] \bullet f_{OSC} \end{split}$$

$$P_{SYNC} = \frac{V_{IN} - V_{OUT}}{V_{IN}} (I_{MAX})^2 (1+\delta) R_{DS(ON)}$$

ここで、 δ は $R_{DS(ON)}$ の温度依存性、 R_{DR} (約 2Ω)はMOSFET のミラーしきい値電圧での実効ドライバ抵抗です。 $V_{TH\,(MIN)}$ は、MOSFETの最小しきい値電圧の標準値です。

 I^2R 損失はいずれのMOSFETでも発生しますが、上側のNチャネルの式には遷移時の損失の項が追加され、これは入力電圧が高いときに最も高くなります。 $V_{\rm IN}<20$ Vでは、高電流のときの効率はより大型のMOSFETを使用すると向上しますが、 $V_{\rm IN}>20$ Vでは遷移損失が急激に増加し、その影響は、 $C_{\rm MILLER}$ が小さく、 $R_{\rm DS}(ON)$ が大きなデバイスを使用する方がむしろ効率が良くなるほどです。同期MOSFETの損失は、上側スイッチのデューティ・ファクタが低く入力電圧が高い場合、または同期スイッチが周期の100%近くオンになる短絡時に最も大きくなります。



一般的に、MOSFETの $(1+\delta)$ の項は、正規化された $R_{DS}(ON)$ と温度の関係を示す曲線の形式で与えられますが、低電圧のMOSFETの場合は、近似値として $\delta = 0.005$ \cite{C} \cite

オプションのショットキ・ダイオードは、2つのパワー MOSFET の導通期間に挟まれたデッドタイム中に導通します。これにより、下側 MOSFET のボディ・ダイオードがオンしてデッドタイム中に電荷を蓄積するのを防止し、逆回復時間を不要にします。逆回復時間があると、VINが高いときに効率が最大3%低下することがあります。平均電流は比較的小さいので、通常は1A~3Aのショットキが両方の動作領域に対する適切な妥協点となります。これより大きなダイオードは接合容量が大きいため、遷移損失が増加します。

可変遅延時間、ソフトスタート、出力電圧ランプ

LTC3887は、ソフトスタートの前に動作状態に移行している必要があります。デバイスの初期化が完了し、 V_{IN} が V_{IN} ONしきい値を超えると、RUNピンが解放されます。アプリケーションで複数のLTC3887を使用する場合、同じRUNピンを共用するように構成してください。全てのデバイスで初期化が完了し、 V_{IN} が V_{IN} ONしきい値を超えるまで、いずれのデバイスも、それぞれの対応するRUNピンを"L"に保持します。 $SHARE_CLK$ ピンは、この信号を接続されたデバイスが、全て同じタイムベースを使用することを保証します。

RUNピンの解放後、コントローラはユーザーが指定するターンオン遅延(TON_DELAY)の経過を待ってから、出力電圧のランプを開始します。複数のLTC3887および他のLTCデバイスは、可変遅延時間で起動するように構成できます。適切に動作させるには、全てのデバイスで同じタイミング・クロック(SHARE_CLK)を使用し、全てのデバイスがRUNピンを共用する必要があります。これによって、全てのデバイスの相対遅延が同期されます。遅延の実際の変化は、SHARE_CLKピンに接続されたデバイスの最も高速なクロック速度によって決まります(リニアテクノロジーのICは、最高速のSHARE_CLK信号によって全デバイスのタイミングを制御できるように構成されています)。SHARE_CLK信号の周波数は±10%変動する可能性があるため、実際の時間遅延は、これと同様に変動します。

ソフトスタートは、負荷電圧をアクティブに安定化しながら、目標電圧をOVから指定された電圧設定値までデジタルにランプ・アップさせることで実現します。電圧ランプの立ち上がり時間はTON_RISEコマンドによってプログラムできるため、起動時の電圧ランプに伴う突入電流を最小限に抑えることができます。ソフトスタート機能は、TON_RISEの値を0.250ms未満の任意の値に設定することでディスエーブルできます。LTC3887は必要な計算を内部で実行して、電圧を確実に目的の勾配に制御します。ただし、電力段の基本的な制限値よりも急峻な電圧勾配を得ることはできません。TON_RISE時間を短く設定するほど、TON_RISEのランプはギザギザになります。ランプには、TON_RISE/0.1msの数だけステップが現れます。

TON_RISE動作中、LTC3887のPWMは常に不連続モードを使用します。不連続モードでは、インダクタで逆電流が検出されると、直ちに下側ゲートがオフされます。この動作により、レギュレータはプリバイアスされた負荷でも起動できるようになります。

LTC3887はトラッキング機能を備えていませんが、2つの出力に同じTON_RISEとTON_DELAY時間を設定すれば、実効的に両者は同時にランプ・アップします。RUNピンが同時に解放され、両方のデバイスが同じタイムベースを使用しているため、出力は互いにわずかな差異でトラッキングします。回路がPolyPhase構成の場合、全てのタイミング・パラメータが同じでなければなりません。

ここで説明した起動シーケンシングの方法は時間ベースで す。連結イベントによる起動では、異なるコントローラの GPIO ピンを使って、RUNピンを制御できます。GPIOピンは、コン バータの出力電圧がVOUT UV FAULT LIMITよりも大き くなった時点で解放されるように構成できます。その場合は、 フィルタを通していない VOUTのUV フォルト・リミットの使用 を推奨します。コンバータがUVしきい値をよぎってからGPIO ピンが解放されるまでに、短いながら無視できない時間遅延 が存在するためです。フィルタを通していない出力は、MFR_ GPIO PROPAGATE VOUT UVUFコマンドを使用してイ ネーブルできます。(本書のPMBusコマンドMFRのセクション を参照してください。)フィルタを通していない信号でも、VOIT 信号がコンパレータのしきい値を超えて遷移する際に、ある程 度のグリッチが生じる場合があります。この問題を最小限に抑 えるために、250μsの小さなデジタル・フィルタが内蔵されてい ます。GPIOピンにグリッチが発生する危険性をできるだけ小 さくするために、TON RISEの時間は100msより短くしてくだ さい。それでもGPIOに好ましくない遷移が発生する場合は、

LINEAR TECHNOLOGY

GPIOピンからグランドにコンデンサを接続して波形をフィルタリングします。このフィルタのRC時定数は十分に短くして、検知できるほどの遅延が発生しないようにします。値を300μs~500μsとすれば、トリガ・イベントを著しく遅延させることなく、フィルタリングの効果をある程度強化できます。

デジタル・サーボ・モード

安定化出力電圧に最大限の精度を求めるならば、MFR PWM MODE LTC3887コマンドのビット6をアサートして、デ ジタル・サーボ・ループをイネーブルします。 デジタル・サーボ・ モードでは、ADCによる電圧読み出し値に基づいて安定化 出力電圧を調整します。デジタル・サーボ・ループは、A/Dコ ンバータによる正確な測定値に出力が達するまで、100msご とにDACのLSB (電圧レンジ・ビットに応じて公称1.375mV または0.6875mV)だけ電圧を調整します。電源投入時、この モードはTON MAX FAULT LIMITの経過後に起動します (値が0(無期限)に設定されていない場合)。TON_MAX_ FAULT LIMITが0(無期限)に設定されている場合、サーボ 制御はTON RISEが経過し、VOUTがVOUT UV FAULT LIMITを超えた時点で開始され、IOUT OCは存在しませ ん。これと同時点に、出力は不連続モードから、MFR PWM MODE LTC3887のビット0によってプログラムされたモード に移行します。時間ベースのシーケンシングにおけるVOUT 波形の詳細は、図28を参照してください。

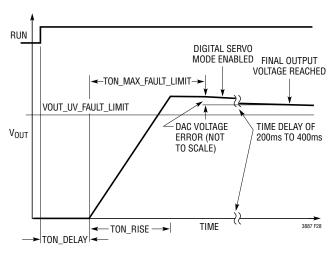


図28. タイミング制御された Vout の立ち上がり

TON_MAX_FAULT_LIMITに0より大きい値が設定され、TON_MAX_FAULT_RESPONSEが「無視」(0x00)に設定されている場合、サーボ制御は次の時点で始まります。

1. TON_RISEシーケンスの完了後

- 2. TON_MAX_FAULT_LIMITの時間の経過後、および
- 3. VOUT_UV_FAULT_LIMITを 超 え る か、IOUT_OC_ FAULT_LIMITがアクティブでなくなった時点

TON_MAX_FAULT_LIMITに0より大きい値が設定され、TON_MAX_FAULT_RESPONSEが「無視」(0x00)に設定されていない場合、サーボ制御は次の時点で始まります。

- 1. TON_RISEシーケンスの完了後
- 2. TON_MAX_FAULT_LIMITの時間が経過し、VOUT_UV_FAULTとIOUT_OC_FAULTのいずれも存在しない場合。

立ち上がり時間の最大値は1.3秒に制限されています。

PolyPhase構成の場合、制御ループのうち1つだけでデジタル・サーボ・モードを有効にすることを推奨します。これによって、リファレンス回路のわずかな違いによって生じる、複数のループ間の競合を防ぐことができます。

ソフトオフ(シーケンス制御によるオフ)

LTC3887は、制御された起動に加えて、制御されたターンオフにも対応しています。図29にTOFF_DELAYとTOFF_FALLの機能を示します。TOFF_FALLはRUNピンが"L"に遷移するか、デバイスがオフするように指示されたときに処理されます。デバイスがフォルトによってオフしたり、GPIOが外部から"L"に引き下げられ、デバイスがこれに応答するようにプログラムされていた場合、出力は制御されたランプ動作を示す代わりにトライステート状態に移行します。この場合の出力は、負荷に応じて減衰します。

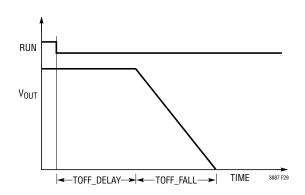


図29.TOFF_DELAYとTOFF_FALL



3887f

出力電圧は、デバイスが強制連続モードで動作し、十分に長 いTOFF FALL時間が設定されていて電力段が目標とする 勾配を実現できる場合は、図29のように動作します。TOFF FALL時間を満足できるのは、電力段とコントローラが十分な 電流をシンクでき、立ち下がり時間が終了するまでに出力を 確実に0Vまで低下させることができる場合だけです。TOFF FALL時間が負荷容量の放電に必要な時間よりも短いと、出 力は目標とするOV状態に到達しません。TOFF FALL時間が 経過すると、コントローラは電流のシンクを停止し、その後の VOLTは負荷インピーダンスで決まる速度で自然に減衰してい きます。コントローラが不連続モードで動作している場合、コ ントローラは負の電流を流さず、出力は電力段ではなく負荷 によって"L"に引き下げられます。立ち下がり時間の最大値は 1.3秒に制限されています。TOFF FALL時間を短く設定する ほど、TOFF FALLのランプはギザギザになります。ランプに は、TOFF FALL/0.1msの数だけステップが現れます。

INTVcc レギュレータ

LTC3887は V_{IN} 電源からINTV_{CC}に電力を供給する、NPNリニア・レギュレータを備えています。INTV_{CC}はゲート・ドライバ、 V_{DD33} 、およびLTC3887の内部回路のほとんどに電力を供給します。 V_{IN} が6.5Vより高いとき、リニア・レギュレータは、INTV_{CC}ピンの公称5Vの電圧を生成します。このレギュレータは100mAのピーク電流を供給可能であり、 1μ F以上のセラミック・コンデンサまたは低ESRの電解コンデンサでグランドにバイパスする必要があります。どのような種類のバルク・コンデンサをINTV_{CC}ピンとGNDピンのすぐ近くに接続することを強く推奨します。MOSFETゲート・ドライバが必要とする大きなトランジェント電流を供給し、チャネル間の相互作用を防ぐため、十分なバイパスが必要です。

大きなMOSFETが高い周波数で駆動される高入力電圧アプリケーションでは、LTC3887のダイ温度が上昇する場合があります。大部分がゲート充電電流からなるINTVCC電流は、内部の5Vリニア・レギュレータから供給されます。デバイスで消費される電力は、VIN・IINTVCCに等しくなります。「効率に関する検討事項」のセクションで説明されているように、ゲート充電電流は動作周波数に依存します。接合部温度は「電気的特性」のNote 2の式を使って推定できます。例えば、入力電源24Vで動作するLTC3887のINTVCC電流が69mA未満に制限されている場合の接合部温度は、次のように計算できます。

 $T_J = 70^{\circ}C + 69mA \cdot 24V \cdot 33^{\circ}C/W = 125^{\circ}C$

LTC3887のINTV $_{CC}$ を外部電源に接続しないでください(ただし、 V_{IN} もその電源に接続した場合を除きます)。INTV $_{CC}$ が外部電源を"H"に引き上げようとして電流制限に達し、ダイ温度を著しく高めるためです。

 V_{IN} が5Vのアプリケーションでは、 V_{IN} ピンとINTV_{CC}ピンを相互に接続し、結合されたこれらのピンを、図30に示すように1 Ω または2.2 Ω の抵抗を使って5V入力に接続します。ゲート充電電流による電圧降下を最小限に抑えるために、 V_{IN} /INTV_{CC}ピンに低ESRのコンデンサを接続する必要があります。この構成により、INTV_{CC}リニア・レギュレータを無効にし、INTV_{CC}が低くなりすぎないようにし、デバイスの消費電力を最小限に抑えます。INTV_{CC}電圧がMOSFETのR_{DS}(ON)テスト電圧(ロジック・レベルのデバイスの場合、標準4.5V)より高いことを確認してください。INTV_{CC}のUVLOは約4Vに設定されています。

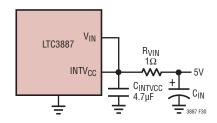


図30.5V入力に対する設定

上側 MOSFETドライバの電源(CB、DB)(LTC3887)

BOOSTピンに接続された外部ブートストラップ・コンデンサ CBは、トップサイドMOSFETにゲート・ドライブ電圧を供給 します。SWピンが"L"のとき、「ブロック図」のコンデンサCB がINTVCCから外付けダイオードDRを介して充電されます。 上側MOSFETの1つをオンさせるとき、ドライバは対象とな るMOSFETのゲート・ソース間にCBの電圧を印加します。 これによってMOSFETが導通し、上側のスイッチがオンしま す。スイッチ・ノード電圧SWはV_{IN}まで上昇し、それに従っ てBOOSTピンの電圧も上昇します。上側MOSFETがオンし ているとき、昇圧電圧は次のように入力電源より高くなりま す。V_{BOOST} = V_{IN} + V_{INTVCC}昇圧コンデンサC_Bには上側 MOSFETの全入力容量の100倍の値が必要です。外付け ショットキ・ダイオードの逆ブレークダウン電圧はVIN(MAX)よ り大きくなければなりません。ゲートの駆動レベルを調整する 場合の最終的な決定要因はレギュレータの全入力電流です。 変更を加えて入力電流が減少すれば、効率は向上していま す。入力電流に変化がなければ効率にも変化がありません。



 V_{IN}/V_{OUT} の比率が大きいデザイン中には、PWMジッタが観測されたものがありました。しかし、このジッタは回路の精度にさほど大きな影響を与えません。図 31を参照して、ダイオードのカソードとBOOSTnピンの間に $1\Omega \sim 5\Omega$ の直列抵抗を挿入すれば、PWMジッタは除去できます。ESLを減らして最適の結果を得るには、ケース・サイズが 0603 以上の抵抗を推奨します。

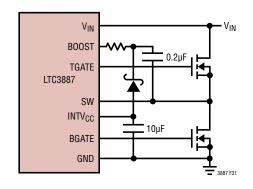


図31. PWM ジッタを最小限に抑える昇圧回路

低電圧ロックアウト

LTC3887は、内部しきい値に基づくUVLOによって初期化されます。その条件は、 V_{IN} が約4V、INTV_{CC}、 V_{DD33} 、 V_{DD25} がレギュレーション値の約20%以内にあることです。さらに、RUNピンが解放される前に、 V_{DD33} が目標値の約7%以内に入っていなければなりません。デバイス初期化の完了後、別のコンパレータが V_{IN} をモニタします。電源シーケンシングが開始されるには、 V_{IN} をモニタします。電源シーケンシングが開始されるには、 V_{IN} のしきい値を超える必要があります。 V_{IN} が V_{IN} OFFしきい値よりも低下すると、RUNピンが"L"に引き下げられます。コントローラが再起動するには、 V_{IN} が V_{IN} ONしきい値よりも高くなる必要があります。 V_{IN} が V_{IN} ONしきい値よりも高くなる必要があります。

VDD33電源を外部から駆動している場合、アプリケーション内でEEPROMの内容をプログラムできます。この構成では、高電圧部分を動作させずに、LTC3887のデジタル部分をアクティブにします。この電源構成ではPMBus通信が有効です。VINが印加されたことのないLTC3887では、MFR_COMMONのビット3(NVMが未初期化)が"L"にアサートされます。この状態が検出された場合、デバイスはアドレス5Aと5Bにしか応答しません。デバイスを初期化するには、次の一連のコマンドを発行します。グローバル・アドレス0x5B、コマンド0xBD、データ0x2Bに続いて、グローバル・アドレス5B、コマンド0xBD、データ0xC4。この操作によって、デバイスは正しいアドレスに応答するようになります。デバイスに必要な構成を設定し、STORE_USER_ALLを発行します。VINを印加したらMFR_RESETコマンドを発行して、PWMをイネーブルし、有効なADC変換を読み出せるようにする必要があります。

CINとCOUTの選択

2フェーズ・アーキテクチャと、入力回路(バッテリ/ヒューズ/コンデンサ)を流れるワーストケースRMS電流へのこのアーキテクチャの影響によって、CINの選択が簡単になります。コンデンサのRMS電流の最悪条件は、片方のコントローラだけが動作しているときです。最大RMSコンデンサ電流の条件を求めるには、VOUTとIOUTの積が最大になる方のコントローラを以下の式で使用する必要があります。他方のコントローラから供給される出力電流を増やすと、実際には入力のRMSリップル電流がこの最大値から減少します。逆位相方式では、1フェーズの電源ソリューションと比較すると、入力コンデンサのRMSリップル電流が一般に30%~70%ほど減少します。

連続モードでは、トップMOSFETのソース電流はデューティサイクルが V_{OUT}/V_{IN} の方形波になります。大きな電圧トランジェントを防止するには、1 チャネルの最大RMS 電流に対応するサイズの低ESR コンデンサを使用する必要があります。コンデンサの最大RMS 電流は次式で与えられます。

$$C_{IN}$$
 Required $I_{RMS} \approx \frac{I_{MAX}}{V_{IN}} [(V_{OUT})(V_{IN} - V_{OUT})]^{1/2}$



この式は $V_{IN}=2V_{OUT}$ のときに最大値になります。ここで、 $I_{RMS}=I_{OUT}/2$ です。設計では多くの場合、この単純なワーストケース条件が使用されます。条件を大きく振っても値は改善されないからです。コンデンサ・メーカーが定めるリップル電流定格は、多くの場合、わずか2000時間の動作寿命に基づいていることに注意が必要です。このため、コンデンサをさらにディレーティングする、つまり要件よりも高い温度定格のコンデンサを選択するようにしてください。設計でのサイズまたは高さの要件に適合させるため、複数のコンデンサを並列に接続できます。LTC3887は動作周波数が高いため、 C_{IN} にセラミック・コンデンサを使用することもできます。疑問点については、必ずメーカーに問い合わせてください。

LTC3887の2フェーズ動作のメリットは、電力の大きい方のコン トローラに対して上記の式を使用し、次に両方のコントローラの チャネルが同時にオンするとき生じると思われる損失を計算する ことによって推測することができます。両方のコントローラが動 作しているときは、入力コンデンサのESRを流れる電流パルスの オーバーラップが減るため、総RMS電力損失が減少します。こ れが、デュアル・コントローラの設計では、ワーストケースのコン トローラについて上式で計算した入力コンデンサの要件で十分 である理由です。さらに、2フェーズ・システムではピーク電流が 減少するため、入力保護ヒューズの抵抗、バッテリ抵抗、および PC基板のトレース抵抗による各損失も減少します。マルチフェー ズ設計の総合的なメリットが全て得られるのは、効率のテストに 電源/バッテリのソース・インピーダンスが含まれている場合だけ です。上側MOSFETのソースは互いに1cm以内に配置し、CIN を共有させます。ソースとCINを離すと、VINに望ましくない電圧 共振や電流共振が生じる可能性があります。

小さな $(0.1\mu F \sim 1\mu F)$ バイパス・コンデンサをLTC3887の近くに配置し、 $V_{\rm IN}$ ピンとグランドの間に挿入することを推奨します。 $C_{\rm IN}$ (C1) と $V_{\rm IN}$ ピンの間に抵抗 $(2.2\Omega \sim 10\Omega)$ を置くと2つのチャネル間の絶縁を強化できます。

 C_{OUT} は、等価直列抵抗(ESR)に基づいて選択します。一般に、ESRの要件が満たされていれば、その容量はフィルタリング機能にも十分です。出力リップル(ΔV_{OUT})は次式で近似できます。

$$\Delta V_{OUT} \approx I_{RIPPLE} \left(ESR + \frac{1}{8fC_{OUT}} \right)$$

ここで、fは動作周波数、COUTは出力容量、IRIPPLEはインダクタのリップル電流です。IRIPPLEは入力電圧に応じて増加するため、出力リップルは入力電圧が最大のときに最も大きくなります。

フォルト状態

LTC3887のGPIOnピンは、OV/UV、OC、OT、タイミング、ピーク過電流などの各種フォルトを示すように設定できます。さらに、GPIOnピンを外部ソースによって"L"に引き下げ、システムの他の部分で発生したフォルトを示すことも可能です。フォルトに対する応答は設定可能であり、次のようなオプションを選択できます。

- 無視
- 即時シャットダウン ラッチ・オフ
- 即時シャットダウン MFR_RETRY_DELAY で指定した インターバルで無期限のリトライ

詳細は、データシートのPMBusのセクション、およびPMBusの仕様を参照してください。

アナログOVに対する応答は自動的であり、事実上即時です。 OVが検出されると、TGが"L"に遷移しBGがアサートされます。

LTC3887ではフォルト・ログが可能です。フォルト・ログ機能は、デバイスのフォルト・オフを引き起こすフォルトが発生したときにデータを自動的に格納するように設定できます。フォルト・ログ・テーブルのヘッダ部分にはピーク値が格納されます。これらの値は、いつでも読み出すことができます。このデータはフォルトのトラブルシューティングに役立ちます。

LTC3887の内部温度が85°Cを超えている場合、EEPROMへの(フォルト・ログ記録以外の)書き込みは推奨されません。そのような場合でも、3.3V電源がUVLOしきい値を下回っていなければデータはRAM内に保持されます。ダイ温度が130°Cを超えると、あらゆる温度で有効なRESTORE_USER_ALLコマンドを除き、全てのEEPROM通信はダイ温度が125°C未満に低下するまでディスエーブルされます。

オープンドレイン・ピン

LTC3887には、次のオープンドレイン・ピンがあります。

3.3Vピン

- 1. $\overline{\text{GPIO}}n$
- 2. SYNC
- 3. SHARE CLK

LINEAR

5Vピン(5Vピンは3.3Vに引き下げられても正常に動作します。)

- 1. RUNn
- 2. ALERT
- 3. SCL
- 4. SDA

上記のピンには、いずれも0.4Vで3mAをシンクできる内蔵プルダウン・トランジスタが接続されています。ピンの"L"しきい値は1.4Vであることから電流3mAのデジタル信号に対して十分なマージンが確保されています。3.3Vピンの場合、3mAの電流は1k抵抗によって得られます。プルアップ抵抗やグランドへの寄生容量のRC時定数に伴うトランジェント速度が問題にならないならば、通常、10k以上の抵抗を推奨します。

SDA、SCL、SYNCなどの高速の信号には、より小さな値の抵抗が必要になる可能性があります。タイミングの問題を避けるために、RC時定数は必要な立ち上がり時間の1/3~1/5にしてください。負荷が100pF、PMBusの通信速度が400kHzの場合、立ち上がり時間は300ns未満でなければなりません。時定数を立ち上がり時間の1/3に設定したSDAおよびSCLピンのプルアップ抵抗の値は、次式で計算できます。

$$R_{PULLUP} = \frac{t_{RISE}}{3 \cdot 100pF} = 1k$$

通信の問題を防ぐために、SDAとSCLピンの寄生容量は可能な限り小さくなるように注意してください。負荷容量を見積もるには、対象となる信号をモニタし、目的の信号が出力値の約63%に達するまでにどれくらいの時間がかかるかを測定します。これが時定数の1単位になります。

SYNC ピンには、公称500nsの間、出力を"L"に保持する内蔵 プルダウン・トランジスタが接続されています。内部発振器が 500kHzに設定され、負荷が100pF、3単位の時定数が必要 な場合、抵抗は次のように計算できます。

$$R_{PULLUP} = \frac{2\mu s - 500ns}{3 \cdot 100pF} = 5k$$

最も近い1%抵抗は4.99kです。

タイミング誤差が発生する場合、またはSYNC周波数に必要な速度が得られない場合は、波形をモニタし、RC時定数がアプリケーションに対して長すぎないかを判断します。可能ならば、寄生容量を低減します。それが困難な場合は、適切な

タイミングが得られるようにプルアップ抵抗を十分に小さくします。SHARE_CLKのプルアップ抵抗は、周期を10μs、プルダウン時間を1μsとして、同じ式で計算されます。RC時定数は、約3μs以下にする必要があります。

フェーズロック・ループと周波数同期

LTC3887には内部の電圧制御発振器(VCO)と位相検出器によって構成されるフェーズロック・ループ(PLL)が内蔵されています。PLLはSYNCピンの立ち下がりエッジにロックされます。チャネル0、チャネル1およびSYNCの立ち下がりエッジの間の位相関係は、MFR_PWM_CONFIG_LTC3887コマンドの下位3ビットで制御されます。PolyPhaseアプリケーションでは、全ての位相を等間隔に離すことを推奨します。したがって、2フェーズのシステムでは信号間の位相差を180°に、4フェーズのシステムでは90°にします。

位相検出器はエッジに反応するデジタル・タイプで、外部発振器と内部発振器の位相シフトを既知の値に設定します。この種の位相検出器は、外部クロックの高調波に誤ってロックすることがありません。

位相検出器の出力は、内部フィルタ・ネットワークを充放電する、1対の相補型電流源です。PLLロックの範囲は、250kHz~1MHzの間で保証されています。公称デバイスは、この範囲を超えても動作すると思われますが、これより広い周波数範囲での動作は保証されていません。

PLLにはロック検出回路があります。動作中にPLLのロックが外れた場合、STATUS_MFR_SPECIFICコマンドのビット4がアサートされ、ALERTピンが"L"に引き下げられます。このフォルトは、上記のビットに1を書き込むことでクリアできます。PLL_FAULTの発生時にALERTピンをアサートさせたくない場合は、SMBALERT MASKコマンドを使用します。

アプリケーションでSYNC信号がクロック動作していない場合、設定された公称周波数がPWM回路を制御します。ただし、複数のデバイスがSYNCピンを共有している場合、SYNC信号がクロック動作していないと、各デバイスは同期せず、出力に過剰な電圧リップルが発生する恐れがあります。この状態が存在する場合、MFR_PADS_LTC3887のビット10が"L"にアサートされます。周波数コマンドを外部発振器に設定した場合、LTC3887のPWMエンジンはPLL発振器の最小自走周波数で動作します。これによって、過剰なインダクタ電流と望ましくない動作が発生する可能性があります。



PWM信号の動作周波数が高すぎると思われる場合は、SYNCピンをモニタします。立ち下がりエッジに余分な遷移が含まれると、PLLは目的とする信号ではなく、ノイズに対してロックしようとします。デジタル制御信号の配線を再確認し、SYNC信号に対するクロストークを最小限に抑えて問題を予防してください。PolyPhase構成では、複数のLTC3887の間でSYNCピンを共用する必要があります。その他の構成の場合は必要に応じて共用します。複数のLTC3887間でSYNCピンを共用する場合、SYNC出力をイネーブルに設定するLTC3887は1つだけにしてください。他の全てのLTC3887は、SYNC出力をディスエーブルするように設定してください。ただし、それらの周波数を目的の公称値に設定する必要があります。

最小オン時間に関する検討事項

最小オン時間ton (MIN)は、LTC3887が上側MOSFETをオンすることができる最小時間です。これは内部タイミング遅延と上側MOSFETをオンするのに必要なゲート電荷の量によって決まります。低デューティ・サイクルのアプリケーションでは、この最小オン時間の限度に接近する可能性があるので、次の条件を満たすように注意してください。

$$t_{ON(MIN)} < \frac{V_{OUT}}{V_{IN} \cdot f_{OSC}}$$

デューティ・サイクルが最小オン時間で対応可能な値より低くなると、コントローラはサイクル・スキップを開始します。出力電圧は引き続き安定化されますが、リップル電圧とリップル電流が増加します。

LTC3887の最小オン時間は(PCBレイアウトが適切であれば)約90ns、インダクタ電流リップルは最小で30%、電流検出信号のリップルは少なくとも10mV~15mVです。最小オン時間はPCBの電圧ループや電流ループのスイッチング・ノイズの影響を受けることがあります。ピーク電流検出電圧が低下するに従って最小オン時間は130nsまで徐々に増加します。これは、強制連続アプリケーションでリップル電流が小さく負荷が軽い場合に、特に懸念される点です。この状況でデューティサイクルが最小オン時間の限度を下回ると、大きなサイクル・スキップが発生する可能性があり、それに応じて電流リップルと電圧リップルが大きくなります。

RCONFIG(外付け抵抗構成設定ピン)

LTC3887のEEPROMのデフォルトは、RCONFIGピンを優先して参照するように設定されています。出力電圧、PWMの周波数や位相、およびアドレスを、ユーザーによるデバイスのプログラミングなしに設定したい場合、または特別にプログラム済みのデバイスを購入した場合は、RCONFIGピンによって、これらのパラメータを設定できます。RCONFIGピンは全て、LTC3887のVDD25とSGNDの間に抵抗分割器を必要とします。RCONFIGピンがモニタされるのは、初期の電源投入時とリセット時だけです。したがって、デバイスへの通電後に例えばA/Dなどによってこれらの値を変更しても、何の効果も得られません。適切な動作を確保するには、許容誤差1%以下の抵抗を使用する必要があります。また、これらのピンの近くにノイズの大きいクロック信号を配線しないでください。

電圧の選択

RCONFIGピンのVOUTn_CFGを使って出力電圧を設定した場合、以下のパラメータが出力電圧のパーセント値として設定されます。

•	VOUT_OV_FAULT_LIMIT	+10%
•	VOUT_OV_WARN	+7.5%
•	VOUT_MAX	+7.5%
•	VOUT_MARGIN_HIGH	+5%
•	VOUT_MARGIN_LOW	-5%
•	VOUT_UV_WARN	-6.5%
•	VOLIT LIV FALILT LIMIT	_7%

RCONFIGピンのVOUT n_C FGを使用して出力電圧を設定するには、表 12を参照してください。RTOPを V_{DD25} とこのピンの間に接続し、RBOTTOMをこのピンとSGNDの間に接続します。適切な動作を確保するには、許容誤差 1%の抵抗を使用する必要があります。

出力電圧のセットポイントは次式で表されます。

 $V_{SFTPOINT} = VOUTn CFG$

例えば、VOUTn_CFGピンに24.9kのR_{TOP}と4.32kのR_{BOTTOM}を接続した場合、次のようになります。

 $V_{SETPOINT} = 0.75V$

LINEAR

出力のセットポイントが5Vの場合、VOUTn_CFGには10kのR_{TOP}と23.2kのR_{BOTTOM}を接続する必要があります。 VOUTが2.5ボルト以下の場合、低電圧レンジが使用されます。チャネル0または1に対する最大電圧コマンドは、VOUT_MARGIN_HIGHおよびVOUTを含む5.5Vです。

表12.VOUTn CFG

R _{TOP} (kΩ)	R _{BOTTOM} (kΩ)	V _{OUT} (V)	オン/オフ
0または開放	開放	NVM	NVM
10	23.2	5.0	オン
10	15.8	3.3	オン
16.2	20.5	2.5	オン
16.2	17.4	1.8	オン
20	17.8	1.5	オン
20	15	1.35	オン
20	12.7	1.25	オン
20	11	1.2	オン
24.9	11.3	1.15	オン
24.9	9.09	1.1	オン
24.9	7.32	1.05	オン
24.9	5.76	0.9	オン
24.9	4.32	0.75	オン
30.1	3.57	0.65	オン
30.1	1.96	0.6	オン
開放	0	NVM	オフ

表13. PHAS CFG

24				
$R_{TOP}(k\Omega)$	$R_{BOTTOM} \ (k\Omega)$	θsync ~ θo 位相差	θ sync~ θ 位相差	SYNC DIS/EN
0または開放	開放	NVM	NVM	NVM
10	23.2	NVM	NVM	NVM
10	15.8	NVM	NVM	NVM
16.2	20.5	120	300	ディスエーブル
16.2	17.4	60	240	ディスエーブル
20	17.8	120	240	ディスエーブル
20	15	0	120	ディスエーブル
20	12.7	0	240	ディスエーブル
20	11	90	270	ディスエーブル
24.9	11.3	0	180	ディスエーブル
24.9	9.09	120	300	イネーブル
24.9	7.32	60	240	イネーブル
24.9	5.76	120	240	イネーブル
24.9	4.32	0	120	イネーブル
30.1	3.57	0	240	イネーブル
30.1	1.96	90	270	イネーブル
開放	0	0	180	イネーブル

RCONFIG による周波数と位相の選択

周波数コマンドと位相コマンドは、RCONFIGピンまたはPMBusコマンドのいずれを使用する場合も、関連がありません。出力を生成するのに複数のLTC3887を使用するPolyPhase構成では、SYNCピンを共有する必要があります。構成がPolyPhaseでなければSYNCピンを共有する必要はありません。SYNCピンを複数のLTC3887間で共有した場合、1つのSYNC出力のみをイネーブルし、他の全てのSYNC出力をディスエーブルする必要があります。SYNC出力をイネーブルした場合、オープンドレインのSYNCピンには、発振器周波数が存在します。SYNCピンには、VDD33へのプルアップ抵抗が必要です。

例えば、425kHzのクロックによって駆動される4位相構成の場合、全てのLTC3887を、目的の周波数と位相に設定し、1つのLTC3887を、SYNC出力をイネーブルして目的の周波数に設定する必要があります。全ての位相の基準は、SYNCの立ち下がりエッジです。

LTC3887デバイス1は、SYNC出力をイネーブルして、90°と 270°の位相シフトで周波数を425kHzに設定します。

周波数: $R_{TOP} = 24.9k\Omega$ 、 $R_{BOTTOM} = 4.32k\Omega$

位相: $R_{TOP} = 20k\Omega$ 、 $R_{BOTTOM} = 11k\Omega$

LTC3887 デバイス2 は、SYNC 出力をディスエーブルして、0°と 180°の位相シフトで周波数を425kHz に設定します。

周波数:24.9kΩおよびRBOTTOM = 4.32kΩ

位相: R_{TOP} は開放、R_{BOTTOM} = 0Ω

周波数および位相は、全てFREQ_CFGピンおよびPHAS_CFGピンによって構成できます。上記のアプリケーションでは、SYNCピンの接続がデバイス1から失われた場合、デバイス2が内部で周波数が失われたことを検出し、引き続き425kHzでスイッチングします。ただし、デバイス間でSYNCピンが切断されるため、出力電圧リップルが目的の値よりも高くなる可能性があります。デバイス2でMFR_PADSのビット10が"L"にアサートされ、外部からSYNCへの入力が期待されているときに、デバイス2がその内部発信器からクロックを供給していることを示します。



表14.FREQ CFG(SYNCの立ち下がりエッジを基準とした位相)

$R_{TOP}(k\Omega)$	$R_{BOTTOM}(k\Omega)$	周波数(kHz)
0または開放	開放	NVM
10	23.2	NVM
10	15.8	NVM
16.2	20.5	NVM
16.2	17.4	NVM
20	17.8	NVM
20	15	NVM
20	12.7	NVM
20	11	1000
24.9	11.3	750
24.9	9.09	650
24.9	7.32	575
24.9	5.76	500
24.9	4.32	425
30.1	3.57	350
30.1	1.96	250
開放	0	External Clock

RCONFIG によるアドレス選択

LTC3887のアドレスは、EEPROMに格納されたアドレス、ASEL0ピン、およびASLE1ピンの組み合わせによって選択されます。ASELの上位ビットは、EEPROM内の上位ビットまたはASEL1でデコードされた値のいずれかであり、下位ビットは、ASEL0でデコードされた値です。これにより、LTC3887は、単一の基板上で、EEPROMに設定された1つのアドレスを使用して、使用可能な全てのPMBusアドレスをデコードすることができます。基板上に16個以下のLTC3887が存在し、全てのLTC3887が同じ上位ビットアドレスを共有できる場合、ユーザーは抵抗をASEL0に接続するだけで済みます。

EEPROMに格納したアドレスが0x4Fの場合、ASEL0およびASEL1を使用して0x40~0x4Fのデバイス・アドレスを設定できます。(標準のデフォルト・アドレスは0x4Fです。)0x5Aまたは0x5Bのアドレスはいずれのデバイスにも割り当てないでください。これらはグローバル・アドレスであり、全てのデバイスが応答します。

アドレス0x40を選択するには、ASEL0の R_{TOP} は開放、 R_{BOTTOM} は 0Ω 、

ASEL1は開放とします。

アドレス 0x45 を選択するには、ASELO の R_{TOP} は 24.9k、R_{BOTTOM} は 7.32k、

ASEL1 は開放とします。

アドレス0x3Eを選択するには、ASEL0の R_{TOP} は10.0k、 $R_{BOTTOM} = 15.8k$ 、

ASEL1のRTOPは24.9k、RBOTTOMは4.32kとします。

表 15.ASELn 抵抗のプログラミング

		ASEL1		ASELO	
$R_{TOP}(k\Omega)$	$R_{BOT}(k\Omega)$	LTC3886 のデバイス・ アドレス・ビット [6:4]		LTC3886 のデバ アドレス・ビット	• • •
		バイナリ	16進	バイナリ	16進
0または開放	開放	NVM		NVM	
10	23.2			1111	F
10	15.8			1110	Е
16.2	20.5			1101	D
16.2	17.4			1100	С
20	17.8			1011	В
20	15			1010	А
20	12.7			1001	9
20	11			1000	8
24.9	11.3	111	7	0111	7
24.9	9.09	110	6	0110	6
24.9	7.32	101	5	0101	5
24.9	5.76	100	4	0100	4
24.9	4.32	011	3	0011	3
30.1	3.57	010	2	0010	2
30.1	1.96	001	1	0001	1
開放	0	000	0	0000	0

効率に関する検討事項

スイッチング・レギュレータのパーセント表示の効率は、出力電力を入力電力で割って100%を掛けたものに等しくなります。個々の損失を解析して、効率を制限する要素がどれであり、また何が変化すれば最も効率が改善されるかを判断できる場合がよくあります。パーセント表示での効率は、次式で表すことができます。

% 効率 = 100% - (L1 + L2 + L3 + ...)

ここで、L1、L2などは入力電力に対するパーセント値で表した個々の損失です。



表 15B¹.LTC3887の MFR_ADDRESS コマンドの例 (7ビットと8ビットの両アドレス指定について表示)

	デバイス・ アドレス (16進)		ビット								
説明	7ビット	8ビット	7	6	5	4	3	2	1	0	R/W
Rail ⁴	0x5A	0xB4	0	1	0	1	1	0	1	0	0
Global ⁴	0x5B	0xB6	0	1	0	1	1	0	1	1	0
デフォルト	0x4F	0x9E	0	1	0	0	1	1	1	1	0
Example 1	0x60	0xC0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Example 2	0x61	0xC2	0	1	1	0	0	0	0	1	0
Disabled ^{2,3,5}			1	0	0	0	0	0	0	0	0

Note 1: この表は、MFR_RAIL_ADDRESS コマンドとMFR_ADDRESS コマンドに適用される。 Note 2: 1つのコマンド内でディスエーブルに設定された値が、デバイスを無効にしたり、グローバル・アドレスを無効にすることはない。

Note 3:1つのコマンド内でディスエーブルに設定された値が、他のコマンドでアドレスを指定されたデバイスの応答を禁止することはない。

Note 4: MFR_ADDRESS または MFR_RAIL_ADDRESS コマンドに、0x00、0x0C(7 ビット) あるいは 0x5A または 0x5B (7 ビット) を書き込むことは推奨できない。

Note 5:アドレスを無効にするには、MFR_ADDRESS コマンドに0x80を入力する。0x80は7ビットのアドレス・フィールドよりも大きく、アドレスを無効にする。

回路内の電力を消費する全ての要素で損失が生じますが、LTC3887の回路の損失の大部分は、次の4つの主な損失要因によって生じます。1) デバイスの V_{IN} 電流、2) INT V_{CC} レギュレータの電流、3) I^2R 損失、4) 上側MOSFETの遷移損失です。

- 1. V_{IN} 電流は「電気的特性」の表に記載されているDC電源電流であり、これにはMOSFETドライバ電流や制御電流は含まれません。 V_{IN} 電流による損失は通常小さな値です(0.1%未満)。
- 2. INTV_{CC}電流は、MOSFETドライバ電流と制御電流の合計です。MOSFETドライバ電流は、パワーMOSFETのゲート容量をスイッチングすることによって流れます。MOSFETのゲートが"L"から"H"、そして再び"L"に切り替わる度に、INTV_{CC}からグランドに一定量の電荷dQが移動します。それによって生じるdQ/dtはINTV_{CC}から流出する電流であり、一般に制御回路の電流よりはるかに大きくなります。連続モードでは、IGATECHG = f(QT+QB)です。ここで、QTとQBはトップMOSFETとボトムMOSFETのゲート電荷です。

- 3. I²R 損失は、ヒューズ(使用する場合)、MOSFET、インダ クタ、電流検出抵抗の各DC抵抗から予測できます。連続 モードでは、LやR_{SENSE}に平均出力電流が流れますが、 上側MOSFETと同期MOSFETの間で「チョッピング」さ れます。2個のMOSFETのR_{DS}(ON)がほぼ同じ場合は、い ずれか一方のMOSFETの抵抗にLの抵抗とR_{SENSE}を 加算するだけでI²R損失を求めることができます。例えば、 各MOSFETの $R_{DS}(ON)$ が $10m\Omega$ 、 $R_{L} = 10m\Omega$ 、 R_{SENSE} $=5m\Omega$ であれば、全抵抗は $25m\Omega$ になります。この結果、 5V出力では出力電流が3Aから15Aまで増加すると損失 は2%~8%の範囲になり、3.3V出力では3%~12%の範 囲になります。外付け部品および出力電力レベルが同じ場 合、効率はVOUTの2乗に反比例して変化します。高性能 デジタル・システムでは低出力電圧と大電流がますます要 求されているので、その相乗効果により、スイッチング・レ ギュレータ・システムの損失項の重要性は倍増ではなく4 倍増となります。
- 4. 遷移損失は上側のMOSFETにのみ適用され、しかも高入力電圧(通常15V以上)で動作している場合にのみ大きくなります。遷移損失は次式から概算できます。

遷移損失 = (1.7) V_{IN}² I_{O(MAX)} C_{RSS} f

銅トレースや内部バッテリ抵抗など他の「隠れた」損失は、携帯用システムではさらに $5\%\sim10\%$ の効率低下を生じる可能性があります。これらの「システム」レベルの損失を設計段階で含めることが非常に重要です。内部バッテリとヒューズの抵抗損失は、スイッチング周波数において C_{IN} に適切な電荷を蓄積し、ESRを小さくすれば最小に抑えることができます。25W電源では、通常容量を $20\mu F\sim40\mu F$ 以上、ESRを $20m\Omega\sim50m\Omega$ 以下にする必要があります。LTC3887の2位相アーキテクチャの場合、通常必要な入力容量は競合製品に比べて半分になります。その他の損失(デッドタイム中のショットキ・ダイオードの導通損失やインダクタのコア損失など)は、合計しても一般には2%未満の損失増にしかなりません。

トランジェント応答の確認

レギュレータのループ応答は、負荷電流のトランジェント応答を調べることで確認できます。スイッチング・レギュレータは、DC(抵抗性)負荷電流のステップに応答するのに数サイクルを要します。負荷ステップが発生すると、VOUTはΔILOAD(ESR)に等しい大きさだけシフトします。ここで、ESRはCOUTの等価直列抵抗です。またΔILOADは、COUTの充電または放電を開始して、帰還誤差信号を発生します。この信号によりレ



ギュレータは、電流変化に適応してVourを定常状態の値に 戻すよう強制されます。この回復期間に、安定性に問題があ ることを示す過度のオーバーシュートやリンギングが発生し ないか、VOUTをモニタできます。ITHピンを備えているため、 制御ループの動作を最適化できるだけでなく、DC結合され、 ACフィルタを通した閉ループ応答のテスト・ポイントが与えら れます。このテスト・ポイントでのDCステップ、立ち上がり時 間、およびセトリングは、閉ループ応答を正確に反映します。2 次特性が支配的なシステムを想定すれば、位相余裕や減衰 係数は、このピンに現れるオーバーシュートのパーセンテー ジから概算できます。このピンの立ち上がり時間を調べること により、帯域幅も概算できます。「標準的応用例」の回路に示 すITHピンの外付け部品は、ほとんどのアプリケーションにお いて検討着手時の妥当な初期値として使えます。ループ利得 に影響を与えるプログラム可能なパラメータは2つだけです。 電圧レンジを決めるMFR PWM MODE LTC3887コマンド のビット1、および電流レンジを決めるMFR PWM MODE LTC3887コマンドのビット7です。補償の計算の前に、必ずこ れらのパラメータを確定しておいてください。

I_{TH}の直列R_C-C_Cフィルタにより、支配的なポール-ゼロ・ルー プ補償が設定されます。これらの値は、最終的なプリント基板 のレイアウトを完了し、特定の出力コンデンサの種類と容量値 を決定してからは、トランジェント応答を最適化するために多 少の(推奨値の0.5~2倍)変更が可能です。ループの利得と 位相は、出力コンデンサのさまざまな種類と値によって決まる ため、出力コンデンサを適切に選択する必要があります。立ち 上がり時間が1us~10usの最大負荷電流の20%~80%の 出力電流パルスによって発生する出力電圧波形とITHピンの 波形により、帰還ループを開くことなく全体的なループの安定 性を判断することができます。パワーMOSFETと出力コンデン サの両端に接地された抵抗を直接接続し、適当な信号発生 器でそのゲートを駆動するのが、負荷ステップを発生する実 用的な方法です。MOSFETとR_{SERIES}によって、およそV_{OUT}/ R_{SERIES}に等しい出力電流が生じます。R_{SERIES}には、電流制 限の設定とプログラムされた出力電圧に応じた、 $0.1\Omega \sim 2\Omega$ の値が妥当です。出力電流のステップ変化によって生じる初 期出力電圧ステップは帰還ループの帯域幅内にない場合が あるため、位相余裕を決定する際にこの信号を使用すること はできません。このため、ITHピンの信号を調べる方が確実で す。この信号は帰還ループ内にあり、フィルタされ、補償され た制御ループ応答です。ループの利得はRcを大きくすると増 加し、ループの帯域幅はCcを小さくすると広くなります。Ccを 減少させるのと同じ比率でRCを増加させると、ゼロの周波数 は変化しないため、帰還ループの最も重要な周波数範囲で 位相シフトが一定に保たれます。出力電圧のセトリング動作は閉ループ・システムの安定性に関係し、電源全体の実際の性能を表します。

次に、大容量の(>1μF)電源バイパス・コンデンサが接続されている負荷をスイッチングすると、さらに大きなトランジェントが発生します。放電しきったバイパス・コンデンサが実質的にCoutと並列接続状態になるため、Voutが急激に低下します。負荷スイッチの抵抗が小さく、かつ急速に駆動されると、どのようなレギュレータでも、出力電圧の急激なステップ変化を防止するだけ素早く電流供給を変えることはできません。CLOAD対Coutの比率が1:50より大きい場合は、スイッチの立ち上がり時間を制御して、負荷の立ち上がり時間を約25・CLOADに制限するようにしてください。そうすることにより、10μFのコンデンサでは250μsの立ち上がり時間が必要とされ、充電電流は約200mAに制限されるようになります。

プリント回路基板レイアウトのチェックリスト

プリント回路基板をレイアウトするときは、以下のチェックリストを使用して、このデバイスが正しく動作するようにします。これらの項目は図32のレイアウト図にも示してあります。連続モードで動作している2フェーズ同期式レギュレータの様々な枝路に現れる電流波形を図33に示します。レイアウトでは、以下の項目をチェックしてください。

- 1. 上側NチャネルMOSFETのM1とM2は互いに1cm以内に配置され、C_{IN}で共通ドレイン接続されていますか。2つのチャネルの入力デカップリングを分割すると大きな共振ループが形成されることがあるので、入力デカップリングは分割しないでください。
- 2. 信号グランドと電源グランドは分離されていますか。1つにまとめたこのデバイスの信号グランド・ピンとC_{INTVCC}のグランド・リターンは、1つにまとめたC_{OUT}の(-)端子に戻す必要があります。I_{TH}のトレースはできるだけ短くします。上側のNチャネルMOSFET、ショットキ・ダイオードおよびC_{IN}コンデンサで形成される経路のリードとPCトレースを短くします。コンデンサは互いに隣接させ、また上記のショットキ・ループからは離して配置し、出力コンデンサの(-)端子と入力コンデンサの(-)端子を可能な限り近づけて接続してください。

LINEAR TECHNOLOGY

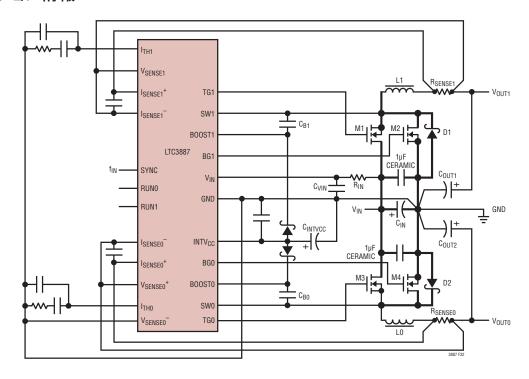


図32. プリント回路基板の推奨レイアウト図

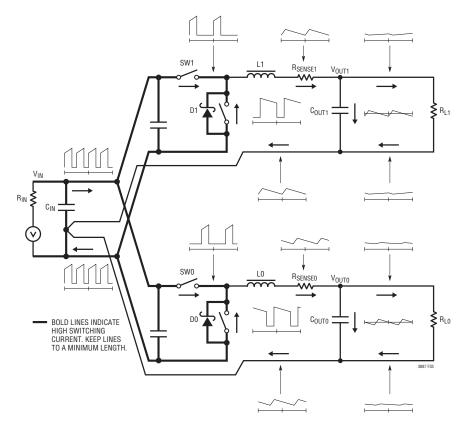


図33. 分岐電流の波形



- 3. LTC3887の V_{SENSE} ラインの電圧は V_{OUT} と同じですか。 V_{OUT0} は差動電圧です。 V_{OUT1} は、負荷1のグランドに接続されたGND(ピン41)を基準にする必要があります。
- 4. Isense⁺とIsense⁻のリードは、PCの最小トレース間隔で並走するように配線されていますか。Isense⁺とIsense⁻間のフィルタ・コンデンサは、デバイスにできるだけ近づけてください。検出抵抗またはインダクタのうち、いずれか電流検出に使用する素子に対してはケルビン接続を用い、正確に電流を検出できるようにします。
- 5. INTV_{CC}のデカップリング・コンデンサは、デバイスの近くでINTV_{CC}ピンと電源グランド・ピン間に接続されていますか。このコンデンサはMOSFETドライバのピーク電流を供給します。1μFのセラミック・コンデンサを1個、INTV_{CC}ピンとGNDピンのすぐ隣に追加すると、ノイズ性能を大幅に改善できます。
- 6. スイッチング・ノード(SW1、SW0)、上側ゲート・ノード(TG1、TG0)、およびブースト・ノード(BOOST1、BOOST0)は、敏感な小信号ノード、特に反対側のチャネルの電圧および電流検出帰還ピンから離してください。これら全てのノードの信号は非常に大きく高速に変化するので、LTC3887の出力側に置き、基板のトレース面積を最小限に抑えます。DCR検出を使用する場合、上側の抵抗(図18aのR1)をスイッチング・ノードの近くに配置します。
- 7. 改良型の「スター・グランド」手法を使用します。これは、入力コンデンサおよび出力コンデンサと同じ基板面に低インピーダンスの大きな銅領域の中央接地点を設け、ここにINTV_{CC}デカップリング・コンデンサの下側、電圧帰還抵抗分割器の下側、およびデバイスのGNDピンを接続する方法です。

PC 基板レイアウトのデバッグ

最初に1つのコントローラだけをオンします。回路をテストするとき、DC~50MHzの電流プローブを使用してインダクタの電流をモニタすることは有用です。出力スイッチング・ノード(SWピン)をモニタして、オシロスコープを内部発振器に同期させ、実際の出力電圧も調べてください。アプリケーションで予想される動作電圧および電流範囲で、適切な性能が達成されていることをチェックします。動作周波数は、ドロップアウト状態になるまでの全入力電圧範囲で一定に保たれている必要があります。

適切に設計によって実装された低ノイズのPCBにおいては、デューティ・サイクルのパーセンテージがサイクル間で変動しません。低調波の周期でデューティ・サイクルが変動する場合、電流検出入力または電圧検出入力でノイズを拾っているか、またはループ補償が適当でない可能性があります。レギュレータの帯域幅の最適化が不要であれば、ループの過補償を用いてPCレイアウトの不備を補うことができます。両方のコントローラを同時にオンするのは必ず各コントローラの個々の性能をチェックした後にしてください。特に条件の厳しい動作領域は、一方のコントローラ・チャネルが電流コンパレータの作動点に近づいているときに他方のチャネルが上側MOSFETをオンする場合です。これは内部クロックの位相同期のために、どちらかのチャネルのデューティ・サイクルが50%付近のとき発生し、デューティ・サイクルの小さなジッタを引き起こす可能性があります。

 V_{IN} をその公称レベルから下げて、ドロップアウト状態のレギュレータ動作を確認します。出力をモニタしながらさらに V_{IN} を下げて動作を確認し、低電圧ロックアウト回路の動作をチェックします。

問題があるのは出力電流が大きいときのみ、または入力電圧が高いときのみであるかどうかを調べます。入力電圧が高くかつ出力電流が小さいときに問題が発生する場合は、BOOST、SW、TG、場合によってはBGと、ノイズの影響を受けやすい電圧ピンおよび電流ピンとの間に容量性結合がないかを調べます。電流検出ピン間に接続するコンデンサは、デバイスのピンのすぐ近くに配置する必要があります。このコンデンサは、高周波容量性結合による差動ノイズの混入の影響を最小限に抑えるのに役立ちます。入力電圧が低く電流出力負荷が大きいときに問題が生じる場合は、CIN、ショットキ・ダイオード、および上側MOSFETと、影響を受けやすい電流および電圧検出トレースとの間に誘導性結合がないかを調べます。さらに、これらの部品とデバイスのGNDピンの間の、共通グランド経路の電圧ピックアップも調べてください。



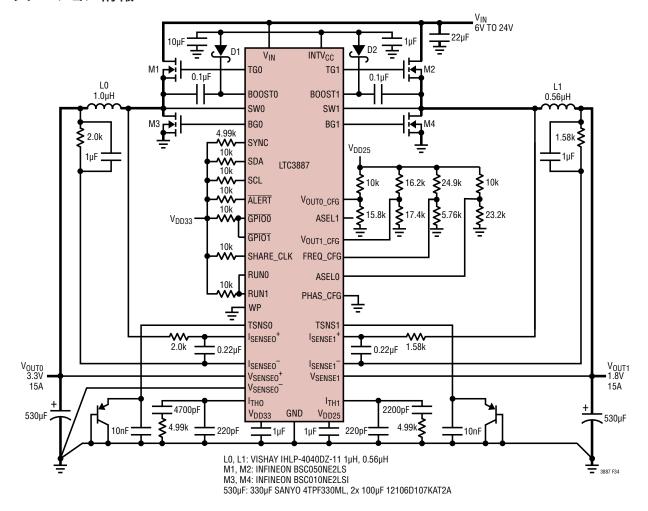


図34. 高効率のデュアル500kHz 3.3V/1.8V 降圧コンバータ

設計例

中程度の2チャネル電流レギュレータの設計例として、以下を仮定します: $V_{IN} = 12V$ (公称値)、 $V_{IN} = 20V$ (最大値)、 $V_{OUT0} = 3.3V$ 、 $V_{OUT1} = 1.8V$ 、 $I_{MAX0,1} = 15A$ 、およびf = 500kHz (図34参照)。

安定化出力は、EEPROMに格納されたVOUT_COMMAND または、次の値を持つ、V_{DD25}、RCONFIGピン、GND間の抵 抗分割器によって決まります。

- 1. $VOUT0_CFG$: $R_{TOP} = 10k$, $R_{BOTTOM} = 15.8k$
- 2. VOUT1_CFG: $R_{TOP} = 16.2k$, $R_{BOTTOM} = 17.4k$

周波数と位相は、EEPROMによって設定するか、V_{DD25}、FREQ_CFG、GNDの間、およびV_{DD25}、PHAS_CFG、GNDの間に次の抵抗分割器を接続することによって設定します。

周波数: $R_{TOP} = 24.9 k\Omega$ 、 $R_{BOTTOM} = 5.76 k\Omega$

位相:R_{TOP}=開放、R_{BOTTOM}=0Ω

アドレスはXFに設定します。XはEEPROMに格納された上位ビットです。

抵抗構成設定ピンによって出力電圧を決定している場合、以下のパラメータは出力電圧に対する比率(パーセント)として設定されます。

VOUT_OV_FAULT	_LIMIT+	-10%
VOUT_OV_WARN	+	7.5%
VOUT MAX	+	7.5%





VOUT_MARGIN_HIGH+5	%
VOUT_MARGIN_LOW5	%
VOUT_UV_WARN6.5	%
VOUT_UV_FAULT_LIMIT7	%

その他のユーザー定義パラメータは、全てEEPROMにプログラムする必要があります。GUIを使用すると、デバイスに必要な動作パラメータを簡単に設定できます。

インダクタンス値は最大35%のリップル電流(各チャネルにつき5.25A)の仮定に基づいています。リップル電流の最大値は、最大入力電圧で発生します。

$$L = \frac{V_{OUT}}{f \cdot \Delta I_{L(MAX)}} \left[1 - \frac{V_{OUT}}{V_{IN(MAX)}} \right]$$

チャネル0には1.05μH、チャネル1には0.624μHが必要になります。最も近い標準値は、それぞれ1μHおよび0.68μHです。 公称入力におけるリップル電流は次のように計算できます。

$$\Delta I_{L(NOM)} = \frac{V_{OUT}}{f \cdot L} \left[1 - \frac{V_{OUT}}{V_{IN(NOM)}} \right]$$

チャネル0のリップル電流は4.79A (32%)になり、チャネル1のリップル電流は5.5A (30%)になります。ピーク・インダクタ電流は、DCの最大値にリップル電流の1/2を加えた値(つまり、チャネル0の場合は17.39A、チャネル1の場合は17.75A)になります。チャネル1での最小オン時間は最大 V_{IN} で生じ、90ns より短くならないようにします。

$$t_{ON(MIN)} = \frac{V_{OUT}}{V_{IN(MAX)} \cdot f} = \frac{1.8V}{20V(500kHz)} = 180ns$$

チャネル0では Vishay IHLP4040DZ-11 1 μ H (25°Cで2.3m Ω のDCR $_{TYP}$)、チャネル1では Vishay IHLP4040DZ-11 0.56 μ H (25°Cで1.61m Ω のDCR $_{TYP}$)を選択します。

インダクタの温度測定が正確であり、C1を 0.2μ Fに設定したとすると、 R_D は無限大となり式から除外されます。

$$R0 = \frac{L}{(DCR \text{ at } 25^{\circ}C) \cdot C1} = \frac{1 \,\mu\text{H}}{2.3 \text{m}\Omega \cdot 0.22 \mu\text{F}} = 2\text{k}$$

ROによる最大電力損失はデューティ・サイクルと関係があり、 連続モード時の最大入力電圧で発生します。

$$P_{LOSS}R0 = \frac{\left(V_{IN(MAX)} - V_{OUT}\right) \cdot V_{OUT}}{R1}$$
$$= \frac{\left(20 - 3.3\right) \cdot 3.3}{2k} = 27.55 \text{mW}$$

チャネル1の各値は、R1 = 2k、R2は開放、 $P_{LOSS}R1 = 20.73$ mWです。

電流制限はピーク値よりも20%高い値に設定し、部品のばら つきやシステム内のノイズによって平均電流が制限されないよ うにします。

 $V_{ILIMIT} = I_{PEAK} \cdot R_{DCR(MAX)} = 17.39A \cdot 2.5m\Omega = 43mV$

この値に最も近い V_{ILIMIT} の設定は、42.9mVまたは46.4mVです。これらの値は、 $IOUT_OC_FAULT_LIMIT$ コマンドによって入力します。予想される変動と検出コンデンサの実験室における測定に基づいて、ユーザーは最適の設定を決定できます。チャネル1の場合、 V_{ILIMT} の値は28.6mVです。最も近い値は28.6mVです。

上側MOSFETの電力損失は容易に推定できます。上側 MOSFETとしてINFINEON BSC050NE2LSを選択します。 $R_{DS (ON)} = 5.7 m \Omega$ 、 $C_{MILLER} = 35 p F$ となります。最大入力電圧、推定温度50°C、下側MOSFETにINFINEON BSC010NE2LSI ($R_{DS (ON)} = 1.1 m \Omega$)を使用した場合、上側 MOSFETの損失は次のようになります。

$$P_{MAIN} = \frac{3.3V}{20V} \bullet (17.39)^2 \bullet \left[1 + (0.005)(50^{\circ}\text{C} - 25^{\circ}\text{C}) \right]$$
$$\bullet 0.0057\Omega + (20V)^2 (8.695\text{A}) \bullet \left(\frac{1}{5 - 2.3} + \frac{1}{2.3} \right)$$
$$(35\text{pF})(500\text{kHz}) = 0.369\text{W}$$

下側MOSFETの損失は、次のように計算できます。

$$P_{SYNC} = \frac{(20V - 3.3V)}{20V} \bullet (17.39A)^2 \bullet$$
$$\left[1 + (0.005)(50^{\circ}C - 25^{\circ}C) \right] \bullet 0.0011\Omega$$
$$= 0.312W$$

LINEAR TECHNOLOGY

 I^2R 損失は両方の MOSFET で発生しますが、 P_{MAIN} の式には 遷移損失の項が追加され、その値は入力電圧が高いときに 最大になります。

 C_{IN} は、次式で表される RMS 電流定格に適合するように選択します。

$$C_{IN}$$
 Required $I_{RMS} = \frac{17.39}{20} [(3.3) \cdot (20 - 3.3)]^{1/2}$
= 6.5A

ここで、温度は、チャネル0またはチャネル1のみがオンの場合を想定しています。 C_{OUT} は、出力リップルが小さくなるようにESRが 0.006Ω のものを選択します。連続モードでの出力リップルは、入力電圧が最大のときに最大になります。ESR による出力電圧リップルは、次のとおりです。

 $V_{ORIPPLE} = R(\Delta I_L) = 0.006\Omega \cdot 5.5A = 33mV$

設計に関するその他の確認事項

- GPIO0とGPIO1を相互に接続し、10kの抵抗を使用して V_{DD33}にプルアップします。
- RUN0とRUN1を相互に接続し、10kの抵抗を使用して V_{DD33}にプルアップします。
- 他のLTC PSMデバイスが存在する場合、RUNピンをデバイス間で接続し、GPIOピンをデバイス間で接続します。
- アプリケーションでは、必ず全てのPMBusピンを、抵抗を使用して V_{DD33} にプルアップし、これらの入力を全てのLTC PSMデバイス間で接続します。
- アプリケーションでは、SHARE_CLKを4.99kの抵抗に接続して V_{DD33} にプルアップし、全てのLTC PSMデバイス間で共有します。
- 各デバイスの一意のアドレスを、ASEL0ピンおよびASEL1 ピンを使用してデコードできるようにします。表 15を参照してください。
- 柔軟性を最大にするには、ASEL0やASEL1など、抵抗を使用して設定する全てのパラメータについて、 R_{TOP} と R_{BOTTOM} の基板面積を許容します。

USBからI²C/SMBus/PMBusへのコントローラを システム内のLTC3887へ接続

USBとI²C/SMBus/PMBusを接続するLTCコントローラは、プログラミング、テレメトリおよびシステム・デバッグのために、ユーザーの基板上のLTC3887との間のインタフェースを提供します。このコントローラをLTpowerPlayと併用すると、電源システム全体の強力なデバッグ手段になります。テレメトリ、フォルト・ステータス・レジスタおよびフォルト・ログを使って、短時間でフォルトを診断することができます。最終構成を短時間で開発し、LTC3887のEEPROMに格納できます。

システム電源の有無に関わらず、LTCのI²C/SMBus/PMBusコントローラを介して、1個または複数のLTC3887に対する給電、プログラミングおよび通信が可能な応用回路を図35に示します。システム電源が存在しない場合、 V_{DD33} 電源ピンからドングルによってLTC3887に給電します。 V_{IN} を印加せず、 V_{DD33} ピンが給電されているデバイスを初期化するには、グローバル・アドレス5B、コマンド0xBD、デー ϕ 0x2B、続いてアドレス5B、コマンド ϕ xBD、デー ϕ 0xC4を使用します。これによって、デバイスとの通信が可能になり、プロジェクト・ファイルが更新されます。更新されたプロジェクト・ファイルをEEPROMに書き込むには、STORE_USER_ALLコマンドを発行します。 V_{IN} を印加したらMFR_RESETコマンドを発行して、PWMをイネーブルし、ADCの有効な値を読み出せるようにする必要があります。

コントローラの電流ソース能力が制限されているため、LTC のドングルDC1613AからOR接続された3.3V電源からは、LTC3887、それらに関連したプルアップ抵抗、および I^2 Cのプルアップ抵抗だけに給電します。さらに、 I^2 Cバス接続をLTC3887と共有しているどのデバイスも、SDA/SCLピンとその V_{DD} ノードの間にボディ・ダイオードが形成されないようにします。これは、システム電源が存在しない場合にバス通信に干渉するからです。 V_{IN} が基板に印加されている場合、ドングルは基板上のLTC3887に給電しません。デバイスの構成が完了するまで負荷に電力が供給されないように、RUNピンを"L"に保持するか、電圧設定抵抗を挿入しないことを推奨します。

LTCのコントローラの Γ C接続は、LTCドングルDC1613Aを使用してPCのUSBから光絶縁されています。コントローラの3.3VとLTC3887の V_{DD33} ピンは、独立したPFETによって各LTC3887を駆動する必要があります。 V_{IN} を印加していない場合、内蔵LDOがオフしているため、 V_{DD33} ピンは並列にすることができます。DC1613Aの3.3Vの電流制限は100mAですが、 V_{DD33} の電流の標準値は15mA未満です。 V_{DD33} は INT V_{CC} ピンを逆ドライブします。通常、 V_{IN} が開放であれば、これは問題になりません。



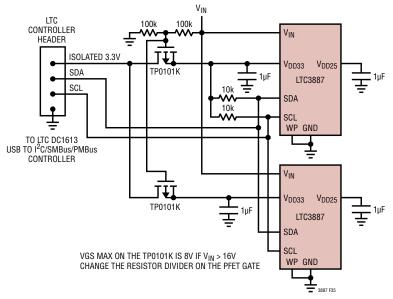


図35.LTCコントローラの接続

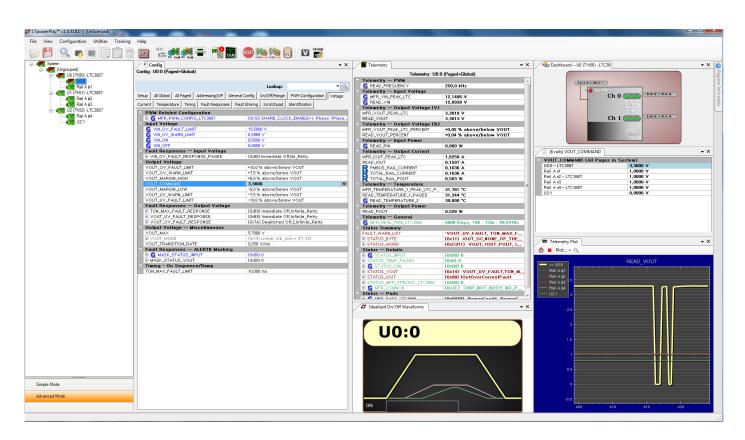


図36

LTpowerPlay: デジタル電源用の対話型 GUI

LTpowerPlay は、LTC3887をはじめとするリニアテクノロジー 社のデジタル・パワーICをサポートする、Windows ベースの 強力な開発環境です。このソフトウェアは、さまざまな作業を 幅広く支援します。LTpowerPlayにデモ・ボードやユーザー・ アプリケーションを接続することで、リニアテクノロジーのIC を評価できます。LTpowerPlayはオフライン・モード(ハード ウェア不要)による使用も可能です。このモードは、保存して おいて後ほど再度読み込むことができる、複数のIC構成ファ イルを作成するために使用します。過去に例のない高度な 診断とデバッグ機能も装備されました。いまや基板開発時 の電源システムのプログラムや調整、あるいは電源レール開 発時の電源に関する問題の診断における、貴重な診断ツー ルとなりました。LTpowerPlayは、DC1590B-A/Bデモ・ボー ド、DC1709Aソケット付きプログラミング・ボード、顧客ター ゲット・システムをはじめとする多くの潜在的ターゲットの1つ と、リニアテクノロジー社のUSB-to-I²C/SMBus/PMBusコン トローラを介して通信します。このソフトウェアは、最新のデ バイス・ドライバやマニュアルとともにリビジョンを常に最新 に保つ自動更新機能も備えています。LTpowerPlayでは、い くつかのチュートリアルのデモを含む、充実したコンテキス ト対応のヘルプを利用することができます。詳細な情報は、 http://www.linear-tech.co.jp/ltpowerplayより入手できます。

PMBus の通信とコマンド処理

LTC3887は、サポート対象コマンドのそれぞれに対して最後に書き込まれたデータを処理前に保持しておく深さ1のバッファを備えています(図37「書き込みコマンドのデータ処理」参照)。デバイスは、バスから新しいコマンドを受信すると、そのデータを書き込みコマンド・データ・バッファにコピーします。次に内部プロセッサに対して、このコマンド・データのフェッチが必要であることを知らせ、さらにコマンドを実行できるように内部形式に変換します。

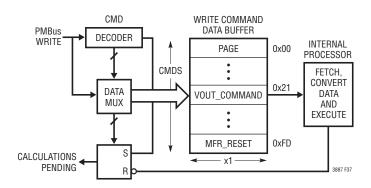


図37. コマンド・データ書き込み処理

2つの独立した並列ブロックがコマンドのバッファ入出力とコマンド処理(フェッチ、変換、実行)を管理するため、いかなるコマンドであれ最後に書き込まれたデータは決して失われることがありません。このバッファ入出力動作では、受信されるPMBus書き込みを処理するために、書き込みコマンド・データ・バッファにコマンド・データを格納し、将来の処理に備えてそれらにマークを付けます。内部プロセッサは並列動作することで、処理が必要としてマークされたコマンドのフェッチ、変換、実行など、低速となる可能性のあるタスクに対処します。

計算の比重が大きいコマンド(例:タイミング・パラメータ、温度、電圧と電流)の一部では、内部プロセッサの処理時間がPMBusのタイミングに比べて長くなる場合があります。コマンド処理のためにデバイスがビジーの間に新たなコマンドが受信されると、実行が遅延されたり、受信とは異なる順序で処理される場合があります。デバイスは、内部で計算処理中であることを、MFR_COMMONのビット5(「計算は保留中ではない」)によって表示します。デバイスが計算のためにビジーである間、ビット5はクリアされます。このビットがセットされた時点で、デバイスは新たなコマンドを実行できるようになります。図37にポーリング・ループの例を示します。コマンドが確実に順序どおり処理されるようにするとともに、エラー処理ルーチンを簡素化するループです。



デバイスはビジー中に新しいコマンドを受信すると、ビジー状態であることを標準PMBusプロトコルによって知らせます。デバイスの構成に応じて、コマンドに対してNACKを返すか、読み出しのために全て1 (0xFF)を返します。BUSYフォルトの生成とALERT通知、またはSCLクロック"L"のストレッチも行うことができます。詳細については、『PMBus Specification v1.2、Part II、Section 10.8.7』および『SMBus v2.0 section 4.3.3』を参照してください。クロック・ストレッチは、MFR_CONFIG_ALL_LTC3887のビット1をアサートすることによってイネーブルできます。クロック・ストレッチが行われるのは、この機能がイネーブルされ、かつバス通信速度が100kHzを超えている場合だけです。

PMBusのビジー・プロトコルは広く受け入れられた規格ですが、書き込みのシステム・レベル・ソフトウェアがある程度複雑化する可能性があります。このデバイスには3つの「ハンドシェイク」ステータス・ビットがあり、これによって信頼性の高いシステム・レベルの通信が可能になる一方で、複雑さが軽減されます。

これら3つのハンドシェイク・ステータス・ビットはMFR COMMONレジスタ内にあります。内部動作の実行によってビ ジーの間、デバイスはMFR COMMONのビット6(「チップはビ ジーではない」)をクリアします。特にVOUTが遷移状態(マー ジン・ハイ/ロー切り換え、電源オフ/オン、新しい出力電圧セッ トポイントへの移行など)にあることでビジーな場合、MFR COMMONのビット4(「出力は遷移中でない」)がクリアされ ます。内部計算が進行中の時は、MFR COMMONのビット5 (「計算は保留されていない」)がクリアされます。これら3つの ステータス・ビットは、3つのビット全てが設定されるまで、MFR COMMON レジスタの PMBus 読み出しバイトによってポーリング することができます。ステータス・ビットがセットされた直後のコ マンドは、NACK 応答またはBUSY フォルト/ALERT 通知を生 成することなく、受け入れられます。ただし、PMBus仕様が要 求する他の理由によってコマンドにNACK応答が返される可能 性はあります(例えば、無効なコマンドやデータなど)。VOUT COMMANDレジスタに対する信頼性の高いコマンド書き込み アルゴリズムの例を図38に示します。

// wait until bits 6, 5, and 4 of MFR_COMMON are all set do $\{$

mfrCommonValue = PMBUS_READ_BYTE(0xEF); partReady = (mfrCommonValue & 0x68) == 0x68; }while(!partReady)

// now the part is ready to receive the next command PMBUS_WRITE_WORD(0x21, 0x2000); //write VOUT_COMMAND to 2V

図38. VOUT_COMMANDのコマンド書き込みの例

全てのコマンド書き込み(バイト書き込み、ワード書き込みなど)の前には、ビジー動作や不要な ALERT 通知を扱うことによって処理がより複雑になるのを避けるために、ポーリング・ループを使用することを推奨します。これを簡単に実現するには、SAFE_WRITE_BYTE()および SAFE_WRITE_WORD()サブルーチンを作成します。上記のポーリング・メカニズムにより、ソフトウェアをクリーンかつシンプルに保ちながら、デバイスとの信頼性の高い通信を実現することができます。これらのトピックやその他の個々のケースに関する詳細な検討については、www.linear-tech.co.jp/designtools/app_notesのアプリケーションノートのセクションを参照してください。

100kHz以下のバス・スピードで通信する場合、ここに示したポーリング・メカニズムは、クロック・ストレッチなしで信頼性の高い通信を確保する、簡単な解決策となります。バス・スピードが100kHzを超える場合は、デバイスをクロック・ストレッチ可能に構成することを強く推奨します。これには、クロック・ストレッチをサポートするPMBusマスタが必要です。通信を行うには、「PMBus Specification v1.2, Part II, Section 10.8.7」に記載された方法で標準のPMBus NACK/BUSYフォルトを検出し、適切に復帰できるシステム・ソフトウェアが必要です。

バス・スピードが400kHzを超えるアプリケーションでは、LTC3887は推奨されません。

LINEAR TECHNOLOGY

アドレス指定および書き込み保護

コマンド名	CMD コード	説明	タイプ	ページ 指定	データ 形式	単位	NVM	デフォルト 値
PAGE	0x00	いずれかのページ設定コマンドに現在選択されている チャネル(ページ)。	R/W Byte	N	Reg			0x00
PAGE_PLUS_WRITE	0x05	指定のページにコマンドを直接書き込む。	W Block	N				
PAGE_PLUS_READ	0x06	指定のページからコマンドを直接読み取る。	Block R/W Process	N				
WRITE_PROTECT	0x10	意図しない PMBus 変更からデバイスを保護する。	R/W Byte	N	Reg		•	0x00
MFR_ADDRESS	0xE6	右ぞろえした7ビットのデバイス・アドレスを指定する。	R/W Byte	N	Reg		•	0x4F
MFR_RAIL_ADDRESS	0xFA	PolyPhase出力を構成するチャネルに対して、 右ぞろえした独自の7ビット・アドレスを指定する。	R/W Byte	Y	Reg		•	0x80

関連コマンド: MFR_COMMON。

PAGE

PAGEコマンドには、MFR_ADDRESSまたはGLOBALデバイス・アドレスのいずれか一方の物理アドレスだけで両方のPWMチャネルの構成、制御、およびモニタを行う機能があります。各PAGEには、一方のPWMチャネルの動作メモリが含まれます。

ページ0x00および0x01は、それぞれこのデバイスのチャネル0およびチャネル1に相当します。

PAGEを0xFFに設定すると、以下のいずれかのページ設定コマンドが両方の出力に適用されます。PAGEを0xFFに設定すると、LTC3887は、PAGEを0x00(チャネル0)に設定した場合と同様に読み出しコマンドに対して応答します。

このコマンドは1バイトのデータを伴います。

PAGE PLUS WRITE

PAGE_PLUS_WRITEコマンドは、デバイス内にページを設定し、コマンドを送信して、その後コマンドのデータを1つの通信パケットで全て送信する方法を提供します。現在の書き込み禁止レベルによって許可されているコマンドは、PAGE_PLUS_WRITEを使用すれば送信できます。

PAGEコマンドで保存された値は、PAGE_PLUS_WRITEによる影響を受けません。PAGE_PLUS_WRITEを使用してページ設定以外のコマンドを送信する場合、Page Numberバイトは無視されます。

このコマンドはWrite Block プロトコルを使用します。2つのデータ・バイトがあるコマンドを送信するPAGE_PLUS_WRITEコマンドとPECの一例を図39に示します。

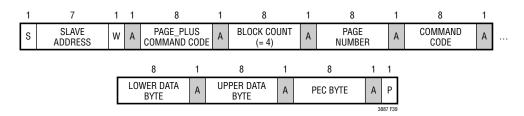


図39. PAGE_PLUS_WRITEの例



PAGE PLUS READ

PAGE_PLUS_READ コマンドは、デバイス内にページを設定し、コマンドを送信して、その後コマンドによって返されるデータを1つの通信パケットで全て読み取る機能を提供します。

PAGEコマンドで保存された値は、PAGE_PLUS_READによる影響を受けません。PAGE_PLUS_READを使用してページ設定以外のコマンドによりデータにアクセスする場合、Page Numberバイトは無視されます。

このコマンドはBlock Write – Block Read Process Callを使用します。PAGE PLUS READコマンドとPECの一例を図40に示します。

注記: PAGE_PLUS コマンドをネストすることはできません。PAGE_PLUS コマンドは、別のPAGE_PLUS コマンドの読み取りまたは書き込みに使用することはできません。これを試行すると、LTC3887はPAGE_PLUS パケット全体にNACKを返し、無効なデータ/サポートされていないデータに対してCMLフォルトを出します。

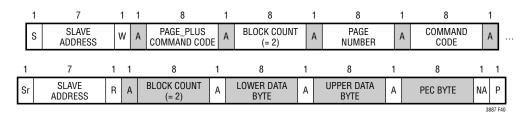


図40. PAGE PLUS READの例

WRITE_PROTECT

WRITE_PROTECT コマンドは、LTC3887デバイスへの書き込みを制御するために使用します。このコマンドは、MFR_COMMON コマンド内で定義されるWPピンの状態を表示するものではありません。WRITE_PROTECT コマンドがより厳格でない限り、WPピンの状態が、このコマンドの値よりも優先されます。

バイト	意味
0x80	WRITE_PROTECT、PAGE、MFR_EE_UNLOCK、STORE_USER_ALL コマンドに対する書き込みを除く、全ての書き込みを ディスエーブルする。
0x40	WRITE_PROTECT、PAGE、MFR_EE_UNLOCK、MFR_CLEAR_PEAKS、STORE_USER_ALL、OPERATION、およびCLEAR_FAULTSの各コマンドに対する書き込みを除く、全ての書き込みをディスエーブルする。個々のフォルト・ビットは、STATUSレジスタの対応するビットに1を書き込むことでクリアできる。
0x20	WRITE_PROTECT、OPERATION、MFR_EE_UNLOCK、MFR_CLEAR_PEAKS、CLEAR_FAULTS、PAGE、ON_OFF_CONFIG、VOUT_COMMAND、STORE_USER_ALLコマンドに対する書き込みを除く、全ての書き込みをディスエーブルする。個々のフォルト・ビットは、STATUSレジスタの対応するビットに1を書き込むことでクリアできる。
0x10	予約済み。0とする必要がある。
0x08	予約済み。0とする必要がある。
0x04	予約済み。0とする必要がある。
0x02	予約済み。0とする必要がある。
0x01	予約済み。0とする必要がある。

WRITE PROTECTを0x00に設定すると、全てのコマンドに対する書き込みがイネーブルされます。

このコマンドは1バイトのデータを伴います。



WPピンが"H"の場合、PAGE、OPERATION、MFR_CLEAR_PEAKS、MFR_EE_UNLOCK、CLEAR_FAULTS コマンドがサポートされます。個々のフォルト・ビットは、STATUS レジスタの対応するビットに1を書き込むことでクリアできる。

MFR ADDRESS

MFR_ADDRESS コマンド・バイトは、このデバイスの PMBus スレーブ・アドレスの 7 ビットを設定します。

このコマンドの値を0x80に設定すると、デバイス・アドレス指定がディスエーブルされます。グローバル・デバイス・アドレスである0x5Aと0x5Bはディスエーブルできません。RCONFIGを無視するように設定した場合も、ASEL0ピンとASEL1ピンは、チャネル・アドレスの下位ビットおよび上位ビットをそれぞれ決定するために使用されます。ASEL1ピンが開放の場合、LTC3887は EEPROMに格納されたMFR_ADDRESSの上位3ビットを使用します。ASEL0ピンが開放の場合、LTC3887は EEPROMに格納されたMFR_ADDRESSの下位4ビットを使用します。

このコマンドは1バイトのデータを伴います。

MFR RAIL ADDRESS

MFR_RAIL_ADDRES コマンドは、PAGEによってアクティブ化されたチャネルに対して、デバイス・アドレスによる直接アクセスを可能にします。このコマンドの値は、1つの電源レールに接続された全てのデバイスで共通でなければなりません。

ユーザーは、このアドレスに対して、コマンド書き込みだけを実行してください。このアドレスからの読み出しを実行した場合に、レール・デバイスが完全に同じ値で応答しないと、LTC3887はバス競合を検出して、CML通信フォルトをセットします。

このコマンドの値を0x80に設定すると、そのチャネルに対するレール・デバイス・アドレス指定がディスエーブルされます。

このコマンドは1バイトのデータを伴います。

汎用構成レジスタ

コマンド名	CMDコード	説明	タイプ	ページ 指定	データ 形式	単位	NVM	デフォルト 値
MFR_CHAN_CONFIG_LTC3887	0xD0	チャネル固有の構成ビット。	R/W Byte	Υ	Reg		Υ	0x1D
MFR_CONFIG_ALL_LTC3887	0xD1	全てのページで共通の構成ビット。	R/W Byte	N	Reg		Υ	0x01

MFR CHAN CONFIG LTC3887

複数のLTC製品に共通する汎用構成コマンドです。

ビット	意味
7	予備
6	予備
5	予備
4	RUNピンの"L"遷移をディスエーブルする。このビットをアサートすると、オフするように指示された場合も、RUNピンに"L"パルスが出力されない。
3	ショート・サイクル。 このビットをアサートすると、TOFF_DELAY または TOFF_FALL の待機中にオンするように指示された場合、 出力が直ちにオフする。 120ms の TOFF_MIN を遵守したうえで、デバイスはオンする。
2	SHARE_CLOCK制御。SHARE_CLOCKを"L"に保持すると、出力がディスエーブルされる。
1	GPIO ALERT を生成しない。GPIO が外部から"L"に引き下げられた場合、ALERT が"L"に引き下げられない。POWER_GOOD またはVOUT_UVUF のいずれかをGPIO 上に伝播する場合に、このビットをアサートする。
0	MFR_RETRY_TIME 処理の VOUT 減衰値の要件をディスエーブルする。このビットを0に設定した場合、レールをオフするあらゆるアクションにおいて、出力はプログラムされた値の 12.5% 未満に減衰しなければならない。ここでいう動作には、フォルト、OFF/ON コマンド、RUN の"H"-"L"-"H"トグルが含まれる。

このコマンドは1バイトのデータを伴います。



 $\overline{}$

MFR_CONFIG_ALL_LTC3887

複数のLTC製品に共通する汎用構成コマンドです。

ビット	意味
7	フォルト・ログをイネーブルする。
6	抵抗構成設定ピンを無視する。
5	予備
4	SYNC出力をディスエーブルする。
3	255msのタイムアウトをイネーブルする。
2	PMBus書き込みを受け付ける際に有効なPECを要求する。このビットがセットされていない場合、デバイスはPECが無効のコマンドも受け付ける。
1	PMBusクロック・ストレッチの使用を可能にする。
0	いずれかのRUNピンが"L"から"H"に遷移してCLEAR_FAULTSコマンドを 発行するのを可能にする。

このコマンドは1バイトのデータを伴います。

オン/オフ/マージン

コマンド名	CMD コード	説明	タイプ	ページ 指定	データ 形式	単位	NVM	デフォルト 値
ON_OFF_CONFIG	0x02	RUNピンおよび PMBus のオン/オフ・コマンドの構成。	R/W Byte	Υ	Reg		Υ	0x1E
OPERATION	0x01	動作モードの制御。オン/オフ、マージン・ハイおよびマージン・ロー。	R/W Byte	Y	Reg		Y	0x40
MFR_RESET	0xFD	パワーダウン不要のコマンドによるリセット。	Send Byte	N				NA

ON_OFF_CONFIG

ON_OFF_CONFIGコマンドは、デバイスのオン/オフに必要なRUNnピンの入力とシリアル・バス・コマンドの組み合わせを構成します。これには、電源が印加されたときのデバイスの応答方法も含まれます。

以下のビットだけが変更可能です。

- 3: シリアル・バスから受信したコマンドに対するデバイスの応答方法を制御します。
- 0: デバイスにオフするように指示するときのRUNピンの動作。ビット0を1に設定すると、デバイスは即座に出力段への電力伝送を停止します。これには、出力コンデンサを負荷によって放電する効果があります。ビット0を0に設定すると、レギュレータはプログラムされたターンオフ遅延と立ち下がり時間を適用します。デバイスが連続モードで動作している場合、プログラムされたターンオフ応答は、負荷から即座に電源を切り離したときよりも格段に速く出力を0Vまで引き下げることができます。

ビット4、2、1の値を変更すると、CMLフォルトが発生します。

このコマンドは1バイトのデータを伴います。

LINEAR

表3. ON_OFF_CONFIGレジスタの詳細情報 ON OFF CONFIGのデータの内容

ビット	シンボル	動作
b[7:5]	予備	ドントケア。常に0を返す。
b[3]	On_off_config_use_pmbus	シリアル・バスから受信したコマンドに対するデバイスの応答方法を制御する。
		0:デバイスはOPERATIONコマンドのb[7:6]を無視する。
		1: デバイスはOPERATION コマンドのb[7:6] に応答する。デバイスの起動にRUNn ピンのアサートも必要となる。
b[0]	On_off_config_control_fast_off	デバイスにオフするように指示するときの RUNn ピンのターンオフ動作。
		0:プログラムされたTOFF_DELAYを使用する。
		1:出力をオフし、可能な限り迅速にエネルギー伝送を停止する。デバイスは、 出力電圧の立ち下がり時間を短縮するための電流シンクを行わない。

Note:電力変換を開始するには、常にRUNピンが"H"でなければならない。電力変換は、RUNが"L"に遷移すると常に停止する。

OPERATION

OPERATIONコマンドは、RUNnピンからの入力と組み合わせて、デバイスをオン/オフするために使います。デバイスの出力電圧をマージン電圧のハイまたはローに設定する場合にも使用します。デバイスは、後続のOPERATIONコマンドかRUNnピンの状態遷移が他のモードへの変更を指示するまで、このコマンドによって指示された動作モードにとどまります。デバイスがMARGIN_LOW/HIGHステートで格納された場合は、次のRESETまたはPOWER_ONサイクルで、そのステートまでランプします。OPERATIONコマンドが変更された場合、例えばONがMARGIN_LOWに変更された場合、出力はVOUT_TRANSITION_RATEで設定された一定の勾配で変化します。デフォルトの動作コマンドはシーケンス・オフです。VINをデフォルトのデバイスに印加し、VOUT_CONFIG抵抗構成設定ピンを実装していない場合、出力がオフするように指示されます。電圧抵抗構成設定ピンを実装している場合、出力動作はオンに設定され、デバイスは、抵抗によって構成された出力電圧に安定化します。

LTC3887では、マージン・ハイ(フォルト無視)およびマージン・ロー(フォルト無視)動作はサポートされていません。

デバイスは、デフォルトでシーケンス・オフ状態になります。

このコマンドは1バイトのデータを伴います。

表 4. OPERATION コマンドの詳細情報 On_Off_Config_Use_PMBus が Operation_Control を イネーブルした場合の OPERATION コマンドのデータ内容

シンボル	動作	値
ビット		
機能	即座にオフ	0x00
	ターンオン	0x80
	マージン・ロー	0x98
	マージン・ハイ	0xA8
	シーケンス・オフ	0x40



チャネルのオン/オフ指示に OPERATION コマンドを使用しないように On_Off_Config を構成した場合の OPERATION コマンドのデータ内容

シンボル	動作	値
ビット		
	公称値で出力	0x80
機能	マージン・ロー	0x98
	マージン・ハイ	0xA8

注記:予約済みの値を書き込もうとするとCMLフォルトが発生する。

MFR_RESET

このコマンドは、ユーザーがLTC3887のリセット動作を実行する手段を提供します。

この書き込み専用コマンドにはデータ・バイトがありません。

PWM構成

コマンド名	CMD コード	説明	タイプ	ページ 指定	データ 形式	単位	NVM	デフォルト 値
MFR_PWM_MODE_ LTC3887	0xD4	各チャネルのPWMエンジンの設定。	R/W Byte	Υ	Reg		Υ	0x01
MFR_PWM_CONFIG_ LTC3887	0xF5	位相設定をはじめとするDC/DCコントローラの 多数のパラメータを設定する。	R/W Byte	N	Reg		Υ	0x10
FREQUENCY_SWITCH	0x33	コントローラのスイッチング周波数。	R/W Word	N	L11	kHz	Y	350 0xFABC

MFR PWM MODE LTC3887

MFR_PWM_MODE_LTC3887コマンドによって、ユーザーはPWMコントローラが不連続モード(パルス・スキップ・モード)または強制連続導通モードのいずれを使用するかをプログラムできます。このコマンドのビット7およびビット1は各チャネルのループ利得に影響を与えるため、外付けの補償ネットワークに変更が必要になる場合があります。

ビット	意味
7	I _{LIMIT} のレンジ 0 - 低電流レンジ 1 - 高電流レンジ
6	サーボ・モードをイネーブルする
5	予備
4	予備
3	予備
2	予備
1	電圧レンジ 0 - 高電圧レンジ(最大5.5V) 1 - 低電圧レンジ(最大2.75V)
0	PWMモード 0 - 不連続モード 1 - 連続モード



チャネルがランプ・アップするときは、このコマンドの値に関わらず、PWMモードは常に不連続になります。

このコマンドのビット7は、デバイスがIOUT_OC_FAULT_LIMITコマンドの高電流レンジまたは低電流レンジのいずれで動作するのかを決定します。このビットの値を変更すると、PWMループの利得と補償が変化します。出力がアクティブな状態でこのビットの値を変更すると、システムに有害な結果をもたらす可能性があります。

ビット6を0に設定すると、LTC3887がオフ、ランプ・オン、ランプ・オフ中にサーボ動作しません。1に設定すると、出力サーボがイネーブルされます。出力セットポイントDACは、READ_VOUT_ADCとVOUT_COMMAND(または該当するマージン設定値)の差を最小化するように、徐々に調整されます。

このコマンドのビット1は、デバイスが高電圧レンジまたは低電圧レンジのいずれで動作するのかを決定します。このビットの値を変更すると、PWMループの利得と補償が変化します。このビットの値は、出力がアクティブのときに変更できません。

このコマンドは1バイトのデータを伴います。

MFR PWM CONFIG LTC3887

MFR_PWM_CONFIG_LTC3887コマンドは、SYNC信号の立ち下がりエッジを基準としたスイッチング周波数の位相オフセットを設定します。このコマンドを処理するには、デバイスがOFFステートになければなりません。RUNピンを"L"にするか、デバイスにオフするように指示する必要があります。デバイスがRUNステートにある間にこのコマンドを書き込むと、無視されBUSYフォルトがアサートされます。ビット7によって、PolyPhaseレール・アプリケーションで、リモート差動電圧検出が可能になります。

ビット	意味				
7	EA接続				
	0 - 独立したEAおよびチャ				
	1 - PolyPhase動作の場合、	、EATかEAU人刀を使用			
6	予備。				
5	予備				
4	SHARE_CLKピンは"L"に引	> VIN_ONになるまで れない。V _{IN} < VIN_OFFの間、 き下げられる。このビット 加を除き、VIN < VIN_OFFで			
3	予備				
ビット[2:0]	チャネル0(度)	チャネル1(度)			
000b	0	180			
001b	90	270			
010b	0	240			
011b	0 120				
100b	120 240				
101b	60	240			
110b	120	300			

PolyPhaseアプリケーションでは、両方のV_{OUT}ピンを相互に接続し、両方のITHピンを相互に接続している場合にのみ、ビット7をアサートしてください。

このコマンドは1バイトのデータを伴います。



300/1

FREQUENCY_SWITCH

FREQUENCY_SWITCHコマンドは、PMBusデバイスのスイッチング周波数をkHz単位で設定します。

対応する周波数は次のとおりです。

值[15:0]	得られる周波数(TYP)
0x0000	外部発振器
0xF3E8	250kHz
0xFABC	350kHz
0xFB52	425kHz
0xFBE8	500kHz
0x023F	575kHz
0x028A	650kHz
0x02EE	750kHz
0x03E8	1000kHz

このコマンドを処理するには、デバイスがOFFステートになければなりません。RUNピンを"L"にするか、デバイスにオフするように指示する必要があります。デバイスがRUNステートにある間にこのコマンドを書き込むと、無視されBUSYフォルトがアサートされます。デバイスにオフを指示し、周波数を変更すると、PLLが新しい周波数にロックする際にPLL_UNLOCKステータスが検出される場合があります。

このコマンドは、Linear 5s 11s形式の2バイトのデータを伴います。

雷圧

入力電圧と制限値

コマンド名	CMDコード	説明	タイプ	ページ 指定	データ 形式	単位	NVM	デフォルト 値
VIN_OV_FAULT_LIMIT	0x55	入力電源の過電圧フォルト・リミット。	R/W Word	N	L11	V	Y	15.5 0xD3E0
VIN_UV_WARN_LIMIT	0x58	入力電源の低電圧警告リミット。	R/W Word	N	L11	V	Y	6.3 0xCB26
VIN_ON	0x35	デバイスが電力変換を開始する入力電圧。	R/W Word	N	L11	V	Y	6.5 0xCB40
VIN_OFF	0x36	デバイスが電力変換を停止する入力電圧。	R/W Word	N	L11	V	Υ	6.0 0xCB00

VIN_OV_FAULT_LIMIT

VIN_OV_FAULT_LIMITコマンドは、入力過電圧フォルトを発生する入力電圧の測定値をV単位で設定します。フォルトはA/Dコンバータによって検出されるため、最大120msのレイテンシが生じます。

このコマンドは、Linear_5s_11s形式の2バイトのデータを伴います。

VIN UV WARN LIMIT

VIN_UV_WARN_LIMITコマンドは、入力低電圧警告を発生する入力電圧の値を設定します。警告はA/Dコンバータによって 検出されるため、最大120msのレイテンシが生じます。

このコマンドは、Linear 5s 11s形式の2バイトのデータを伴います。

/ LINEAR

VIN ON

VIN_ONコマンドは、デバイスが電力変換を開始する入力電圧をV単位で設定します。 このコマンドは、Linear_5s_11s形式の2バイトのデータを伴います。

VIN_OFF

VIN_OFFコマンドは、デバイスが電力変換を停止する入力電圧をV単位で設定します。 このコマンドは、Linear_5s_11s形式の2バイトのデータを伴います。

出力電圧と制限値

コマンド名	CMDコード	説明	タイプ	ページ 指定	データ 形式	単位	NVM	デフォルト 値
VOUT_MODE	0x20	出力電圧の形式および指数(2-12)。	R Byte	Υ	Reg			2 ⁻¹² 0x14
VOUT_MAX	0x24	指示した出力電圧に対する VOUT_MARGIN_HIGHを含む上限。	R/W Word	Υ	L16	V	Y	5.6 0x599A
VOUT_OV_FAULT_ LIMIT	0x40	出力過電圧フォルト・リミット。	R/W Word	Υ	L16	V	Y	1.1 0x119A
VOUT_OV_WARN_ LIMIT	0x42	出力の過電圧警告リミット。	R/W Word	Y	L16	V	Y	1.075 0x1133
VOUT_MARGIN_HIGH	0x25	マージン・ハイの出力電圧設定ポイント。 VOUT_COMMANDよりも大きくなければ ならない。	R/W Word	Y	L16	V	Y	1.05 0x10CD
VOUT_COMMAND	0x21	公称出力電圧の設定ポイント。	R/W Word	Υ	L16	V	Y	1.0 0x1000
VOUT_MARGIN_LOW	0x26	マージン・ローの出力電圧設定ポイント。 VOUT_COMMANDよりも小さくなければ ならない。	R/W Word	Y	L16	V	Υ	0.95 0x0F33
VOUT_UV_WARN_ LIMIT	0x43	出力の低電圧警告リミット。	R/W Word	Υ	L16	V	Y	0.925 0x0ECD
VOUT_UV_FAULT_ LIMIT	0x44	出力低電圧フォルト・リミット。	R/W Word	Υ	L16	V	Y	0.9 0x0E66
MFR_VOUT_MAX	0xA5	VOUT_OV_FAULT_LIMITを含む最大許容出力 電圧。	R Word	Υ	L16	V		5.7 0x5B33

VOUT MODE

出力電圧の指示と読み出しに使用するVOUT_MODEコマンドのデータ・バイトは、3ビットのモード(リニア形式のみサポート)と、出力電圧の読み出し/書き込みコマンドで使用する指数を表す5ビットのパラメータから構成されます。

この読み出し専用コマンドは1バイトのデータを伴います。

VOUT MAX

VOUT_MAXコマンドは、VOUT_MARGIN_HIGHを含む任意の電圧の上限を設定します。デバイスは、他のいかなるコマンドまたはその組み合わせにも関係なく、この設定を指示できます。このコマンドの最大許容値は、5.7Vです。LTC3887が生成できる最大出力電圧は、VOUT_MARGIN_HIGHを含めて5.5Vです。ただし、VOUT_OV_FAULT_LIMITは、最大5.7Vまで指示できます。

このコマンドは、Linear_16u形式の2バイトのデータを伴います。



VOUT_OV_FAULT_LIMIT

VOUT_OV_FAULT_LIMITコマンドは、出力過電圧フォルトを発生する、検出ピンにおける出力電圧の測定値をV単位で設定します。

スイッチャがアクティブである間にVOUT_OV_FAULT_LIMITを変更した場合、新しい値が確実に設定されるように、コマンドの変更後 10ms 待機してください。デバイスは計算によるビジー状態を表示します。MFR_COMMONのビット5と6をモニタしてください。デバイスがビジーの場合、いずれかのビットが"L"になります。上記の待機時間を守らずに、VOUT_COMMANDを変更前の過電圧リミットよりも高い電圧に変更すると、一時的にOV状態が検出され、好ましくない動作をもたらしたり、スイッチャに損傷を与える恐れがあります。

VOUT_OV_FAULT_RESPONSEがOV_PULLDOWNに設定されている場合、VOUT_OV_FAULTが伝播されても、GPIOピンはアサートされません。LTC3887は、過電圧状態が検出されると、すぐにTGを"L"に引き下げ、BGビットをアサートします。

このコマンドは、Linear_16u形式の2バイトのデータを伴います。

VOUT_OV_WARN_LIMIT

VOUT_OV_WARN_LIMITコマンドは、出力過電圧警告を発生する、検出ピンにおける出力電圧の測定値をV単位で設定します。このリミットを超えたか否かの判断には、READ_VOUTの値を使用します。

VOUT OV WARN LIMITの超過に対して、デバイスは次のように応答します。

- STATUS_BYTEのNONE_OF_THE_ABOVEビットをセットする。
- STATUS WORDのVOUTビットをセットする。
- STATUS_VOUT コマンドの VOUT 過電圧警告ビットをセットする。
- マスクされていない限り、ALERTピンをアサートしてホストに通知する。

この状態はADCによって検出するため、最大120msの応答時間を要する場合があります。

このコマンドは、Linear_16u形式の2バイトのデータを伴います。

VOUT MARGIN HIGH

VOUT_MARGIN_HIGHコマンドは、OPERATIONコマンドが「マージン・ハイ」に設定された場合の、変更後の出力電圧をV単位でデバイスに読み込みます。この値はVOUT_COMMANDより大きくなければなりません。VOUT_MARGIN_HIGHに対する最大保証値は、5.5Vです。

このコマンドは、TON_RISEとTOFF_FALLの出力シーケンス実行中は処理されません。出力がアクティブな定常状態にある間に、このコマンドを変更すると、VOUT_TRANSITION_RATEが適用されます。

このコマンドは、Linear_16u形式の2バイトのデータを伴います。

VOUT COMMAND

 $VOUT_COMMAND$ は2バイトから構成され、出力電圧をV 単位で設定するために使用します。VOUT に対する最大保証値は、5.5Vです。

このコマンドは、TON_RISEとTOFF_FALLの出力シーケンス実行中は処理されません。出力がアクティブな定常状態にある間に、このコマンドを変更すると、VOUT_TRANSITION_RATEが適用されます。

このコマンドは、Linear 16u形式の2バイトのデータを伴います。

LINEAR

VOUT MARGIN LOW

VOUT_MARGIN_LOW コマンドは、OPERATION コマンドが「マージン・ロー」に設定された場合の、変更後の出力電圧をV単位でデバイスに読み込みます。この値はVOUT COMMANDより小さくなければなりません。

このコマンドは、TON_RISEとTOFF_FALLの出力シーケンス実行中は処理されません。出力がアクティブな定常状態にある間に、このコマンドを変更すると、VOUT_TRANSITION_RATEが適用されます。

このコマンドは、Linear_16u形式の2バイトのデータを伴います。

VOUT_UV_WARN_LIMIT

 $VOUT_UV_WARN_LIMIT$ コマンドは、出力低電圧警告を発生する、検出ピンにおける出力電圧の測定値をV単位で読み出します。

VOUT_UV_WARN_LIMITの超過に対して、デバイスは次のように応答します。

- STATUS_BYTE ONONE_OF_THE_ABOVE ビットをセットする。
- STATUS WORD O VOUT ビットをセットする。
- STATUS_VOUT コマンドの VOUT 低電圧警告ビットをセットする。
- マスクされていない限り、ALERTピンをアサートしてホストに通知する。

この状態はADCによって検出するため、最大120msの応答時間を要する場合があります。

このコマンドは、Linear_16u形式の2バイトのデータを伴います。

VOUT_UV_FAULT_LIMIT

VOUT_UV_FAULT_LIMITコマンドは、出力低電圧フォルトを発生する、検出ピンにおける出力電圧の測定値をV単位で読み出します。

このコマンドは、Linear 16u形式の2バイトのデータを伴います。

MFR_VOUT_MAX

MFR_VOUT_MAXコマンドは、VOUT_OV_FAULT_LIMITを含むチャネルごとの最大出力電圧(V単位)です。出力電圧を高電圧レンジに設定した場合(MFR_PWM_MODE_LTC3887のビット1を0に設定)、チャネル0とチャネル1のMFR_VOUT_MAXは5.7Vです。出力電圧を低電圧レンジに設定した場合(MFR_PWM_MODE_LTC3887のビット1を1に設定)、両方のチャネルのMFR_VOUT_MAXは2.75Vです。これより大きな値をVOUT_COMMANDの値に入力すると、CMLフォルトが発生し、出力電圧の設定は最大レベルにクランプされます。

この読み出し専用コマンドは、Linear 16u形式の2バイトのデータを伴います。

電流

入力電流の較正

コマンド名	CMDコード	説明	タイプ	ページ 指定	データ 形式	単位	NVM	デフォルト 値
MFR_IIN_OFFSET	0xE9	デバイスのIQを考慮するために 入力電流への追加に使用される係数。	R/W Word	Y	L11	А	Y	0.050 0x9333



3887f

MFR IIN OFFSET

MFR_IIN_OFFSET コマンドを使用して、各チャネルの静止電流を表す入力電流を設定できます。低出力電流において正確な結果を得るには、デバイスを連続導通モードで動作させる必要があります。

このコマンドは、Linear_5s_11s形式の2バイトのデータを伴います。

出力電流の較正

コマンド名	CMD コード	説明	タイプ	ページ 指定	データ 形式	単位	NVM	デフォルト 値
IOUT_CAL_GAIN	0x38	検出電流に対する電流検出ピンの電圧の比。 固定された電流検出抵抗を使用している デバイスの場合は mΩ単位の抵抗値となる。	R/W Word	Y	L11	mΩ	Y	1.8 0xBB9A
MFR_IOUT_CAL_GAIN_TC	0xF6	電流検出素子の温度係数。	R/W Word	Y	CF		Y	3900 0x0F3C

IOUT CAL GAIN

 $IOUT_CAL_GAIN$ コマンドは、電流検出抵抗の抵抗値を $m\Omega$ 単位で設定します。(MFR_IOUT_CAL_GAIN_TCも参照してください。)

このコマンドは、Linear_5s_11s形式の2バイトのデータを伴います。

MFR_IOUT_CAL_GAIN_TC

MFR_IOUT_CAL_GAIN_TCコマンドによって、ユーザーは検出抵抗IOUT_CAL_GAINまたはインダクタDCRの温度係数を、ppm/°C単位でプログラムできます。

このコマンドは、16ビットの2の補数の整数形式で表される2バイトのデータ(ppm)を伴います。 $N = -32768 \sim 32767 \cdot 10^{-6}$ 。公称温度は 27° Cであることから、 $IOUT_CAL_GAIN$ には次の係数が掛けられます。

[1.0 + MFR_IOUT_CAL_GAIN_TC・(READ_TEMPERATURE_1-27)]DCR 検出における標準値は3900です。

IOUT_CAL_GAINとMFR_IOUT_CAL_GAIN_TCは、次を含む全ての電流パラメータに影響を与えます: READ_IOUT、READ_IIN、IOUT_OC_FAULT_LIMIT、およびIOUT_OC_WARN_LIMIT。

入力電流

コマンド名	CMDコード	説明	タイプ	ページ 指定	データ 形式	単位	NVM	デフォルト 値
IIN_OC_WARN_LIMIT	0x5D	入力の過電流警告リミット。	R/W Word	N	L11	А	Y	10.0 0xD280

IIN_OC_WARN_LIMIT

IIN_OC_WARN_LIMITコマンドは、入力過電流警告を発生する入力電流の値をA単位で設定します。このリミットを超えたか否かの判断には、READ_IINの値を使用します。

IIN OC WARN LIMITの超過に対して、デバイスは次のように応答します。

- STATUS_BYTE OOTHER ビットをセットする。
- STATUS_WORD上位バイトのINPUTビットをセットする。

LINEAR

- STATUS_INPUT コマンドのIIN 過電流警告ビットをセットする。
- マスクされていない限り、ALERTピンをアサートしてホストに通知する。

この状態はADCによって検出するため、最大120msの応答時間を要する場合があります。

このコマンドは、Linear 5s 11s形式の2バイトのデータを伴います。

出力電流

コマンド名	CMDコード	説明	タイプ	ページ 指定	データ 形式	単位	NVM	デフォルト 値
IOUT_OC_FAULT_LIMIT	0x46	出力過電流フォルト・リミット。	R/W Word	Y	L11	A	Y	29.75 0xDBB8
IOUT_OC_WARN_LIMIT	0x4A	出力の過電流警告リミット。	R/W Word	Y	L11	А	Y	20.0 0xDA80

IOUT_OC_FAULT_LIMIT

IOUT_OC_FAULT_LIMITコマンドは、ピーク出力電流リミットをA単位で設定します。コントローラに電流制限が適用されている場合、過電流検出回路が過電流フォルト状態を表示します。過電流フォルト・リミットのプログラム値は、下表のディスクリートな値のいずれか最も近いものに丸められます。

25mV/IOUT_CAL_GAIN	低電流レンジ(1.5x公称ループ利得)
28.6mV/IOUT_CAL_GAIN	MFR_PWM_MODE_LTC3887 [7]=0
32.1mV/IOUT_CAL_GAIN	
35.7mV/IOUT_CAL_GAIN	
39.3mV/IOUT_CAL_GAIN	
42.9mV/IOUT_CAL_GAIN	
46.4mV/IOUT_CAL_GAIN	
50mV/IOUT_CAL_GAIN	
37.5mV/IOUT_CAL_GAIN	高電流レンジ(公称ループ利得)
42.9mV/IOUT_CAL_GAIN	MFR_PWM_MODE_LTC3887 [7]=1
48.2mV/IOUT_CAL_GAIN	
53.6mV/IOUT_CAL_GAIN	
58.9mV/IOUT_CAL_GAIN	
64.3mV/IOUT_CAL_GAIN	
69.6mV/IOUT_CAL_GAIN	
75mV/IOUT_CAL_GAIN	

Note: これは電流波形のピークです。READ_IOUTコマンドは、平均電流を返します。ピーク出力電流リミットは、次式を使い、MFR_IOUT_CAL_GAIN_TCの値に基づいて温度補正されます。

 $IOUT_OC_FAULT_LIMIT = IOUT_CAL_GAIN \cdot (1 + MFR_IOUT_CAL_GAIN_TC \cdot (READ_TEMPERTURE_1-27.0))$

LTpowerPlayのGUIは、自動的に電圧を電流に変換します。

IOUTのレンジは、MFR_PWM_MODE_LTC3887コマンドのビット7によって設定されます。

TON_RISEとTOFF_FALLの期間は、IOUT_OC_FAULT_LIMITを無視します。

このコマンドは、Linear_5s_11s形式の2バイトのデータを伴います。



IOUT OC WARN LIMIT

このコマンドは、出力過電流警告を発生する出力電流の値をA単位で設定します。このリミットを超えたか否かの判断には、 READ IOUTの値を使用します。

IOUT_OC_WARN_LIMITの超過に対して、デバイスは次のように応答します。

- STATUS_BYTE ONONE_OF_THE_ABOVE ビットをセットする。
- STATUS WORD の IOUT ビットをセットする。
- STATUS_IOUT コマンドのIOUT 過電流警告ビットをセットする。
- マスクされていない限り、ALERTピンをアサートしてホストに通知する。

この状態はADCによって検出するため、最大120msの応答時間を要する場合があります。

TON_RISEとTOFF_FALLの期間は、IOUT_OC_FAULT_LIMITを無視します。

このコマンドは、Linear_5s_11s形式の2バイトのデータを伴います。

温度

外部温度の較正

コマンド名	CMDコード	説明	タイプ	ページ 指定	データ 形式	単位	NVM	デフォルト 値
MFR_TEMP_1_GAIN	0xF8	外付け温度センサの勾配を設定する。	R/W Word	Y	CF		Υ	1 0x4000
MFR_TEMP_1_OFFSET	0xF9	外付け温度センサの-273.1℃を基準とした オフセットを設定する。	R/W Word	Y	L11	С	Y	0 0x8000

MFR TEMP 1 GAIN

MFR_TEMP_1_GAINコマンドは、素子の非理想性およびインダクタ温度を遠隔測定していることで生じる誤差を考慮して、外付け温度センサの勾配を補正します。

このコマンドは、16ビットの2の補数の整数形式で表される2バイトのデータを伴います。 $N=8192\sim32767$ 。実効的な補正値は $N\cdot 2^{-14}$ です。公称値は1です。

MFR_TEMP_1_OFFSET

MFR_TEMP_1_OFFSET コマンドは、素子の非理想性およびインダクタ温度を遠隔測定していることで生じる誤差を考慮して、外付け温度センサのオフセットを補正します。

このコマンドは、Linear_5s_11s形式の2バイトのデータを伴います。デバイスは、値-273.15から計算を開始するため、デフォルトの補正値は0です。

LINEAR

外部温度リミット

コマンド名	CMDコード	説明	タイプ	ページ 指定	データ 形式	単位	NVM	デフォルト 値
OT_FAULT_LIMIT	0x4F	外部過熱フォルト・リミット。	R/W Word	Y	L11	С	Υ	100.0 0xEB20
OT_WARN_LIMIT	0x51	外部過熱警告リミット。	R/W Word	Y	L11	С	Υ	85.0 0xEAA8
UT_FAULT_LIMIT	0x53	外部低温フォルト・リミット。	R/W Word	Y	L11	С	Υ	-40.0 0xE580

OT FAULT LIMIT

OT_FAULT_LIMIT コマンドは、過熱フォルトを発生する外部検出温度の値を°C単位で設定します。このリミットを超えたか否かの判断には、READ_TEMPERATURE_1の値を使用します。

この状態はADCによって検出するため、最大120msの応答時間を要する場合があります。

このコマンドは、Linear_5s_11s形式の2バイトのデータを伴います。

OT_WARN_LIMIT

OT_WARN_LIMITコマンドは、過熱警告を発生する外部検出温度の値を°C単位で設定します。このリミットを超えたか否かの判断には、READ_TEMPERATURE_1の値を使用します。

OT WARN LIMITの超過に対して、デバイスは次のように応答します。

- STATUS_BYTEのTEMPERATUREビットをセットする。
- STATUS_TEMPERATUREコマンドの過熱警告ビットをセットする。
- マスクされていない限り、ALERTピンをアサートしてホストに通知する。

この状態はADCによって検出するため、最大120msの応答時間を要する場合があります。

このコマンドは、Linear_5s_11s形式の2バイトのデータを伴います。

UT FAULT LIMIT

UT_FAULT_LIMITコマンドは、低温フォルトを発生する外部検出温度の値を℃単位で設定します。このリミットを超えたか否かの判断には、READ_TEMPERATURE_1の値を使用します。

注記:温度センサを実装していない場合、UT_FAULT_LIMITを-275°Cに、UT_FAULT_LIMIT応答を「無視」に設定することで、 ALERTがアサートされないようにすることができます。

この状態はADCによって検出するため、最大120msの応答時間を要する場合があります。

このコマンドは、Linear_5s_11s形式の2バイトのデータを伴います。



タイミング

タイミング - オン・シーケンス/ランプ

コマンド名	CMD コード	説明	タイプ	ページ 指定	データ 形式	単位	NVM	デフォルト 値
TON_DELAY	0x60	RUN および OPERATION (または、 そのいずれか) によるオンから、 出力レールのターンオンまでの時間。	R/W Word	Y	L11	ms	Y	0.0 0x8000
TON_RISE	0x61	出力の立ち上がり開始から、出力電圧が VOUTコマンドで指定された値に 達するまでの時間。	R/W Word	Y	L11	ms	Y	8.0 0xD200
TON_MAX_FAULT_LIMIT	0x62	TON_RISEの開始から、VOUTがVOUT_UV_ FAULT_LIMITをよぎるまでの最大時間。	R/W Word	Υ	L11	ms	Y	10.0 0xD280
VOUT_TRANSITION_RATE	0x27	VOUTに新しい値を指定したときに出力が変化する速度。	R/W Word	Υ	L11	V/ms	Y	0.25 0xAA00

TON_DELAY

TON_DELAY コマンドは、スタート条件を受信してから、出力電圧が立ち上がりはじめるまでの時間をms単位で設定します。有効な値の範囲は、0ms~83秒です。

このコマンドは、Linear 5s 11s形式の2バイトのデータを伴います。

TON_RISE

TON_RISEコマンドは、出力が立ち上がりはじめてから、レギュレーション範囲に入るまでの時間をms 単位で設定します。有効な値の範囲は、 $0\sim1.3$ 秒です。TON_RISEイベントの間、デバイスは不連続モードで動作します。TON_RISEが0.25ms より短い場合、LTC3887のデジタル・スロープ制御はバイパスされます。出力電圧の遷移はPWM スイッチャのアナログ性能で決まります。許容される勾配の最大値は4V/msです。

このコマンドは、Linear 5s 11s形式の2バイトのデータを伴います。

TON_MAX_FAULT_LIMIT

TON_MAX_FAULT_LIMIT コマンドは、出力電圧が低電圧フォルト・リミットに到達しないときに、デバイスがどれだけの時間パワーアップを試みるかをms単位で設定します。

データ値の0msは制限なしを意味します。つまり、デバイスは出力電圧の立ち上げを無期限で試みます。リミットの最大値は83秒です。

このコマンドは、Linear_5s_11s形式の2バイトのデータを伴います。

VOUT TRANSITION RATE

PMBus デバイスが、出力電圧を変化させる VOUT_COMMAND または OPERATION (マージン・ハイ、マージン・ロー) のいずれかを受信したときに、出力電圧が変化する速度を V/ms 単位で設定します。ここで指定した変化率は、デバイスにオン/オフするように指示した場合には適用されません。

0.1V/msよりも大きい値を推奨します。

このコマンドは、Linear_5s_11s形式の2バイトのデータを伴います。

LINEAR

タイミング - オフ・シーケンス/ランプ

コマンド名	CMD コード	説明	タイプ	ページ 指定	データ 形式	単位	NVM	デフォルト 値
TOFF_DELAY	0x64	RUNおよび OPERATION (またはそのいずれか) による オフから TOFF_FALL ランプの開始までの時間。	R/W Word	Υ	L11	ms	Υ	0.0 0x8000
TOFF_FALL	0x65	出力の立ち下がり開始から、出力がOVに 達するまでの時間。	R/W Word	Υ	L11	ms	Y	8.0 0xD200
TOFF_MAX_WARN_LIMIT	0x66	TOFF_FALLが完了してから、デバイスが 12.5%未満に減衰するまでの最大許容時間。	R/W Word	Y	L11	ms	Y	150 0xF258

TOFF DELAY

TOFF_DELAY コマンドは、ストップ条件を受信してから、出力電圧が立ち下がりはじめるまでの時間をms単位で設定します。 有効な値の範囲は、 $0 \sim 83$ 秒です。

このコマンドは、フォルト・イベントから除外されています。

このコマンドは、Linear 5s 11s形式の2バイトのデータを伴います。

TOFF_FALL

TOFF_FALLコマンドは、ターンオフ遅延時間の終了時点から、出力電圧のゼロが指示されるまでの時間をms単位で設定します。これは、VOUTDACのランプ時間です。VOUTDACが0になると、デバイスはトライステート状態に移行します。

デバイスは、プログラムされた動作モードを維持します。定義されたTOFF_FALLの期間は、デバイスを連続導通モードに設定してください。最大値を読み込むと、デバイスは可能な限り最大の時間をかけてランプ・ダウンします。サポートされる最短の立ち下がり時間は0.25msです。0.25msよりも小さな値を設定した場合は、0.25msでランプ・ダウンします。立ち下がり時間の最大値は1.3秒です。許容される勾配の最大値は4V/msです。

不連続導通モードの場合、コントローラは負荷からの電流を流さないため、立ち下がり時間は出力容量と負荷電流によって決まります。

このコマンドは、Linear 5s 11s形式の2バイトのデータを伴います。

TOFF_MAX_WARN_LIMIT

TOFF_MAX_WARN_LIMITコマンドは、デバイスがどれだけの時間出力のターンオフを試みた後に警告をアサートするかを ms 単位で設定します。Vout電圧が、プログラムされた VOUT_COMMAND の値の 12.5% を下回った時点を、出力のターンオフ完了と見なします。計算は、TOFF_FALLの完了後に開始されます。VOUT_DECAY がディスエーブルされている状態では、TOFF_MAX WARN はイネーブルされません。

データ値の0msは制限なしを意味します。つまり、デバイスは出力電圧のターンオフを無期限で試みます。有効な値は、0を除いた120ms~524秒です。

このコマンドは、Linear_5s_11s形式の2バイトのデータを伴います。

再起動の前提条件

コマンド名	CMD コード	説明	タイプ	ページ 指定	データ 形式	単位	NVM	デフォルト 値
MFR_RESTART_ DELAY	0xDC	RUNの実際のアクティブ・エッジからRUNの 仮想のアクティブ・エッジまでの遅延。	R/W Word	Y	L11	ms	Υ	500 0xFBE8



3887f

MFR RESTART DELAY

このコマンドは、RUNのオフ時間の最小値をms単位で指定します。デバイスは、RUNの立ち下がりエッジを検出すると、このコマンドで設定した時間だけRUNピンを"L"に保持します。設定の推奨最小値は136msです。

Note: 再起動遅延は、リトライ遅延とは異なります。再起動遅延では、指定された時間だけRUNを"L"に保持した後、標準の起動シーケンスを開始します。最小の再起動遅延は、TOFF_DELAY + TOFF_FALL + 136ms に等しくなります。有効な設定は、136ms~65.52秒の範囲の16ms刻みの値です。最小オフ時間を確保するために、MFR_RESTART_DELAYには目標値より16ms 長い時間を設定してください。MFR_CHAN_CONFIG_LTC3887の出力減衰ビット1がイネーブルに設定されていて、出力がプログラムされた値の12.5%未満まで減衰するのに長時間を要した場合は、RUNピンが"H"に引き上げられた後の出力レールのオフ期間がMFR_RESTART_DELAYの設定値よりも長くなる可能性があります。

このコマンドは、Linear 5s 11s形式の2バイトのデータを伴います。

フォルト応答

フォルト応答 - 全フォルト

コマンド名	CMDコード	説明	タイプ	ページ 指定	データ 形式	単位	NVM	デフォルト 値
MFR_RETRY_ DELAY	0xDB	フォルト再試行モードでの再試行間隔。	R/W Word	Υ	L11	ms	Y	350 0xFABC

MFR RETRY DELAY

このコマンドは、フォルト応答が、指定した間隔でコントローラにリトライ動作させる設定の場合に、その再起動間隔を ms 単位で設定します。このコマンドの値は、リトライを必要とする全てのフォルト応答に適用されます。リトライ時間は、障害のあるチャネルでフォルトが検出された時点を起点とします。有効な設定は、120ms ~83.88 秒の範囲の 10μs 刻みの値です。

Note: リトライの遅延時間は、MFR_RETRY_DELAYコマンドまたは安定化出力がプログラム値の12.5%未満に減衰するまでの時間の、いずれか長い方で決まります。出力が自然に減衰するまでの時間が長すぎる場合、MFR_CHAN_CONFIG_LTC3887のビット0をアサートすることでMFR_RETRY_DELAYコマンドの電圧要件を解除できます。

このコマンドは、Linear 5s 11s形式の2バイトのデータを伴います。

フォルト応答 - 入力電圧

コマンド名	CMD コード	説明	タイプ	ページ 指定	データ 形式	単位	NVM	デフォルト 値
VIN_OV_FAULT_RESPONSE	0x56	入力電源の過電圧フォルトが検出されたとき、 デバイスが取るアクション。	R/W Byte	Y	Reg		Y	0x80

VIN_OV_FAULT_RESPONSE

VIN_OV_FAULT_RESPONSEコマンドは、入力の過電圧フォルトに対する応答としてデバイスが取るべきアクションを指示します。データ・バイトは表9に示した形式です。

デバイスは、この設定に加えて以下の応答を示します。

- STATUS_BYTEのNONE_OF_THE_ABOVEビットをセットする。
- STATUS WORD上位バイトのINPUTビットをセットする。

LINEAR

- STATUS INPUT コマンドの VIN 過電圧フォルト・ビットをセットする。
- マスクされていない限り、ALERTピンをアサートしてホストに通知する。

このコマンドは1バイトのデータを伴います。

フォルト応答 - 出力電圧

コマンド名	CMD コード	説明	タイプ	ページ 指定	データ 形式	単位	NVM	デフォルト 値
VOUT_OV_FAULT_RESPONSE	0x41	出力過電圧フォルトが検出されたときの デバイスの動作。	R/W Byte	Υ	Reg		Υ	0xB8
VOUT_UV_FAULT_RESPONSE	0x45	出力低電圧フォルトが検出されたときの デバイスの動作。	R/W Byte	Υ	Reg		Υ	0xB8
TON_MAX_FAULT_ RESPONSE	0x63	TON_MAX_FAULTイベントが検出されたときの デバイスの動作。	R/W Byte	Υ	Reg		Y	0xB8

VOUT_OV_FAULT_RESPONSE

VOUT_OV_FAULT_RESPONSEコマンドは、出力の過電圧フォルトに対する応答としてデバイスが取るべきアクションを指示します。データ・バイトは表5に示した形式です。

デバイスは、この設定に加えて以下の応答を示します。

- STATUS_BYTEのVOUT_OVビットをセットする。
- STATUS WORDのVOUTビットをセットする。
- STATUS VOUT コマンドの VOUT 過電圧フォルト・ビットをセットする。
- マスクされていない限り、ALERTピンをアサートしてホストに通知する。

このコマンドは、以下に示す値のみを認識します。

0x80 - デバイスはシャットダウンし(出力をディスエーブル)、リトライは試みません。出力は、フォルトがクリアされるまでディスエーブルされたままになります(PMBus, Part II, Section 10.7)。

0xB8 - デバイスはシャットダウンし(出力をディスエーブル)、オフを指示されるか(RUNピンまたはOPERATIONコマンド、または両方による)、バイアス電源が遮断されるか、他のフォルト条件によってシャットダウンされるまで、リトライを継続して無期限に試みます。

0x4n - デバイスはシャットダウンし、リトライは試みません。デバイスが、オフに続いてオンするように指示されるか、RUNピンが "L"にアサートされた後に"H"にアサートされた場合、またはRESETコマンドの発行、VINの遮断のいずれかが発生するまで、出力はディスエーブルされたままになります。OVフォルトは $n \cdot 10\mu s$ の期間、アクティブを保つ必要があります。ここで、 $n \cdot t \cdot 0 \sim 7$ の値です。

0x78+n - デバイスはシャットダウンし、フォルト条件がクリアされるか、デバイスがオフに続いてオンするにように指示されるか、RUNピンが"L"にアサートされた後に"H"にアサートされた場合、またはRESET コマンドの発行、VINの遮断のいずれかが発生するまで、リトライを継続して試みます。OV フォルトは $n\cdot 10\mu s$ の期間、アクティブを保つ必要があります。ここで、nは $0\sim 7$ の値です。

その他の値は、いずれもCMLフォルトを発生し、書き込みは無視されます。



このコマンドは1バイトのデータを伴います。

表5. VOUT_OV_FAULT_RESPONSEのデータ・バイトの内容

ビット	説明	値	意味
7:6	応答。 ビット[7:6]の全ての値に対して、LTC3887は以下のように 動作します。	00	デバイスは OV プルダウンのみを実行する (すなわち、 V _{OUT} > VOUT_OV_FAULT の間、上側 MOSFET をオフ、 下側 MOSFET をオンする)
	・ステータス・コマンドの該当するフォルト・ビットをセットする。 ・マスクされていない限り、ALERT ピンをアサートしてホストに 通知する。 フォルト・ビットはいったんセットされると、以下のイベントのうち 1つまたは複数が発生するまでクリアされない。	01	PMBus デバイスはビット [2:0] に指定された遅延時間の数値と、特定のフォルトに対して規定された遅延時間の単位で表される期間だけ動作を継続する。この遅延時間の経過後もフォルト条件が解消されていない場合、デバイスはリトライ設定(ビット [5:3]) にプログラムされた方法で応答する。
	・デバイスが CLEAR_FAULTS コマンドを受信した場合。	10	デバイスは直ちにシャットダウンし(出力をディスエーブル)、 ビット[5:3]のリトライ設定に従って応答する。
	・RUNn ピン、OPERATION コマンド、RUNn ピンと OPERATION コマンドの組み合わせアクションのいずれかによって、オフを指示された後、再びオンを指示された場合。 ・LTC3887へのバイアス電源が遮断された後、再び印加された場合。	11	サポートされていない。この値を書き込むとCMLフォルトが 発生する。
5:3	リトライ設定	000-110	デバイスは再起動を試みない。フォルトがクリアされるか、 デバイスがオフするように指示されるか、バイアス電源が 遮断されるまで、出力はディスエーブルされたままになる。
		111	PMBus デバイスはオフを指示されるか (RUNn ピンまたは OPERATION コマンド、または両方による)、バイアス電源が 遮断されるか、他のフォルト条件によってリトライなしで シャットダウンされるまで、再起動を継続して無期限に試みる。 注記:リトライ・インターバルは MFR_RETRY_DELAY コマンドに よって設定される。
2:0	遅延時間	XXX	10µs刻みの遅延時間。この遅延時間は、フォルトの検出後、コントローラが動作を継続する時間を決定する。 デグリッチされたオフ・ステートに対してのみ有効。

VOUT_UV_FAULT_RESPONSE

VOUT_UV_FAULT_RESPONSEコマンドは、出力の低電圧フォルトに対する応答としてデバイスが取るべきアクションを指示します。データ・バイトは表6に示した形式です。

デバイスは、この設定に加えて以下の応答を示します。

- STATUS_WORDのVOUTビットをセットする。
- STATUS_VOUT コマンドの VOUT 低電圧フォルト・ビットをセットする。
- マスクされていない限り、ALERTピンをアサートしてホストに通知する。

次の基準が満たされるまで、UVフォルトおよび警告はマスクされます。

- 1) TON_MAX_FAULT_LIMITに達する。
- 2) TON_DELAYシーケンスが完了する。
- 3) TON_RISEシーケンスが完了する。
- 4) VOUT_UV_FAULT_LIMITしきい値に達する。
- 5) IOUT_OC_FAULT_LIMITが存在しない。

チャネルがアクティブでない場合は、常にUVフォルトおよび警告がマスクされます。



UVフォルトおよび警告は、TON_RISEとTOFF_FALLシーケンスの実行中もマスクされます。 このコマンドは1バイトのデータを伴います。

表 6. VOUT UV FAULT RESPONSEのデータ・バイトの内容

ビット	説明	値	意味
7:6	応答。 ビット [7:6] の全ての値に対して、LTC3887 は以下のように	00	PMBusデバイスは中断せずに動作を続ける。 (フォルト機能を無視)
	動作します。 ・ステータス・コマンドの該当するフォルト・ビットをセットする。 ・マスクされていない限り、ALERT ピンをアサートしてホストに 通知する。	01	PMBus デバイスはビット [2:0] に指定された遅延時間の数値と、特定のフォルトに対して規定された遅延時間の単位で表される期間だけ動作を継続する。この遅延時間の経過後もフォルト条件が解消されていない場合、デバイスはリトライ設定(ビット [5:3]) にプログラムされた方法で応答する。
	フォルト・ビットはいったんセットされると、以下のイベントのうち 1つまたは複数が発生するまでクリアされない。 ・デバイスがCLEAR_FAULTSコマンドを受信した場合。 ・RUNnピン、OPERATIONコマンド、RUNnピンと OPERATION コマンドの組み合わせアクションのいずれかによって、オフを 指示された後、再びオンを指示された場合。 ・LTC3887へのバイアス電源が遮断された後、再び印加された 場合。	10	デバイスはシャットダウンし(出力をディスエーブル)、 ビット[5:3]のリトライ設定に従って応答する。
		11	サポートされていない。この値を書き込むとCMLフォルトが 発生する。
5:3	リトライ設定	000-110	デバイスは再起動を試みない。フォルトがクリアされるか、 デバイスがオフするように指示されるか、バイアス電源が 遮断されるまで、出力はディスエーブルされたままになる。
		111	PMBus デバイスはオフを指示されるか (RUNn ピンまたは OPERATION コマンド、または両方による)、バイアス電源が 遮断されるか、他のフォルト条件によってリトライなしで シャットダウンされるまで、再起動を継続して無期限に試みる。 注記: リトライ・インターバルは MFR_RETRY_DELAY コマンドに よって設定される。
2:0	遅延時間	XXX	10µs刻みの遅延時間。この遅延時間は、フォルトの検出後、コントローラが動作を継続する時間を決定する。 デグリッチされたオフ・ステートに対してのみ有効。

TON_MAX_FAULT_RESPONSE

TON_MAX_FAULT_RESPONSEコマンドは、TON_MAXフォルトに対する応答としてデバイスが取るべきアクションを指示します。データ・バイトは表9に示した形式です。

デバイスは、この設定に加えて以下の応答を示します。

- STATUS_BYTEのNONE_OF_THE_ABOVEビットをセットする。
- STATUS_WORDのVOUTビットをセットする。
- STATUS_VOUT コマンドのTON_MAX_FAULT ビットをセットする。
- マスクされていない限り、ALERTピンをアサートしてホストに通知する。
- 値0を設定すると、TON_MAX_FAULT_RESPONSEがディスエーブルされます。0を設定することは推奨できません。 このコマンドは1バイトのデータを伴います。



3887f

フォルト応答 - 出力電流

コマンド名	CMDコード	説明	タイプ	ページ 指定	データ 形式	単位	NVM	デフォルト 値
IOUT_OC_FAULT_RESPONSE	0x47	出力過電流フォルトが検出されたときの デバイスの動作。	R/W Byte	Υ	Reg		Y	0x00

IOUT_OC_FAULT_RESPONSE

IOUT_OC_FAULT_RESPONSEコマンドは、出力の過電流フォルトに対する応答としてデバイスが取るベきアクションを指示します。データ・バイトは表7に示した形式です。

デバイスは、この設定に加えて以下の応答を示します。

- STATUS_BYTE O IOUT_OC ビットをセットする。
- STATUS_WORDのIOUTビットをセットする。
- STATUS_IOUT コマンドの IOUT 過電流フォルト・ビットをセットする。
- マスクされていない限り、ALERTピンをアサートしてホストに通知する。

このコマンドは1バイトのデータを伴います。

表 7. IOUT OC FAULT RESPONSE のデータ・バイトの内容

ビット	説明	値	意味
7:6	応答。 ビット [7:6] の全ての値に対して、LTC3887 は以下のように 動作します。 ・ステータス・コマンドの該当するフォルト・ビットをセットする。	00	LTC3887は、出力電圧の変動は無視して、IOUT_OC_FAULT_ LIMITによって設定された値の出力電流を保ちつつ、無期限に 動作を継続する(定電流リミット動作またはブリックウォール・ リミット動作とも呼ばれる)。
	・マスクされていない限り、ALERTピンをアサートしてホストに	01	サポートされていない。
	通知する。 フォルト・ビットはいったんセットされると、以下のイベントのうち 1つまたは複数が発生するまでクリアされない。 ・デバイスが CLEAR_FAULTS コマンドを受信した場合。 ・RUNn ピン、OPERATION コマンド、RUNn ピンと OPERATION	10	LTC3887は、出力電圧の変動は無視して、IOUT_OC_FAULT_ LIMITによって設定された値の出力電流を保ちつつ、 ビット[2:0]で設定された遅延時間だけ動作を継続する。 この遅延時間の経過後もデバイスが電流制限値で 動作している場合、リトライ設定(ビット[5:3])に プログラムされた方法で応答する。
	コマンドの組み合わせアクションのいずれかによって、 オフを指示された後、再びオンを指示された場合。 ・LTC3887へのバイアス電源が遮断された後、再び印加された 場合。	11	LTC3887 は直ちにシャットダウンし、ビット [5:3] の リトライ設定にプログラムされた方法で応答する。
5:3	リトライ設定	000-110	デバイスは再起動を試みない。RUNnピンをサイクルさせるか、 バイアス電源を遮断することでフォルトをクリアするまで、 出力はディスエーブルされたままになる。
		111	デバイスはオフを指示されるか(RUNnピンまたはOPERATIONコマンド、または両方による)、バイアス電源が遮断されるか、他のフォルト条件によってシャットダウンされるまで、再起動を継続して無期限に試みる。注記:リトライ・インターバルはMFR_RETRY_DELAYコマンドによって設定される。
2:0	遅延時間	XXX	16ms 単位の数で表した遅延時間。この遅延時間は、 フォルトが検出されてからシャットダウンされるまでデバイスが 動作を継続する時間を決定する。デグリッチされた オフ・ステートに対してのみ有効。



フォルト応答 - IC温度

コマンド名	CMDコード	説明	タイプ	ページ 指定	データ 形式	単位	NVM	デフォルト 値
MFR_OT_FAULT_RESPONSE	0xD6	内部過熱フォルトが検出されたとき、 デバイスが取るアクション。	R Byte	N	Reg			0xC0

MFR_OT_FAULT_RESPONSE

MFR_OT_FAULT_RESPONSEコマンド・バイトは、内部過熱フォルトに対する応答としてデバイスが取るべきアクションを指示します。データ・バイトは表8に示した形式です。

デバイスは、この設定に加えて以下の応答を示します。

- STATUS_WORDのMFRビットをセットする。
- STATUS_MFR_SPECIFIC コマンドの過熱フォルト・ビットをセットする。
- マスクされていない限り、ALERTピンをアサートしてホストに通知する。

このコマンドは1バイトのデータを伴います。

表8. MFR_OT_FAULT_RESPONSEのデータ・バイトの内容

ビット	説明	値	意味
7:6	応答。 ビット[7:6]の全ての値に対して、LTC3887は以下のように	00	サポートされていない。この値を書き込むとCMLフォルトが 発生する。
	動作します。 ・ステータス・コマンドの該当するフォルト・ビットをセットする。	01	サポートされていない。この値を書き込むとCMLフォルトが 発生する。
	・マスクされていない限り、ALERT ピンをアサートしてホストに 通知する。	10	デバイスは直ちにシャットダウンし(出力をディスエーブル)、 ビット[5:3]のリトライ設定に従って応答する。
	フォルト・ビットはいったんセットされると、以下のイベントのうち 1つまたは複数が発生するまでクリアされない。 ・デバイスがCLEAR_FAULTSコマンドを受信した場合。 ・RUNn ピン、OPERATIONコマンド、RUNn ピンとOPERATION コマンドの組み合わせアクションのいずれかによって、 オフを指示された後、再びオンを指示された場合。 ・LTC3887へのバイアス電源が遮断された後、再び印加された 場合。	11	フォルトが解消されない限り、デバイスの出力はディスエーブルされたままになる。フォルト条件が解消されると、動作が再開し、出力がイネーブルされる。
5:3	リトライ設定	000	デバイスは再起動を試みない。フォルトがクリアされるまで 出力はディスエーブルされたままになる。
		001-111	サポートされていない。この値を書き込むとCMLフォルトが 発生する。
2:0	遅延時間	XXX	サポートされていない。値は無視される。

フォルト応答 - 外部温度

コマンド名	CMDコード	説明	タイプ	ページ 指定	データ 形式	単位	NVM	デフォルト 値
OT_FAULT_ RESPONSE	0x50	外部過熱フォルトが検出されたとき、 デバイスが取るアクション。	R/W Byte	Υ	Reg		Y	0xB8
UT_FAULT_ RESPONSE	0x54	外部低温フォルトが検出されたとき、 デバイスが取るアクション。	R/W Byte	Y	Reg		Y	0xB8



3887f

OT FAULT RESPONSE

OT_FAULT_RESPONSEコマンドは、外付け温度センサによる外部過熱フォルトに対する応答としてデバイスが取るべきアクションを指示します。データ・バイトは表9に示した形式です。

デバイスは、この設定に加えて以下の応答を示します。

- STATUS_BYTE OTEMPERATURE ビットをセットする。
- STATUS TEMPERATUREコマンドの過熱フォルト・ビットをセットする。
- マスクされていない限り、ALERTピンをアサートしてホストに通知する。

この状態はADCによって検出するため、最大120msの応答時間を要する場合があります。

このコマンドは1バイトのデータを伴います。

UT_FAULT_RESPONSE

UT_FAULT_RESPONSEコマンドは、外付け温度センサによる外部低温フォルトに対する応答としてデバイスが取るべきアクションを指示します。データ・バイトは表9に示した形式です。

デバイスは、この設定に加えて以下の応答を示します。

- STATUS_BYTE OTEMPERATURE ビットをセットする。
- STATUS TEMPERATUREコマンドの低温フォルト・ビットをセットする。
- マスクされていない限り、ALERTピンをアサートしてホストに通知する。

この状態はADCによって検出するため、最大120msの応答時間を要する場合があります。

このコマンドは1バイトのデータを伴います。

表9. データ・バイトの内容:TON_MAX_FAULT_RESPONSE、VIN_OV_FAULT_RESPONSE、OT FAULT RESPONSE、UT FAULT RESPONSE

ビット	説明	値	意味
7:6	応答。	00	PMBus デバイスは中断せずに動作を続ける。
	ビット[7:6]の全ての値に対して、LTC3887は以下のように動作します。 ・ステータス・コマンドの該当するフォルト・ビットをセットする。	01	サポートされていない。この値を書き込むとCMLフォルトが 発生する。
	・マスクされていない限り、ALERTピンをアサートしてホストに通知する。 フォルト・ビットはいったんセットされると、以下のイベントのうち	10	デバイスは直ちにシャットダウンし(出力をディスエーブル)、 ビット[5:3]のリトライ設定に従って応答する。
	1つまたは複数が発生するまでクリアされない。 ・デバイスが CLEAR_FAULTS コマンドを受信した場合。 ・RUN7 ピン、OPERATION コマンド、RUN7 ピンと OPERATION コマンドの	11	サポートされていない。この値を書き込むとCMLフォルトが 発生する。
	組み合わせアクションのいずれかによって、オフを指示された後、 再びオンを指示された場合。		
	・LTC3887へのバイアス電源が遮断された後、再び印加された場合。		
5:3	リトライ設定		デバイスは再起動を試みない。フォルトがクリアされるか、 デバイスがオフするように指示されるか、バイアス電源が 遮断されるまで、出力はディスエーブルされたままになる。
		111	PMBus デバイスはオフを指示されるか(RUNnピンまたはOPERATIONコマンド、または両方による)、バイアス電源が遮断されるか、他のフォルト条件によってリトライなしでシャットダウンされるまで、再起動を継続して無期限に試みる。注記:リトライ・インターバルはMFR_RETRY_DELAYコマンドによって設定される。
2:0	遅延時間	XXX	サポートされていない。値は無視される。



フォルト共有

フォルト共有 - 伝播

コマンド名	CMDコード	説明	タイプ	ページ 指定	データ 形式	単位	NVM	デフォルト 値
MFR_GPIO_ PROPAGATE_LTC3887	0xD2	GPIO ピンに伝播するフォルトを決定する設定。	R/W Word	Y	Reg		Y	0x6993

MFR_GPIO_PROPAGATE_LTC3887

MFR_GPIO_PROPAGATE_LTC3887 コマンドは、 $\overline{\text{GPIO}}_n$ ピンを"L"にアサートするフォルトをイネーブルします。コマンドは表 10 に示した形式です。応答するようにプログラムされたフォルトだけが $\overline{\text{GPIO}}$ に伝播されます。

このコマンドは2バイトのデータを伴います。

表 10. GPIOn 伝搬フォルトの構成

GPIO0 ピンおよび GPIO1 ピンは、選択されたイベントをユーザーに電気的に通知できるように設計されています。これらのイベントの一部は、両方の出力チャネルに共通しています。その他のイベントは、1つの出力チャネルに固有です。これらのイベントは、チャネル間でのフォルトの共有にも使用できます。

ビット	シンボル	動作
B[15]	VOUT disabled while not decayed.	このビットはMFR_CHAN_CONFIG_LTC3887のビット0が0の場合のPolyPhase構成で使われる。RUNピンのトグルまたはデバイスをオフする指示によってチャネルをオフした後、出力が減衰する前にRUNを再度アサートするか、デバイスに再びオンするように指示したとしても、12.5%の減衰要件が満たされるまでVOUTを再起動しない。ビット15がアサートされている場合、この状態の間はGPIOピンがアサートされる。
B[14]	Mfr_gpio_propagate_short_CMD_cycle	0:アクションなし。
		1:デバイスがオフするように指示され、出力のオフ・シーケンスが完了する前に再度オンを 指示された場合に"L"にアサートされる。オフ・シーケンスの120ms後に、再度"H"にアサートされる。
b[13]	Mfr_gpio_propagate_ton_max_fault	0:TON_MAX_FAULTフォルトがアサートされてもアクションなし。
		1:TON_MAX_FAULTフォルトがアサートされた場合、関連する出力が"L"にアサートされる。
		GPIOOは、ページ0のTON_MAX_FAULTフォルトに関連付けられる。
		GPI01は、ページ1のTON_MAX_FAULTフォルトに関連付けられる。
b[12]	Mfr_gpio0_propagate_vout_uvuf、	フィルタを通していないVOUT_UV_FAULT_LIMITコンパレータの出力
	Mfr_gpio1_propagate_vout_uvuf	GPIOO はチャネルOに関連付けられる
		GPIO1 はチャネル1 に関連付けられる
b[11]	Mfr_gpio0_propagate_int_ot、	0:MFR_OT_FAULT_LIMITフォルトがアサートされてもアクションなし。
	Mfr_gpio1_propagate_int_ot	1:MFR_OT_FAULT_LIMITフォルトがアサートされた場合、関連する出力を"L"にアサートする。
b[10]	Mfr_pwrgd1_en	0:チャネル1のPOWER_GOODが真ではない場合もアクションなし。
		1:チャネル1のPOWER_GOODが真ではない場合、関連する出力を"L"にアサートする。
		このビットがアサートされた場合、GPIO_FAULT_RESPONSEを無視する必要がある。GPIO_FAULT_RESPONSEを「無視」に設定していない場合、デバイスはラッチ・オフされ、起動できなくなる。
b[9]	Mfr_pwrgd0_en	0:チャネル0のPOWER_GOODが真ではない場合もアクションなし。
		1:チャネル0のPOWER_GOODが真ではない場合、関連する出力を"L"にアサートする。
		このビットがアサートされた場合、GPIO_FAULT_RESPONSEを無視する必要がある。GPIO_FAULT_RESPONSEを「無視」に設定していない場合、デバイスはラッチ・オフされ、起動できなくなる。
b[8]	Mfr_gpio0_propagate_ut\	0:UT_FAULT_LIMITフォルトがアサートされてもアクションなし。
	Mfr_gpio1_propagate_ut	1:UT_FAULT_LIMITフォルトがアサートされた場合、関連する出力を"L"にアサートする。
		GPIOOは、ページ0のUTフォルトに関連付けられる。
		GPIOTは、ページ1のUTフォルトに関連付けられる。



ビット	シンボル	動作
b[7]	Mfr_gpio0_propagate_ot\	0:OT_FAULT_LIMITフォルトがアサートされてもアクションなし。
	Mfr_gpio1_propagate_ot	1:0T_FAULT_LIMITフォルトがアサートされた場合、関連する出力を"L"にアサートする。
		GPIOOは、ページ0のOTフォルトに関連付けられる。
		GPIOTは、ページ1のOTフォルトに関連付けられる。
b[6]	予備	
b[5]	予備	
b[4]	Mfr_gpio0_propagate_input_ov、	0:VIN_OV_FAULT_LIMITフォルトがアサートされてもアクションなし。
	Mfr_gpio1_propagate_input_ov	1:VIN_OV_FAULT_LIMITフォルトがアサートされた場合、関連する出力を"L"にアサートする。
b[3]	予備	
b[2]	Mfr_gpio0_propagate_iout_oc\	0:IOUT_OC_FAULT_LIMITフォルトがアサートされてもアクションなし。
	Mfr_gpio1_propagate_iout_oc	1:IOUT_OC_FAULT_LIMITフォルトがアサートされた場合、関連する出力を"L"にアサートする。
		GPIOOは、ページ0のOCフォルトに関連付けられる。
		GPI01は、ページ1の0Cフォルトに関連付けられる。
b[1]	Mfr_gpio0_propagate_vout_uv\	0:VOUT_UV_FAULT_LIMITフォルトがアサートされてもアクションなし。
	Mfr_gpio1_propagate_vout_uv	1:VOUT_UV_FAULT_LIMITフォルトがアサートされた場合、関連する出力を"L"にアサートする。
		GPIOOは、ページ0のUVフォルトに関連付けられる。
		GPI01は、ページ1のUVフォルトに関連付けられる。
b[0]	Mfr_gpio0_propagate_vout_ov、	0:VOUT_OV_FAULT_LIMITフォルトがアサートされてもアクションなし。
	Mfr_gpio1_propagate_vout_ov	1:VOUT_OV_FAULT_LIMITフォルトがアサートされた場合、関連する出力を"L"にアサートする。
		GPIOOは、ページ0のOVフォルトに関連付けられる。
		GPI01は、ページ1の0Vフォルトに関連付けられる。

フォルト共有 - 応答

コマンド名	CMDコード	説明	タイプ	ページ 指定	データ 形式	単位	NVM	デフォルト 値
MFR_GPIO_RESPONSE	0xD5	GPIO ピンが"L"にアサートされたとき、 デバイスが取るアクション。	R/W Byte	Υ	Reg		Υ	0xC0

MFR_GPIO_RESPONSE

このコマンドは、GPIOnピンが外部ソースによって"L"に引き下げられた場合のコントローラの応答を決定します。

値	意味
0xC0	GPIO_INHIBIT。LTC3887はGPIOピンの"L"アサートに対する応答として出力をトライステート化する。
0x00	GPIO_IGNORE。LTC3887は中断せずに動作を継続する。

デバイスは、この設定に加えて以下の応答を示します。

- STATUS_BYTEのNONE_OF_THE_ABOVE ビットをセットする。
- STATUS_WORDのMFRビットをセットする。
- STATUS_MFR_SPECIFIC コマンドのGPIOB ビットをセットする。
- マスクされていない限り、ALERT ピンをアサートしてホストに通知する。ALERT ピンの"L"アサートは、MFR_CHAN_CFG_LTC3887のビット1をセットすることでディスエーブルできる。

このコマンドは1バイトのデータを伴います。

LINEAD TECHNOLOGY

スクラッチパッド

コマンド名	CMDコード	説明	タイプ	ページ 指定	データ 形式	単位	NVM	デフォルト 値
USER_DATA_00	0xB0	OEMにより予約。通常、デバイスのシリアル化に使用。	R/W Word	N	Reg		Υ	NA
USER_DATA_01	0xB1	メーカーにより、LTpowerPlay用に予約。	R/W Word	Υ	Reg		Υ	NA
USER_DATA_02	0xB2	OEMが確保。通常、デバイスのシリアル化に使用。	R/W Word	N	Reg		Υ	NA
USER_DATA_03	0xB3	ユーザーが使用可能なNVMワード。	R/W Word	Υ	Reg		Υ	0x0000
USER_DATA_04	0xB4	ユーザーが使用可能なNVMワード。	R/W Word	N	Reg		Υ	0x0000

USER_DATA_00 ~ USER_DATA_04

これらのコマンドは、顧客が格納用として使用する不揮発性メモリの位置を示します。顧客には、USER_DATA_nnに、いつでも任意の値を書き込むことができるオプションが提供されています。ただし、LTpowerPlayソフトウェアおよび提携メーカーはこれらのコマンドの一部を在庫管理のために使用します。予約済みのUSER_DATA_nnコマンドの変更は、在庫管理上の不具合やこれらの製品との互換性の問題を招く恐れがあります。

これらのコマンドはレジスタ形式の2バイトのデータを伴います。

識別

コマンド名	CMD コード	説明	タイプ	ページ 指定	データ 形式	単位	NVM	デフォルト 値
PMBUS_REVISION	0x98	デバイスがサポートする PMBus のリビジョン。 現在のリビジョンは 1.2。	R Byte	N	Reg			0x22
CAPABILITY	0x19	デバイスがサポートする PMBus オプション通信 プロトコルの要約。	R Byte	N	Reg			0x22
MFR_ID	0x99	LTC3887のメーカーIDをASCIIで示した値。	R String	N	ASC			LTC
MFR_MODEL	0x9A	メーカー製品番号をASCIIで示した値。	R String	N	ASC			LTC3887
MFR_SERIAL	0x9E	この特定のユニットのシリアル番号をASCIIで示した値。	R Block	N	CF			NA
MFR_SPECIAL_ID	0xE7	LTC3887を表すメーカー・コード。	R Word	N	Reg			0x470X

PMBus REVISION

PMBUS_REVISION コマンドは、デバイスが準拠するPMBusのリビジョンを示します。LTC3887は、PMBusバージョン1.2のPart I およびPart IIの両方に準拠しています。

この読み出し専用コマンドは1バイトのデータを伴います。

CAPABILITY

このコマンドにより、ホスト・システムがPMBusデバイスのいくつかの主要機能を識別する手段が提供されます。

LTC3887は、パケット・エラー・チェック、400kHzのバス・スピード、ALERTピンをサポートします。

この読み出し専用コマンドは1バイトのデータを伴います。

MFR_ID

MFR_IDコマンドは、LTC3887のメーカーIDをASCII文字で示します。

この読み出し専用コマンドはブロック形式です。



3887f

MFR MODEL

MFR_MODELコマンドは、LTC3887のメーカー製品番号をASCII文字で示します。 この読み出し専用コマンドはブロック形式です。

MFR SERIAL

MFR_SERIALコマンドには、LTC3887の構成を一意に識別するための、最大9バイトのカスタム形式のデータが含まれています。 この読み出し専用コマンドはブロック形式です。

MFR_SPECIAL_ID

デバイスの名称を表す、16ビットのワードです。0x470はデバイスがLTC3887であることを意味し、Xはメーカーが変更できます。 この読み出し専用コマンドは2バイトのデータを伴います。

フォルトの警告および状態

コマンド名	CMD コード	説明	タイプ	ページ 指定	形式	単位	NVM	デフォルト 値
CLEAR_FAULTS	0x03	セットされている全フォルト・ビットをクリア。	Send Byte	N				NA
SMBALERT_MASK	0x1B	ALERT 動作をマスクする。	Block R/W	Y	Reg		Υ	CMD の 詳細を 参照
MFR_CLEAR_PEAKS	0xE3	全てのピーク値をクリアする。	Send Byte	N				NA
STATUS_BYTE	0x78	ユニットのフォルト状態の1バイトの要約。	R/W Byte	Υ	Reg			NA
STATUS_WORD	0x79	ユニットのフォルト状態の2バイトの要約。	R/W Word	Υ	Reg			NA
STATUS_VOUT	0x7A	出力電圧のフォルトおよび警告の状態。	R/W Byte	Υ	Reg			NA
STATUS_IOUT	0x7B	出力電流のフォルトおよび警告の状態。	R/W Byte	Υ	Reg			NA
STATUS_INPUT	0x7C	入力電源のフォルトおよび警告の状態。	R/W Byte	N	Reg			NA
STATUS_ TEMPERATURE	0x7D	READ_TEMERATURE_1の外部温度フォルト および警告の状態。	R/W Byte	Y	Reg			NA
STATUS_CML	0x7E	通信およびメモリのフォルトおよび警告の状態。	R/W Byte	N	Reg			NA
STATUS_MFR_ SPECIFIC	0x80	メーカー固有のフォルトおよび状態の情報。	R/W Byte	Υ	Reg			NA
MFR_PADS	0xE5	1/0 パッドのデジタル・ステータス。	R Word	N	Reg			NA
MFR_COMMON	0xEF	複数のLTCチップに共通するメーカー・ ステータス・ビット。	R Byte	N	Reg			NA

CLEAR FAULTS

CLEAR_FAULTSコマンドは、現在までにセットされている全てのフォルト・ビットをクリアするために使われます。このコマンドは、全てのステータス・コマンドに含まれる全てのビットを同時にクリアします。さらに、デバイスが ALERT ピン信号をアサート中であった場合は、ALERT ピン信号出力を否定(クリア、解放)します。ビットをクリアする時点でフォルトが依然として存在する場合、フォルト・ビットはセットされたままになり、ALERT ピンの"L"アサートによってホストに通知されます。CLEAR_FAULTS の処理には、最大で10μs かかります。この時間内にフォルトが発生した場合、ステータス・レジスタが設定される前に、そのフォルトがクリアされる場合があります。

この書き込み専用コマンドにはデータ・バイトがありません。

LINEAR

CLEAR_FAULTSコマンドは、フォルト状態のためにラッチ・オフしているデバイスを再起動させることはありません。フォルト状態によってシャットダウンされたデバイスが再起動するのは、以下の場合です。

- RUNピン、OPERATIONコマンド、RUNピンとOPERATIONコマンドの組み合わせアクションのいずれかによって、オフを指示された後、再びオンを指示された場合。
- MFR_RESET コマンドまたはRESTORE_USER_ALL コマンドが発行された場合。
- ICへのバイアス電源が遮断された後、再び印加された場合。

MFR CLEAR PEAKS

MFR_CLEAR_PEAKSコマンドは、MFR_*_PEAKのデータ値をクリアします。リセットによってこのコマンドが開始されます。 この書き込み専用コマンドにはデータ・バイトがありません。

SMBALERT MASK

SMBALERT_MASK コマンドを使用すると、単数または複数の特定のステータス・ビットが ALERT をアサートしないようにすることができます。 サポートされているビットのみをマスクすることができます。

図41は、ALERTマスクを(この場合はPECなしで)設定するときに使用されるワード書き込み形式の例を示します。マスク・バイト内のビットは、指定のステータス・レジスタ内のビットと一致します。例えば、STATUS_TEMPERATUREコマンドが最初のデータ・バイトで送られ、マスク・バイトに0x40が含まれている場合、後続の外部過熱警告は引き続きSTATUS_TEMPERATUREのビット6を設定しますが、ALERTはアサートしません。サポートされているその他のSTATUS_TEMPERATUREビットが全て設定されている場合は、これらのビットによって引き続きALERTがアサートされます。

図42は、サポートされている任意のステータス・レジスタの現在の状態を読み出すときに使用する「ブロック書き込み – ブロック 読み出しプロセス呼び出し」プロトコルの例を示します。この場合もやはりPEC なしです。

SMBALERT_MASKは、STATUS_BYTE、STATUS_WORD、MFR_COMMON、またはMFR_PADS_LTC3887には適用できません。適用できるステータス・レジスタの工場出荷時のデフォルトのマスキング設定を以下に示します。サポートされていないコマンド・コードをSMBALERT MASKに設定すると、無効なデータ/サポートされていないデータに対してCMLが生成されます。

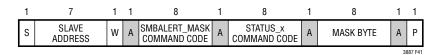


図41. SMBALERT_MASKの設定例

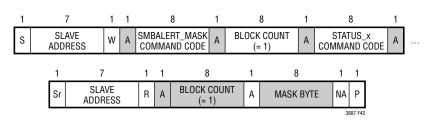


図42. SMBALERT_MASKの読み出し例



3887f

SMBALERT_MASKのデフォルト設定:(図43「ステータス・レジスター覧」も参照してください。)

ステータス・レジスタ	ALERTのマスク値	マスクされたビット
STATUS_VOUT	0x00	なし
STATUS_IOUT	0x00	なし
STATUS_TEMPERATURE	0x00	なし
STATUS_CML	0x00	なし
STATUS_INPUT	0x00	なし
STATUS_MFR_SPECIFIC	0x11	ビット4(内部PLL非同期)、ビット0(GPIOが外部デバイスによって"L"に引き下げられる)

STATUS_BYTE

STATUS BYTEコマンドは、最も重大なフォルトの1バイトの要約を返します。

STATUS BYTEのメッセージの内容:

ビット	ステータス・ビット名	意味
7	BUSY	LTC3887が応答できないので、フォルトが宣言された。
6	オフ	このビットは、単にイネーブルされていない場合も含めて、理由に関係なく、チャネルが出力に電力を 供給していない場合に設定される。
5	VOUT_OV	出力過電圧フォルトが生じている。
4	IOUT_OC	出力過電流フォルトが生じている。
3	VIN_UV	サポートされていない(LTC3887は0を返す)。
2	温度	温度フォルトまたは警告が生じている。
1	CML	通信、メモリ、またはロジック・フォルトが生じている。
0	上記のいずれでもない	ビット[7:1]に記載されていないフォルトが生じている。

このコマンドは1バイトのデータを伴います。

このコマンドに含まれる、サポート対象のフォルト・ビットは、いずれもALERTイベントを起動します。

STATUS_WORD

STATUS_WORDコマンドは、チャネルのフォルト状態の2バイトの要約を返します。STATUS_WORDコマンドの下位バイトはSTATUS_BYTEコマンドと同じです。

STATUS_WORD上位バイトのメッセージの内容:

_		
ビット	ステータス・ビット名	意味
15	V _{OUT}	出力電圧フォルトまたは警告が生じている。
14	Іоит	出力電流フォルトまたは警告が生じている。
13	入力	入力電圧フォルトまたは警告が生じている。
12	MFR_SPECIFIC	LTC3887に固有のフォルトまたは警告が生じている。
11	POWER_GOOD#	このビットが設定されている場合、POWER_GOOD状態は正しくない。
10	FANS	サポートされていない(LTC3887は0を返す)。
9	OTHER	サポートされていない(LTC3887は0を返す)。
8	UNKNOWN	サポートされていない(LTC3887は0を返す)。

このコマンドに含まれる、サポート対象のフォルト・ビットは、いずれもALERTイベントを起動します。

このコマンドは2バイトのデータを伴います。

LINEAD TECHNOLOGY

PMBusコマンドの詳細 (フォルト応答および通信)

STATUS_VOUT

STATUS_VOUT コマンドは、1バイトのVOUT ステータス情報を返します。

STATUS_VOUTのメッセージの内容:

ビット	意味
7	V _{OUT} の過電圧フォルト。
6	V _{OUT} の過電圧警告。
5	V _{OUT} の低電圧警告。
4	V _{OUT} の低電圧フォルト。
3	VOUT_MAX警告。
2	TON_MAX フォルト。
1	TOFF_MAX 警告。
0	LTC3887によってサポートされていない(0を返す)。

ビット [7:1] のいずれかを設定した場合は、ALERT をアサートできます。これらのビットは、CLEAR_FAULTS コマンドの代わりに、STATUS_VOUT内でそれらのビット位置に1を書き込むことによりクリアできます。

このコマンドは1バイトのデータを伴います。

STATUS IOUT

STATUS_IOUT コマンドは、1バイトのIOUT ステータス情報を返します。

STATUS_IOUTのメッセージの内容:

ビット	意味
7	I _{OUT} の過電流フォルト。
6	サポートされていない(LTC3887は0を返す)。
5	l _{OUT} の過電流警告。
4:0	サポートされていない(LTC3887は0を返す)。

サポートされているいずれかのビットを設定した場合は、ALERTをアサートできます。サポートされているビットは、CLEAR_FAULTSコマンドの代わりに、STATUS_IOUT内でそのビット位置に1を書き込むことによりクリアできます。

このコマンドは1バイトのデータを伴います。

STATUS_INPUT

STATUS_INPUT コマンドは、1バイトのV_{IN} (VINSNS)ステータス情報を返します。

STATUS INPUTのメッセージの内容:

ビット	意味
7	V _{IN} の過電圧フォルト。
6	サポートされていない(LTC3887は0を返す)。
5	V _{IN} の低電圧警告。
4	サポートされていない(LTC3887は0を返す)。
3	V _{IN} が不十分なため、デバイスはオフ。
2	サポートされていない(LTC3887は0を返す)。
1	入力過電流警告。
0	サポートされていない(LTC3887は0を返す)。

ビット7を設定した場合は、 $\overline{\text{ALERT}}$ をアサートできます。ビット7は、 $\overline{\text{CLEAR_FAULTS}}$ コマンドの代わりに、1を書き込むことによりクリアできます。

このコマンドは1バイトのデータを伴います。



STATUS_TEMPERATURE

STATUS_TEMPERATUREコマンドは、1バイトの外部温度検出ステータス情報を返します。

STATUS_TEMPERATURE のメッセージの内容:

ビット	意味
7	外部過熱フォルト。
6	外部過熱警告。
5	サポートされていない(LTC3887は0を返す)。
4	外部低温フォルト。
3:0	サポートされていない(LTC3887は0を返す)。

サポートされているいずれかのビットを設定した場合は、ALERTをアサートできます。サポートされているビットは、CLEAR_FAULTSコマンドの代わりに、STATUS_TEMPERATURE内でそのビット位置に1を書き込むことによりクリアできます。

このコマンドは1バイトのデータを伴います。

STATUS CML

STATUS CML コマンドは、受信したコマンド、内部メモリおよびロジックの1バイトのステータス情報を返します。

STATUS_CMLのメッセージの内容:

ビット	意味
7	無効なコマンドまたはサポートされていないコマンドを受け取った。
6	無効なデータまたはサポートされていないデータを受け取った。
5	パケット・エラー検査が失敗した。
4	メモリ・フォルトが検出された。
3	プロセッサ・フォルトが検出された。
2	予備(LTC3887は0を返す)。
1	その他の通信フォルト。
0	その他のメモリ・フォルトまたはロジック・フォルト。

サポートされているいずれかのビットを設定した場合は、ALERTをアサートできます。サポートされているビットは、CLEAR_FAULTSコマンドの代わりに、STATUS_CML内でそのビット位置に 1を書き込むことによりクリアできます。

このコマンドは1バイトのデータを伴います。

STATUS_MFR_SPECIFIC

STATUS_MFR_SPECIFICコマンドは、メーカー固有のステータス情報を1バイトで返します。

各チャネルは同じ情報のコピーを保持します。ビット0のみがページに固有です。

このバイトの形式は次のとおりです。

ビット	意味
7	内部温度フォルト・リミットを超過した。
6	内部温度警告リミットを超過した。
5	NVM CRC フォルト。
4	PLLのロックが外れた。
3	フォルト・ログが存在する。
2	V _{DD33} のUVまたはOVフォルト
1	Voutが短時間でサイクルした。
0	外部デバイスによって GPIO ピンが"L"にアサートされた(ページ指定)。



これらのビットのいずれかがセットされた場合、STATUS_WORDのMFRビットもセットされます。

ユーザーは、このコマンド内の任意のビットに1を書き込むことで、特定のフォルトをクリアできます。このビットにより、ユーザーはCLEAR_FAULTSコマンドの使用以外の手段によって、ステータスをクリアできます。例外:フォルト・ログの存在を示すビットは、MFR_FAULT_LOG_CLEARコマンドの発行によってのみクリアできます。

このコマンドに含まれる、サポート対象のフォルト・ビットは、いずれもALERTイベントを起動します。

このコマンドは1バイトのデータを伴います。

MFR PADS

このコマンドは、ユーザーがデバイスのI/Oピンのデジタル・ステータスを直接読み出す手段を提供します。このコマンドのビット割り当ては次のとおりです。

ビット	割り当てられるデジタル・ピン
15	V _{DD33} OVフォルト
14	V _{DD33} UVフォルト
13	予備
12	予備
11	ADCの値が無効。起動時に発生する。
10	外部クロックのため、SYNC出力がディスエーブルされている。
9	パワーグッド1
8	パワーグッド0
7	デバイスがRUN1を"L"に駆動中。
6	デバイスがRUN0を"L"に駆動中。
5	RUN1
4	RUN0
3	デバイスが GPI01 を"L"に駆動中。
2	デバイスが GPIOO を"L"に駆動中。
1	GPIO1
0	GPIO0

1は、条件が真であることを意味します。

この読み出し専用コマンドは2バイトのデータを伴います。

MFR_COMMON

MFR_COMMONコマンドには、LTCのデジタル電源およびテレメトリ製品の全てに共通するビットが含まれます。

ビット	意味
7	デバイスはALERTを"L"に駆動していない。
6	デバイスは BUSY ではない。
5	計算が保留中でない。
4	出力は遷移中ではない。
3	NVMが初期化済み。
2	予備
1	SHARE_CLKのタイムアウト。
0	WPピンのステータス。

この読み出し専用コマンドは1バイトのデータを伴います。



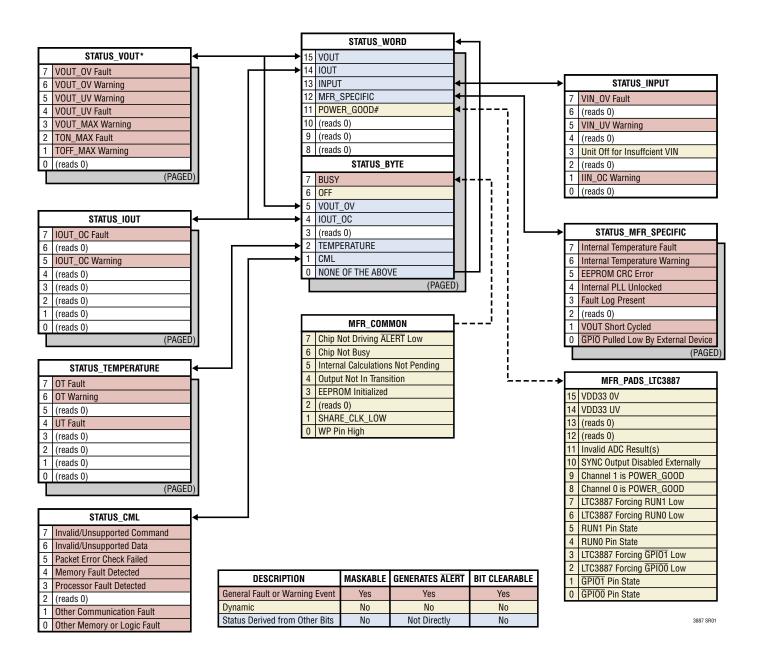


図43. ステータス・レジスタ一覧

遠隔測定値

コマンド名	CMD コード	説明	タイプ	ページ 指定	形式	単位	NVM	デフォルト 値
READ_VIN	0x88	入力電源電圧の測定値。	R Word	N	L11	V		NA
READ_VOUT	0x8B	出力電圧の測定値。	R Word	Υ	L16	V		NA
READ_IIN	0x89	入力電源電流の計算値。	R Word	N	L11	Α		NA
MFR_READ_IIN	0xED	チャネルごとに計算された入力電流。	R Word	Υ	L11	Α		NA
READ_IOUT	0x8C	出力電流の測定値。	R Word	Υ	L11	Α		NA
READ_TEMPERATURE_1	0x8D	外部温度センサ。IOUT_CAL_GAINをはじめとする、 全ての温度関連処理に使用される値。	R Word	Υ	L11	С		NA
READ_TEMPERATURE_2	0x8E	内部ダイ温度。他のいずれのレジスタにも影響を 与えない。	R Word	N	L11	С		NA
READ_DUTY_CYCLE	0x94	上側ゲート制御信号のデューティ・サイクル。	R Word	Υ	L11	%		NA
READ_POUT	0x96	出力電力の計算値。	R Word	Υ	L11	W		NA
MFR_VOUT_PEAK	0xDD	最後のMFR_CLEAR_PEAKS 以降に測定された READ_VOUTの最大値。	R Word	Υ	L16	V		NA
MFR_VIN_PEAK	0xDE	最後のMFR_CLEAR_PEAKS以降に測定された READ_VINの最大値。	R Word	N	L11	V		NA
MFR_TEMPERATURE_1_PEAK	0xDF	最後のMFR_CLEAR_PEAKS 以降に測定された 外部温度(READ_TEMPERATURE_1)の最大値。	R Word	Υ	L11	С		NA
MFR_TEMPERATURE_2_PEAK	0xF4	最後のMFR_CLEAR_PEAKS以降に測定された 外部温度(READ_TEMPERATURE_2)の最大値。	R Word	N	L11	С		NA
MFR_IOUT_PEAK	0xD7	最後のMFR_CLEAR_PEAKS 以降に測定された READ_IOUT の最大値を報告する。	R Word	Υ	L11	А		NA
MFR_ADC_CONTROL	0xD8	A/D コンバータの反復される高速読み出しのために 選択するADCテレメトリ・パラメータ。	R/W Byte	N	Reg			0x00
MFR_ADC_TELEMETRY_ STATUS	0xDA	ショート・ラウンド・ロビン ADC ループがイネーブル されたときに、最後に変換されたパラメータを示す ADC テレメトリ・ステータス。	R/W Byte	N	Reg			NA

READ_VIN

READ VINコマンドは、測定された入力電圧(V単位)を返します。

この読み出し専用コマンドは、Linear_5s_11s形式の2バイトのデータを伴います。

READ VOUT

READ_VOUTコマンドは、VOUT_MODEコマンドによって設定されたものと同じ形式で出力電圧の測定値を返します。 この読み出し専用コマンドは、Linear_16u形式の2バイトのデータを伴います。

READ_IIN

READ_IINコマンドは、入力電流(A単位)を返します。注記:入力電流は、両方の出力からのREAD_IOUT電流とREAD_DUTY_CYCLE値、およびMFR_IIN_OFFSETから計算されます。低電流において正確な値を得るには、デバイスを連続導通モードで動作させる必要があります。DCR 検出を使用した場合の誤差の最大の発生源は、室温のIOUT_CAL_GAINでのインダクタの寄生 DC抵抗(DCR)の精度です。

READ_IIN = MFR_READ_IIN_PAGE0 + MFR_READ_IIN_PAGE1

この読み出し専用コマンドは、Linear_5s_11s形式の2バイトのデータを伴います。



3887f

MFR READ IIN

MFR_READ_IINコマンドは、ページ指定されたMFR_IIN_OFFSETパラメータを適用する入力電流のページ指定読み出しです。 この計算は、ページ指定値を使用することを除き、READ IINと同じです。

MFR_READ_IIN = MFR_IIN_OFFSET + (IOUT • DUTYCYCLE)

このコマンドは、Linear 5s 11s形式の2バイトのデータを伴います。

READ IOUT

READ_IOUT コマンドは、平均出力電流をA単位で返します。IOUTの値は、以下の値によって決まります。

- a) I_{SENSE}ピンで測定される差動電圧。
- b) IOUT_CAL_GAINの値
- c) MFR_IOUT_CAL_GAIN_TCの値
- d) READ_TEMPERATURE_1の値
- e) MFR_TEMP_1_GAIN & MFR_TEMP_1_OFFSET

この読み出し専用コマンドは、Linear_5s_11s形式の2バイトのデータを伴います。

READ TEMPERATURE 1

READ_TEMPERATURE_1 コマンドは、外付けの検出素子で測定される温度($^{\circ}$ C)を返します。この読み出し専用コマンドは、Linear_5s_11s形式の2バイトのデータを伴います。

READ TEMPERATURE 2

READ_TEMPERATURE_2コマンドは、内部検出素子で測定される温度を $^{\circ}$ C単位で返します。 この読み出し専用コマンドは、Linear 5s 11s形式の2バイトのデータを伴います。

READ_DUTY_CYCLE

READ_DUTY_CYCLE コマンドは、コントローラのデューティ・サイクルを%単位で返します。 この読み出し専用コマンドは、Linear_5s_11s形式の2バイトのデータを伴います。

READ POUT

READ_POUT コマンドは、DC/DC コンバータの出力電力のページ指定読み出し値をW単位で返します。POUT は、最新の相関する出力電圧と電流読み出し値に基づいて計算されます。

このコマンドは、Linear 5s 11s形式の2バイトのデータを伴います。

MFR VOUT PEAK

MFR_VOUT_PEAKコマンドは、READ_VOUT測定によって報告される最大電圧をV単位で返します。

このコマンドは、MFR CLEAR PEAKSコマンドによってクリアされます。

この読み出し専用コマンドは、Linear_16u形式の2バイトのデータを伴います。

LINEAR

MFR VIN PEAK

MFR_VIN_PEAK コマンドは、READ_VIN測定によって報告される最大電圧をV単位で返します。

このコマンドは、MFR CLEAR PEAKSコマンドによってクリアされます。

この読み出し専用コマンドは、Linear_5s_11s形式の2バイトのデータを伴います。

MFR_TEMPERATURE_1_PEAK

MFR_TEMPERATURE_1_PEAKコマンドは、READ_TEMPERATURE_1測定によって報告される最大温度を°C単位で返します。 このコマンドは、MFR CLEAR PEAKSコマンドによってクリアされます。

この読み出し専用コマンドは、Linear 5s 11s形式の2バイトのデータを伴います。

MFR_TEMPERATURE_2_PEAK

MFR_TEMPERATURE_2_PEAKコマンドは、READ_TEMPERATURE_2測定によって報告される最大温度を°C単位で返します。 このコマンドは、MFR CLEAR PEAKSコマンドによってクリアされます。

この読み出し専用コマンドは、Linear_5s_11s形式の2バイトのデータを伴います。

MFR IOUT PEAK

MFR_IOUT_PEAK コマンドは、READ_IOUT 測定によって報告される最大電流をA単位で返します。

このコマンドは、MFR CLEAR PEAKSコマンドによってクリアされます。

この読み出し専用コマンドは、Linear_5s_11s形式の2バイトのデータを伴います。

MFR_ADC_CONTROL

MFR_ADC_CONTROLコマンドは、A/Dコンバータの読み出し選択を決定します。このコマンドのデフォルト値のによって、ラウンド・ロビン方式で100msの標準待ち時間で全てのパラメータが更新され、標準テレメトリ・ループが動作します。ユーザーは、0以外の値を指示して、約8msの更新レートで1つのパラメータをモニタできます。このコマンドには、最大で2つのADC変換の待ち時間、つまり約16msの待ち時間があります(外部温度変換には、最大で3つのADC変換、つまり約24msの待ち時間がある場合があります)。0x0Dの値を選択すると、ショート・ラウンド・ロビン・ループがイネーブルされます。この値を指示すると、ラウンド・ロビン方式でVOUTO、IOUTO、VOUTI、およびIOUT1のみを選択する短いテレメトリ・ループが動作します。ラウンド・ロビンの標準待ち時間は27msです。1つのパラメータについて高速なA/Dコンバータの更新が必要になる特殊な場合を除き、デバイスを標準テレメトリ・モードのままにすることを推奨します。限定された時間(1秒未満)の間目的のパラメータをモニタしてから、このコマンドを標準ラウンド・ロビン・モードに再設定するように、デバイスに指示する必要があります。このコマンドを、標準ラウンド・ロビン・テレメトリ(0)以外の値に設定した場合、選択したパラメータ以外のテレメトリに関連する全ての警告およびフォルトは事実上ディスエーブルされ、電圧のサーボ制御はディスエーブルされます。ラウンド・ロビンを再びアサートすると、全ての警告とフォルト、およびサーボ・モードが再びイネーブルされます。



コマンド値	選択される遠隔測定値
0x0E-0xFF	予備
0x0D	ADCショート・ラウンド・ロビン
0x0C	チャネル1の外部温度
0x0B	予備
0x0A	チャネル1のIOUT
0x09	チャネル1のVOUT
0x08	チャネル0の外部温度
0x07	予備
0x06	チャネル0のIOUT
0x05	チャネル0のVOUT
0x04	内部デバイス温度
0x03	予備
0x02	予備
0x01	V _{IN}
0x00	標準ADCラウンド・ロビン・テレメトリ

予備のコマンド値を入力した場合、デフォルトで内部デバイス温度に設定され、CML[6]フォルトが発行されます。CML[6]フォルトは、有効なコマンド値が入力されるまで、LTC3887によって継続的に発行されます。

この読み出し/書き込みコマンドは、レジスタ形式の1バイトのデータを伴います。

MFR_ADC_TELEMETRY_STATUS

MFR_ADC_TELEMETRY_STATUS コマンドは、コマンド0xD8の値0x0Dを使用してMFR_ADC_CONTROLのショート・ラウンド・ロビン・ループをイネーブルした場合に、最後のADC変換を決定する手段を提供します。このコマンドのビット割り当ては次のとおりです。

ビット	使用可能な遠隔測定値データ
7	予備、0を返す。
6	予備、0を返す。
5	予備、0を返す。
4	予備、0を返す。
3	チャネル1のIOUTの読み出し(IOUT1)。
2	チャネル1のVOUTの読み出し(VOUT1)。
1	チャネル0のIOUTの読み出し(IOUTO)。
0	チャネル0のVOUTの読み出し(VOUT0)。

1に設定されたデータ・ビットをMFR_ADC_TELEMETRY_STATUSに書き込むと、対応するビットがクリアされます。 この読み出し/書き込みコマンドは、レジスタ形式の1バイトのデータを伴います。

LINEAR

NVM(EEPROM)メモリ・コマンド

ストア/リストア

コマンド名	CMDコード	説明	タイプ	ページ 指定	形式	単位	NVM	デフォルト 値
STORE_USER_ALL	0x15	ユーザー動作メモリを EEPROM に格納する。	Send Byte	N				NA
RESTORE_USER_ALL	0x16	ユーザー使用メモリをEEPROMからリストアする。	Send Byte	N				NA
MFR_COMPARE_USER_ALL	0xF0	現在のコマンドの内容をNVMと比較する。	Send Byte	N				NA

STORE USER ALL

STORE_USER_ALLコマンドは、PMBus デバイスに、動作メモリ内の不揮発性ユーザー・コンテンツを、不揮発性ユーザー NVM メモリ(EEPROM)の対応する位置にコピーするように指示します。

ダイ温度が85°Cを超える場合は、このコマンドの実行を推奨できません。また、データ保持期間の10年も保証できません。ダイ温度が130°Cを超えると、STORE_USER_ALLコマンドはディスエーブルされます。IC温度が125°Cを下回ると、コマンドは再度イネーブルされます。

LTC3887との通信、およびEEPROMのプログラミングは、VDD33が使用可能になり、かつVINが印加されていない場合に開始できます。デバイスをこの状態に移行させるには、グローバル・アドレスの0x5Bを使用して0x2Bを書き込み、続いて0xC4を書き込みます。これによって、デバイスとの通信が可能になり、プロジェクト・ファイルが更新されます。更新されたプロジェクト・ファイルをEEPROMに書き込むには、STORE_USER_ALLコマンドを発行します。VINを印加したらMFR_RESETコマンドを発行して、PWMをイネーブルし、ADCの有効な値を読み出せるようにする必要があります。

この書き込み専用コマンドにはデータ・バイトがありません。

RESTORE USER ALL

RESTORE USER ALLコマンドは、ユーザーがLTC3887のリセット動作を実行する手段を提供します。

この書き込み専用コマンドにはデータ・バイトがありません。

MFR_COMPARE_USER_ALL

MFR_COMPARE_USER_ALLコマンドは、PMBusデバイスに、現在のコマンド内容を、不揮発性メモリに格納された内容と比較するように指示します。この比較動作によって相違が検出された場合、CMLビット0フォルトが生成されます。

MFR_COMPARE_USER_ALLコマンドは、ダイ温度が 130° Cを超えるとディスエーブルされ、ダイ温度が 125° Cを下回るまで再度イネーブルされません。

この書き込み専用コマンドにはデータ・バイトがありません。

フォルト・ログ

コマンド名	CMD コード	説明	タイプ	ページ 指定	データ 形式	単位	NVM	デフォルト 値
MFR_FAULT_LOG	0xEE	フォルト・ログのデータ・バイト。この順次取得データを使用して完全なフォルト・ログをアセンブルする。	R Block	N	CF		Y	NA
MFR_FAULT_LOG_ STORE	0xEA	RAMからEEPROMへのフォルト・ログの伝送を命令する。	Send Byte	N				NA
MFR_FAULT_LOG_CLEAR	0xEC	フォルト・ログ用に予約されたEEPROMブロックを 初期化する。	Send Byte	N				NA



MFR FAULT LOG

MFR_FAULT_LOGコマンドによって、ユーザーはMFR_FAULT_LOG_CLEARコマンドを最後に書き込んで以降、最初のフォルト発生後のFAULT_LOGの内容を読み出すことができます。このコマンドの内容は不揮発メモリに格納され、MFR_FAULT_LOG_CLEARコマンドによってクリアされます。表11に、このコマンドの長さと内容の一覧を示します。ユーザーがMFR_FAULT_LOGコマンドにアクセスしたときに、フォルト・ログが存在しなかった場合、データ長0が返されます。フォルト・ログが存在した場合は、常に長さ147バイトのデータ・ブロックが返されます。電源印加後、最初の1秒以内にフォルトが発生した場合、フォルト・ログの前寄りのページの一部には有効なデータが格納されていない可能性があります。

NOTE:このコマンドのおよその伝送時間は、400kHzクロックを使用した場合、3.4msです。

この読み出し専用コマンドはブロック形式です。

MFR FAULT LOG STORE

MFR_FAULT_LOG_STORE コマンドは、フォルト・イベントが発生したかのように、フォルト・ログ動作が強制的にEEPROMに書き込まれるようにします。このコマンドは、MFR_CONFIG_ALL_LTC3887 コマンドで「フォルト・ログ記録のイネーブル」ビットが設定されるとMFR_SPECIFICフォルトを発生させます。

MFR_FAULT_LOG_STORE コマンドは、ダイ温度が130°Cを超えると、IC温度が125°Cを下回るまでディスエーブルされます。

フォルト・ログのヘッダにはアップタイム・カウンタがあります。このカウンタは、最後のリセット後の経過時間を200μs刻みで示したものです。これは、48 ビット・バイナリ・カウンタです。

この書き込み専用コマンドにはデータ・バイトがありません。

表11. フォルト・ログ

えて、フォルト・ロフ この表は、MFR_FAULT_LOGコマン	ノドのブロック・データ	ヲ読み出しに使われるブロック・データの形式についてまとめたもので	す。
データ形式の完美		LIN 11 - DMRus - Poy 1 1 Part 2 coction 7 1	

データ形式の定義				LIN 11 = PMBus = Rev 1.1, Part 2, section 7.1.
				LIN 16 = PMBus Rev 1.1, Part 2, section 8。 仮数部分のみ。
				BYTE = このコマンドの定義に従って解釈される8ビット
データ	ビット	データ 形式	バイト番号	ブロック読み出しコマンド
Block Length		BYTE	147	MFR_FAULT_LOGコマンドの長さは147バイト固定である。
				データ・ログ・イベントが取得されていない場合、ブロック長は0になる。
ヘッダ情報				
フォルト・ログの前書き	[7:0]	ASC	0	部分的なフォルト・ログまたは完全なフォルト・ログが存在する場合、
	[7:0]		1	│バイト0で始まるLTxxを返します。ワードxxはデバイスごとに │変えることができる工場識別子です。
	[15:8]	Reg	2	- 文元のここが (との工物助力) () (
	[7:0]		3	
フォルト発生源	[7:0]	Reg	4	表3を参照してください。
MFR_REAL_TIME	[7:0]	Reg	5	フォルト発生時の48ビット共有クロック・カウンタの値(分解能200µs)。
	[15:8]		6	
	[23:16]		7	
	[31:24]	1	8	
	[39:32]	1	9	
	[47:40]	1	10	1

MFR_VOUT_PEAK (PAGE 0)	[15:8]	L16	11	最後の電源投入以来またはCLEAR_PEAKSコマンド以来の チャネル0でのピーク READ VOUT。
	[7:0]	1	12	
MFR_VOUT_PEAK (PAGE 1)	[15:8]	L16	13	最後の電源投入以来またはCLEAR_PEAKSコマンド以来の チャネル1でのピークREAD VOUT。
	[7:0]	-	14	_ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
MFR_IOUT_PEAK (PAGE 0)	[15:8]	L11	15	最後の電源投入以来またはCLEAR_PEAKSコマンド以来の チャネル0でのピークREAD_IOUT。
	[7:0]	1	16	
MFR_IOUT_PEAK (PAGE 1)	[15:8]	L11	17	最後の電源投入以来またはCLEAR_PEAKSコマンド以来のチャネル1でのピークREAD_IOUT。
	[7:0]]	18	
MFR_VIN_PEAK	[15:8]	L11	19	最後の電源投入以来またはCLEAR_PEAKSコマンド以来のチャネル0でのピークREAD_VIN。
	[7:0]]	20	
READ_TEMPERATURE1 (PAGE 0)	[15:8]	L11	21	最後のイベント発生時の外部温度センサ0。
	[7:0]		22	
READ_TEMPERATURE1 (PAGE 1)	[15:8]	L11	23	最後のイベント発生時の外部温度センサ1。
	[7:0]		24	
READ_TEMPERATURE2	[15:8]	L11	25	最後のイベント発生時の内部温度センサ。
	[7:0]		26	
巡回データ				
EVENT n (フォルトが発生したデータ。最新デ-	-タ)			イベント「n」は、フォルト発生時のMUXを介したADC読み出しの 完全な1サイクルを表す。例:ADCがステップ15を処理しているときに フォルトが発生した場合、ステップ25まで読み出し値の取得を続けた後、 ヘッダと6つのイベント・ページの全てをEEPROMに格納する。
READ_VOUT (PAGE 0)	[15:8]	LIN 16	27	
	[7:0]	LIN 16	28	
READ_VOUT (PAGE 1)	[15:8]	LIN 16	29	
	[7:0]	LIN 16	30	
READ_IOUT (PAGE 0)	[15:8]	LIN 11	31	
	[7:0]	LIN 11	32	
READ_IOUT (PAGE 1)	[15:8]	LIN 11	33	
	[7:0]	LIN 11	34	
READ_VIN	[15:8]	LIN 11	35	
	[7:0]	LIN 11	36	
READ_IIN	[15:8]	LIN 11	37	
	[7:0]	LIN 11	38	
STATUS_VOUT (PAGE 0)		BYTE	39	
STATUS_VOUT (PAGE 1)		BYTE	40	
STATUS_WORD (PAGE 0)	[15:8]	WORD	41	
	[7:0]	WORD	42	



STATUS_WORD (PAGE 1)	[15:8]	WORD	43
	[7:0]	WORD	44
STATUS_MFR_SPECIFIC (PAGE 0)		BYTE	45
STATUS_MFR_SPECIFIC (PAGE 1)		BYTE	46
EVENT n-1			
(フォルトの検出前に測定されたデータ	7)		
READ_VOUT (PAGE 0)	[15:8]	LIN 16	47
	[7:0]	LIN 16	48
READ_VOUT (PAGE 1)	[15:8]	LIN 16	49
	[7:0]	LIN 16	50
READ_IOUT (PAGE 0)	[15:8]	LIN 11	51
	[7:0]	LIN 11	52
READ_IOUT (PAGE 1)	[15:8]	LIN 11	53
	[7:0]	LIN 11	54
READ_VIN	[15:8]	LIN 11	55
_	[7:0]	LIN 11	56
READ_IIN	[15:8]	LIN 11	57
_	[7:0]	LIN 11	58
STATUS_VOUT (PAGE 0)	1.141	BYTE	59
STATUS_VOUT (PAGE 1)		BYTE	60
STATUS_WORD (PAGE 0)	[15:8]	WORD	61
	[7:0]	WORD	62
STATUS_WORD (PAGE 1)	[15:8]	WORD	63
	[7:0]	WORD	64
STATUS_MFR_SPECIFIC (PAGE 0)	[,,0]	BYTE	65
STATUS_MFR_SPECIFIC (PAGE 1)		BYTE	66
*		DITL	00
*			
*			
EVENT n E		<u> </u>	
EVENT n-5 (記録された是も士いデータ)			
(記録された最も古いデータ)	[15.0]	1111116	107
READ_VOUT (PAGE 0)	[15:8]	LIN 16	127
DEAD VOUT (DACE 4)	[7:0]	LIN 16	128
READ_VOUT (PAGE 1)	[15:8]	LIN 16	129
DEAD TOLIT (DAGE 2)	[7:0]	LIN 16	130
READ_IOUT (PAGE 0)	[15:8]	LIN 11	131
	[7:0]	LIN 11	132

READ_IOUT (PAGE 1)	[15:8]	LIN 11	133	
	[7:0]	LIN 11	134	
READ_VIN	[15:8]	LIN 11	135	
	[7:0]	LIN 11	136	
READ_IIN	[15:8]	LIN 11	137	
	[7:0]	LIN 11	138	
STATUS_VOUT (PAGE 0)		BYTE	139	
STATUS_VOUT (PAGE 1)		BYTE	140	
STATUS_WORD (PAGE 0)	[15:8]	WORD	141	
	[7:0]	WORD	142	
STATUS_WORD (PAGE 1)	[15:8]	WORD	143	
	[7:0]	WORD	144	
STATUS_MFR_SPECIFIC (PAGE 0)		BYTE	145	
STATUS_MFR_SPECIFIC (PAGE 1)		BYTE	146	

表11a.Position_Faultの値の説明

POSITION_FAULTの値	フォルト・ログの発生要因
0xFF	MFR_FAULT_LOG_STORE
0x00	TON_MAX_FAULTチャネル0
0x01	VOUT_OV_FAULTチャネル0
0x02	VOUT_UV_FAULTチャネル0
0x03	IOUT_OC_FAULTチャネル0
0x05	OT_FAULTチャネル0
0x06	UT_FAULTチャネル0
0x07	VIN_OV_FAULTチャネル0
0x0A	MFR_OT_FAULTチャネル0
0x10	TON_MAX_FAULTチャネル1
0x11	VOUT_OV_FAULTチャネル1
0x12	VOUT_UV_FAULTチャネル1
0x13	IOUT_OC_FAULTチャネル1
0x15	OT_FAULTチャネル1
0x16	UT_FAULTチャネル1
0x17	VIN_OV_FAULTチャネル1
0x1A	MFR_OT_FAULTチャネル1



MFR_FAULT_LOG_CLEAR

MFR_FAULT_LOG_CLEAR コマンドは、フォルト・ログ・ファイルに格納された値を消去します。さらに、STATUS_MFR_SPECIFIC コマンドのビット3もクリアします。クリア・コマンドの発行後、ステータスがクリアされるまでに最大8msかかる場合があります。

この書き込み専用コマンドの形式はバイト送信です。

ブロック・メモリ書き込み/読み出し

コマンド名	CMD コード	説明	タイプ	ページ 指定	データ 形式	単位	NVM	デフォルト 値
MFR_EE_UNLOCK	0xBD	MFR_EE_ERASEコマンドとMFR_EE_DATAコマンドによる アクセスのために、ユーザーのEEPROMのロックを解除する。	R/W Byte	N	Reg			NA
MFR_EE_ERASE	0xBE	MFR_EE_DATAによる一括プログラミングのために、 ユーザーのEEPROMを初期化する。	R/W Byte	N	Reg			NA
MFR_EE_DATA	0xBF	PMBusワードの順次読み出しまたは書き込みによって EEPROMとの間で伝送されるデータ。一括プログラミングを サポートする。	R/W Word	N	Reg			NA

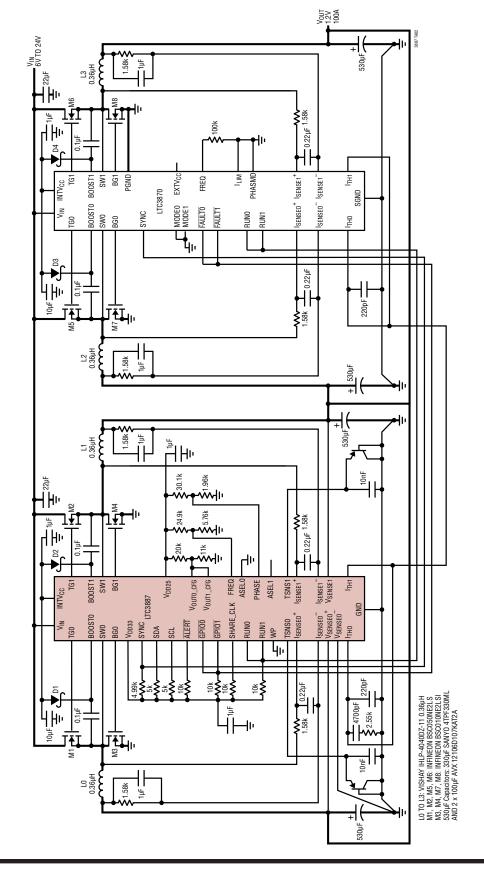
全ての(EEPROM) コマンドは、ダイ温度が 130° Cを超えるとディスエーブルされ、ダイ温度が 125° Cを下回ると再度イネーブルされます。

MFR EE xxxx

MFR_EE_XXXXコマンドは、内部 EEPROM の一括プログラミングを容易にするために使用されます。詳細については、弊社にご連絡ください。

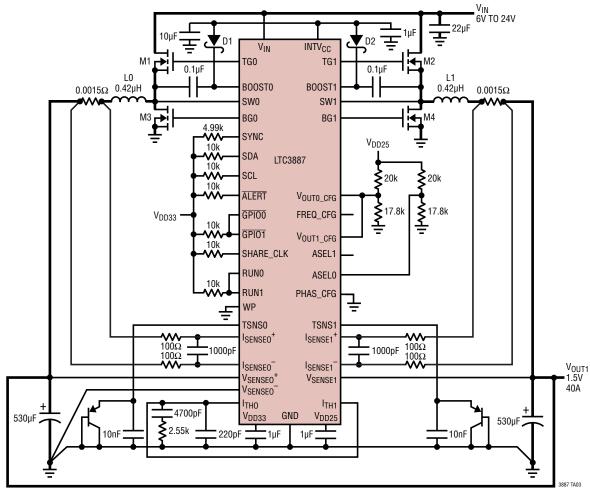


LTC3887 およびLTC3870 を使用した高効率クワッド500kHz/1.2V 降圧コンバータ





高効率350kHz/2位相/1.5Vデュアル降圧コンバータ(検出抵抗付き)

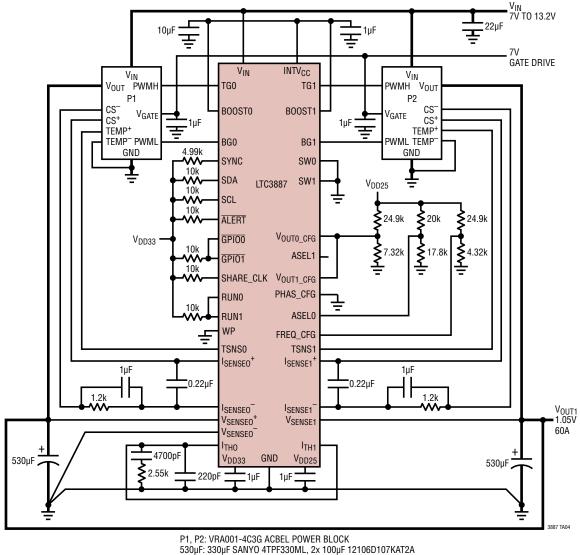


LO, L1: VITEC 59PR9875 0.42µH M1, M2: INFINEON BSC050NE2LS M3, M4: INFINEON BSC010NE2LSI

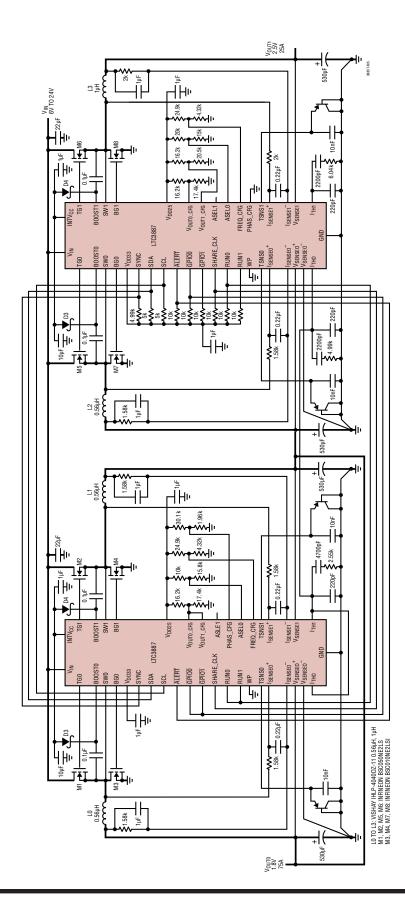
530µF: 330µF SANYO 4TPF330ML, 2x 100µF 12106D107KAT2A

LINEAR

LTC3887を使用した高効率 425kHz/1.05V/降圧デュアル・フェーズ・コンバータ(パワー・ブロック付き)







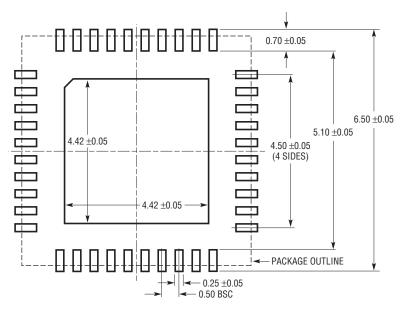
高効率の425kHz、3位相/1.8Vおよび1位相/2.5V降圧コンバータ

パッケージ

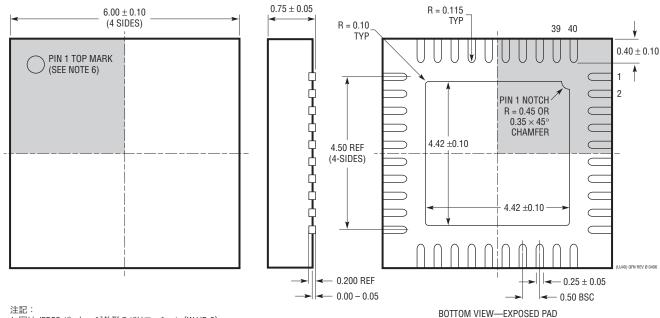
最新のパッケージ図面については、http://www.linear-tech.co.jp/designtools/packaging/を参照してください。

UJ Package 40-Lead Plastic QFN (6mm×6mm)

(Reference LTC DWG # 05-08-1728 Rev Ø)



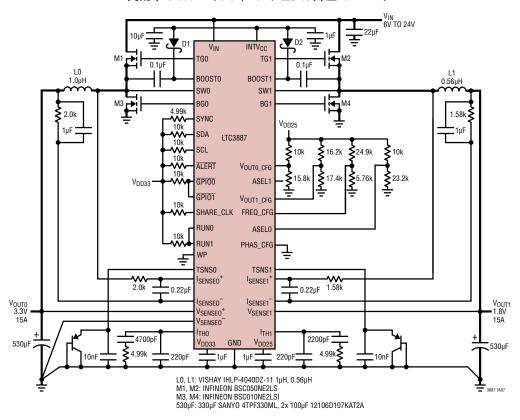
RECOMMENDED SOLDER PAD PITCH AND DIMENSIONS APPLY SOLDER MASK TO AREAS THAT ARE NOT SOLDERED



- 1. 図は JEDEC パッケージ外形のバリエーション(WJJD-2)
- 2. 図は実寸とは異なる
- 3. すべての寸法はミリメートル
- 4. パッケージ底面の露出パッドの寸法にはモールドのバリを含まない モールドのバリは(もしあれば)各サイドで 0.20mm を超えないこと
- 5. 露出パッドは半田メッキとする
- 6. 灰色の部分はパッケージの上面と底面のピン1の位置の参考に過ぎない



高効率の500kHz、3.3V/1.8V デュアル降圧コンバータ



関連製品

製品番号	説明	注釈
LTC3880/ LTC3880-1	デジタル・パワー・システム・マネージメント機能付き、 デュアル出力PolyPhase降圧コントローラ	V _{IN} :最大24V、0.5V ≤ V _{OUT} ≤ 5.4V、アナログCM制御ループ、 EEPROMおよび16ビットADCとのI ² C/PMBusインタフェース
LTC3883/ LTC3883-1	入力電流検出およびデジタル・パワー・システム・マネージメント 機能付き、シングル出力 PolyPhase 降圧コントローラ	V _{IN} :最大24V、0.5V ≤ V _{OUT} ≤ 5.4V、アナログ CM 制御ループ、 EEPROM および 16ビット ADC との I ² C/PMBus インタフェース
LTC3882	デジタル・パワーシステム・マネージメント機能を搭載した デュアル出力PolyPhase降圧DC/DC電圧モード・コントローラ	リーディングエッジ電圧モード、同期可能、 $3V \le V_{IN} \le 38V$ 、 $0.5V \le V_{OUT} \le 5.25V$
LTC2977	PMBus 準拠のオクタル電源モニタ、スーパバイザ、シーケンサ、 マージン・コントローラ	内蔵EEPROMへのフォルト・ログ機能、出力8チャネルと入力電圧1チャネルの モニタ機能
LTC2974	正確な出力電流を特長とする4チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ	全未調整誤差が0.25%の16ビットADC、電圧/電流/温度モニタおよび監視
LTC3855	差動アンプおよびDCRによる温度補償機能付き、デュアル、 マルチフェーズ、同期整流式降圧DC/DCコントローラ	PLLによる固定周波数: 250kHz~770kHz、4.5V ≤ V _{IN} ≤ 38V、 0.8V ≤ V _{OUT} ≤ 12V
LTC3869	並列時に電流バランスの優れた、デュアル2相同期整流式降圧 DC/DCコントローラ	PLLによる固定周波数: 250kHz~770kHz、4V ≤ V _{IN} ≤ 38V、 0.6V≤ V _{OUT} ≤ 12.5V
LTC3861	差動アンプおよびスリーステート出力駆動回路付き、デュアル、 マルチフェーズ、同期整流式降圧DC/DCコントローラ	パワーブロック、DRMOS デバイスまたは外付け MOSFET で動作、 $3V \le V_{\text{IN}} \le 24V$ 、 $t_{\text{ON}}(M_{\text{IN}}) = 20$ ns
LTC3856	差動アンプおよび DCR 温度補償機能を備えたシングル出力、 2相同期整流式降圧 DC/DC コントローラ	PLLによる固定周波数: 250kHz ~ 770kHz、4.5V ≤ V _{IN} ≤ 38V、 0.6V ≤ V _{OUT} ≤ 5.25V
LTC3870	デジタル・パワーシステム・マネージメント機能を備えた LTC3880/LTC3883 向けのPolyPhase 降圧スレーブ・コントローラ	LTC3880/LTC3883の位相拡張器、4.5V ≤ V _{IN} ≤ 60V、 PLLによる周波数:100kHz~1MHz、28ピン(4mm×5mm)QFNパッケージ
LTM [®] 4676/ LTM4676A	デジタル・パワー・システム・マネージメント機能付き、 デュアル 13A またはシングル 26A μModule [®] 電源	$4.5\text{V} \leq \text{V}_{\text{IN}} \leq 26\text{V}$ 、 $0.5\text{V} \leq \text{V}_{\text{OUT}} \leq 5.4\text{V}$ 、 $16\text{mm} \times 16\text{mm} \times 5.01\text{mm}$ BGAパッケージ